

32ビット ARM® Cortex®-M4F FM4 マイクロコントローラ

S6E2H1 シリーズは、高速処理と低コストを求める組込み制御用途向けに設計された、高集積 32 ビットマイクロコントローラです。本シリーズは、CPU に ARM Cortex-M4F プロセッサを搭載し、フラッシュメモリおよび SRAM のオンチップメモリとともに、周辺機能として、モータ制御用タイマ、A/D コンバータ、各種通信インタフェース (UART, CSIO, I²C, LIN) により構成されます。

特長

32 ビット ARM Cortex-M4F コア

- プロセッサ版数: r0p1
- 最大動作周波数: 160 MHz
- FPU 搭載
- DSP 命令対応
- メモリ保護ユニット (MPU): 組込みシステムの信頼性を向上させます。
- ネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC): 1 チャンネルの NMI (ノンマスカブル割り込み) と 128 チャンネルの周辺割り込みに対応。16 の割り込み優先度レベルを設定できます。
- 24 ビットシステムタイマ (Sys Tick): OS タスク管理用のシステムタイマです。

オンチップメモリ

- フラッシュメモリ
本シリーズは、2 つの独立したフラッシュメモリを搭載します。

- メインフラッシュメモリ
 - ・ 最大 512 K バイト
 - ・ 16 K バイトのトレースバッファメモリを使用した、フラッシュメモリアクセラレータ機能を内蔵
 - ・ フラッシュメモリへのリードアクセスは、動作周波数 72 MHz までは 0 wait-cycle です。72 MHz より大きい場合でも、フラッシュメモリアクセラレータ機能により、0 wait-cycle と同等なアクセスを行います。
 - ・ コード保護用セキュリティ機能
- ワークフラッシュメモリ
 - ・ 32 K バイト
 - ・ リードサイクル:
 - ・ 6 wait-cycle 動作周波数が 120 MHz を超え、160 MHz 以下の場合
 - ・ 4 wait-cycle 動作周波数が 72 MHz を超え、120 MHz 以下の場合
 - ・ 2 wait-cycle 動作周波数が 40 MHz を超え、72 MHz 以下の場合
 - ・ 0 wait-cycle 動作周波数が 40 MHz 以下の場合
 - ・ セキュリティ機能はコード保護用セキュリティ機能と共有

■ SRAM

本シリーズのオンチップ SRAM は、3 つの独立した SRAM (SRAM0, SRAM1, SRAM2) により構成されます。SRAM0 は、

Cortex-M4F コアの I-Code バス, D-Code バスに接続します。SRAM1, SRAM2 は、Cortex-M4F コアの System バスに接続します。

- SRAM0: 最大 32 K バイト
- SRAM1: 最大 16 K バイト
- SRAM2: 最大 16 K バイト

外部バスインタフェース

- SRAM, NOR と NAND フラッシュおよび SDRAM デバイスに対応
- 最大 9 チップセレクト CS0~CS8 (CS8 は SDRAM 専用)
- 8/16 ビットデータ幅
- 最大 25 ビットのアドレスビット
- アドレス/データマルチプレクスをサポート
- 外部 RDY 機能をサポート
- スランブル機能サポート
 - 外部領域 0x6000_0000~0xDFFF_FFFF の領域を 4 M バイト単位でスランブルの有効/無効を設定可能
 - スランブルキーを 2 種類設定可能
 - **注意事項:** 本機能を使用するためには、専用のソフトウェアライブラリが必要です。

マルチファンクションシリアルインタフェース (最大 8 チャンネル)

- 64 バイト FIFO あり (FIFO 段数は通信モード・ビット長の設定により可変)
- チャンネルごとに動作モードを次の中から選択できます。
 - UART
 - CSIO
 - LIN
 - I²C
- UART
 - 全二重ダブルバッファ
 - パリティあり/なし選択可能
 - 専用ボーレートジェネレータ内蔵
 - 外部クロックをシリアルクロックとして使用可能
 - ハードウェアフロー・コントロール: CTS/RTS による送受信自動制御 (ch.4 のみ)
 - 豊富なエラー検出機能 (パリティエラー, フレーミングエラー, オーバランエラー)

■CSIO

- 全二重ダブルバッファ
- 専用ボーレートジェネレータ内蔵
- オーバランエラー検出機能
- シリアルチップセレクト機能(ch.6, ch.7のみ)
- 高速SPI対応(ch.4, ch.6のみ)
- データ長 5~16 ビット

■LIN

- LIN プロトコル Rev.2.1 対応
- 全二重ダブルバッファ
- マスタ/スレーブモード対応
- LIN break field 生成(13~16 ビット長に変更可能)
- LIN break デリミタ生成(1~4 ビット長に変更可能)
- 豊富なエラー検出機能(パリティエラー, フレーミングエラー, オーバランエラー)

■I²C

- 標準モード(最大 100 kbps)/高速モード(最大 400 kbps)に対応
- 高速モードプラス(Fm+) (最大 1000 kbps, ch.3=ch.A, ch.7=ch.B のみ)に対応

DMA コントローラ(8 チャンネル)

DMA コントローラは、CPU とは独立した DMA 専用バスを持ち、CPU と並列動作できます。

■8 つを独自に構成かつ動作可能なチャンネル

■ソフトウェア要求または内蔵周辺機能要求による転送開始可能

■転送アドレス空間: 32 ビット(4 G バイト)

■転送モード: ブロック転送/ バースト転送/ デマンド転送

■転送データタイプ: バイト/ ハーフワード/ ワード

■転送ブロック数: 1~16

■転送回数: 1~65536

DSTC (Descriptor System data Transfer Controller) (256 チャンネル)

DSTC は、CPU を介さずにデータを高速に転送できます。Descriptor システム方式を採用しており、あらかじめメモリ上に構築された Descriptor の指定内容に従って、メモリ/Peripheral デバイスに直接アクセスを行い、データ転送動作を実行できます。

ソフトウェア起動, ハードウェア起動, Chain 起動機能サポート

AD コンバータ(最大 24 チャンネル)

■逐次比較型

■3 ユニット搭載

■変換時間: 0.5 μ s @ 5 V

■優先変換可能(2 レベルの優先度)

■スキャン変換モード

■変換データ格納用 FIFO 搭載(スキャン変換用: 16 段, 優先変換用: 4 段)

DA コンバータ(最大 2 チャンネル)

■R-2R 型

■12 ビット分解能

ベースタイマ(最大 8 チャンネル)

チャンネルごとに動作モードを次の中から選択できます。

■16 ビット PWM タイマ

■16 ビット PPG タイマ

■16/32 ビットリロードタイマ

■16/32 ビット PWC タイマ

■イベントカウンタモード(外部クロックモード)

汎用 I/O ポート

本シリーズは、端子が外部バスまたは周辺機能に使用されていない場合、汎用 I/O ポートとして使用できます。また、どの I/O ポートに周辺機能を割り当てるかを設定できるポートリロケート機能を搭載しています。

■端子ごとにブルアップ制御可能

■端子レベルを直接読出し可能

■ポートリロケート機能

■最大 100 本の高速汎用 I/O ポート@ 120 pin Package

■一部のポートは、5 V トレラントに対応
該当する端子については「4. 端子機能一覧」と「5. 入出力回路形式」を参照してください。

多機能タイマ(最大 3 ユニット)

多機能タイマは、次のブロックで構成されます。

最小分解能: 6.25 ns

■16 ビットフリーランタイマ×3 チャンネル / ユニット

■インプットキャプチャ×4 チャンネル / ユニット

■アウトプットコンペア×6 チャンネル / ユニット

■A/D 起動コンペア×6 チャンネル / ユニット

■波形ジェネレータ×3 チャンネル / ユニット

■16 ビット PPG タイマ×3 チャンネル / ユニット

モータ制御を実現するために次の機能を用意しています。

■PWM 信号出力機能

■DC チョップパ波形出力機能

■デッドタイム機能

■インプットキャプチャ機能

■A/D コンバータ起動機能

■DTIF(モータ緊急停止)割込み機能

リアルタイムクロック(RTC : Real Time Clock)

00 年～99 年までの年/月/日/時/分/秒/曜日のカウントを行います。

- 日時指定(年/月/日/時/分)での割込み機能、年/月/日/時/分だけの個別設定も可能
- 設定時間後/設定時間ごとのタイマ割込み機能
- カウントを継続して時刻書換え可能
- うるう年の自動カウント

クアドカウンタ (QPRC : Quadrature Position/Revolution Counter) (最大 3 チャネル)

クアドカウンタ(QPRC)は、ポジションエンコードの位置を測定するために使います。また、設定によりアップダウンカウンタとしても使用できます。

- 3つの外部イベント入力端子 AIN, BIN, ZIN の検出エッジを設定可能
- 16 ビット位置カウンタ
- 16 ビット回転カウンタ
- 2つの16 ビットコンペアレジスタ

デュアルタイマ(32/16 ビットダウンカウンタ)

デュアルタイマは、2つのプログラム可能な32/16 ビットダウンカウンタで構成されます。各タイマチャネルの動作モードを次の中から選択できます。

- フリーランモード
- 周期モード(=リロードモード)
- ワンショットモード

時計カウンタ

時計カウンタは低消費電力モードからのウェイクアップに使用します。クロックソースはメインクロック/サブクロック/内蔵高速 CR クロック/内蔵低速 CR クロックから選択可能です。インターバルタイマ : 最大 64 s@サブクロック使用時(32.768 kHz)

外部割込み制御ユニット

- 外部割込み入力端子: 最大 16 本
 - 立上り/立下りの両エッジ検出に対応
- ノンマスカブル割込み(NMI)入力端子: 1 本

ウォッチドッグタイマ(2 チャネル)

ウォッチドッグタイマは、タイムアウト値に達すると割込みまたはリセットを発生します。

本シリーズには、ハードウェアウォッチドッグとソフトウェアウォッチドッグの2つの異なるウォッチドッグがあります。

ハードウェアウォッチドッグタイマは内蔵低速 CR 発振で動作するため、STOP 以外のすべての低消費電力モードで動作します。

CRC (Cyclic Redundancy Check)アクセラレータ

CRC アクセラレータは、ソフト処理負荷の高い CRC 計算を行い、受信データおよびストレージの整合性確認処理負荷の軽減を実現します。

CCITT CRC16 と IEEE-802.3 CRC32 をサポートします。

■CCITT CRC16 Generator Polynomial: 0x1021

■IEEE-802.3 CRC32 Generator Polynomial: 0x04C11DB7

クロック/リセット

■クロック

5種類のクロックソース(2種類の外部発振, 2種類の内蔵 CR 発振, メイン PLL)から選択できます。

- メインクロック: 4 MHz～48 MHz
- サブクロック: 32.768 kHz
- 内蔵高速 CR クロック: 4 MHz
- 内蔵低速 CR クロック: 100 kHz
- メイン PLL クロック

■リセット

- INITX 端子からのリセット要求
- 電源投入リセット
- ソフトウェアリセット
- ウォッチドッグタイマリセット
- 低電圧検出リセット
- クロックスーパバイザリセット

クロック監視機能(CSV : Clock Super Visor)

内蔵 CR 発振による生成クロックを用いて外部クロックの異常を監視します。

- 外部クロック異常(クロック停止)が検出されると、リセットがアサートされます。
- 外部周波数異常が検出されると、割込みまたはリセットがアサートされます。

低電圧検出機能(LVD : Low-Voltage Detect)

本シリーズは、2段階で VCC の電圧を監視します。設定した電圧より VCC 端子の電圧が下がった場合、低電圧検出機能により割込みまたはリセットが発生します。

■LVD1: 割込みによりエラーを報告

■LVD2: オートリセット動作

低消費電力モード

6種類の低消費電力モードに対応します。

- スリープ
- タイマ
- RTC
- ストップ
- ディープスタンバイ RTC(RAM 保持あり・なし選択可能)
- ディープスタンバイストップ(RAM 保持あり・なし選択可能)

VBAT

RTC(カレンダー回路)/32 kHz 発振回路に独立した電源を供給することで、RTC 動作時の消費電力を低減できます。

VBAT には以下の回路が含まれます。

■RTC

■32 kHz 発振回路

■パワーオン回路

■バックアップレジスタ: 32 バイト

■ポート回路

デバッグ

■シリアル・ワイヤ JTAG デバッグ・ポート (SWJ-DP)

■エンベデッド・トレース・マクロセル(ETM)

ユニーク ID

41 ビットのデバイス固有の値を設定済み

電源

2 種類の電源

■ワイドレンジ電圧対応: VCC = 2.7 V~5.5 V

■VBAT 用電源: VBAT = 2.7 V~5.5 V

Table of Contents

特長	1
1. 品種構成.....	7
2. パッケージと品種対応	8
3. 端子配列図	9
4. 端子機能一覧.....	13
5. 入出力回路形式	40
6. 取扱上のご注意	47
6.1 設計上の注意事項	47
6.2 パッケージ実装上の注意事項	48
6.3 使用環境に関する注意事項	50
7. デバイス使用上の注意	51
8. ブロックダイアグラム	54
9. メモリサイズ.....	55
10. メモリマップ.....	55
11. 各 CPU ステートにおける端子状態	58
12. 電気的特性	65
12.1 絶対最大定格	65
12.2 推奨動作条件	66
12.3 直流規格	69
12.3.1 電流規格	69
12.3.2 端子特性	78
12.4 交流規格	80
12.4.1 メインクロック入力規格	80
12.4.2 サブクロック入力規格	81
12.4.3 内蔵 CR 発振規格	81
12.4.4 メイン PLL の使用条件 (PLL の入力クロックにメインクロックを使用)	82
12.4.5 メイン PLL の使用条件 (メイン PLL の入力クロックに内蔵高速 CR クロックを使用)	82
12.4.6 リセット入力規格	82
12.4.7 パワーオンリセットタイミング	83
12.4.8 GPIO 出力規格	84
12.4.9 外バスタイミング	85
12.4.10 ベースタイマ入力タイミング	97
12.4.11 CSIO タイミング	98
12.4.12 外部入力タイミング	131
12.4.13 クアッドカウンタ タイミング	132
12.4.14 I2C タイミング	135
12.4.15 ETM タイミング	138
12.4.16 JTAG タイミング	139
12.5 12 ビット A/D コンバータ	140
12.6 12 ビット D/A コンバータ	144
12.7 低電圧検出特性	145
12.7.1 低電圧検出リセット	145
12.7.2 低電圧検出割込み	145
12.8 メインフラッシュメモリ書込み/消去特性	146
12.9 ワークフラッシュメモリ書込み/消去特性	146
12.10 スタンバイ復帰時間	147
12.10.1 復帰要因: 割込み/WKUP	147
12.10.2 復帰要因: リセット	149

13. オーダ型格	151
14. パッケージ・外形寸法図.....	152
改訂履歴	156
セールス, ソリューションおよび法律情報	158

1. 品種構成

メモリサイズ

品種名	S6E2H14E0A S6E2H14F0A S6E2H14G0A	S6E2H16E0A S6E2H16F0A S6E2H16G0A
メインフラッシュメモリ	256 K バイト	512 K バイト
ワークフラッシュメモリ	32 K バイト	32 K バイト
オンチップ SRAM	32 K バイト	64 K バイト
SRAM0	16 K バイト	32 K バイト
SRAM1	8 K バイト	16 K バイト
SRAM2	8 K バイト	16 K バイト

ファンクション

品 種 名			S6E2H14E0A S6E2H16E0A	S6E2H14F0A S6E2H16F0A	S6E2H14G0A S6E2H16G0A
端子数			80	100	120/121
CPU			Cortex-M4F, MPU, NVIC 128ch.		
	周波数		160 MHz		
電源電圧範囲			2.7 V～5.5 V		
DMAC			8ch.		
DSTC			256ch.		
外部バスインタフェース			Addr:19-bit (最大), R/W data: 8-bit (最大), CS:5 (最大), SRAM, NOR フラッシュ	Addr:25-bit (最大), R/W data: 8-/16-bit (最大), CS:9 (最大), SRAM, NOR フラッシュ, SDRAM	Addr:25-bit (最大), R/W data: 8-/16-bit (最大), CS:9 (最大), SRAM, NOR フラッシュ, NAND フラッシュ, SDRAM
マルチファンクションシリアル (UART/CSIO/LIN/I ² C)			8ch. (最大)		
ベースタイマ (PWC/リロードタイマ/PWM/PPG)			8ch. (最大)		
多機能タイマ	A/D 起動コンペア	6ch.	3 unit (最大)		
	インプットキャプチャ	4ch.			
	フリーランタイマ	3ch.			
	アウトプットコンペア	6ch.			
	波形ジェネレータ	3ch.			
	PPG	3ch.			
クアドカウンタ			3ch. (最大)		
デュアルタイマ			1 unit		
リアルタイムクロック			1 unit		
時計カウンタ			1 unit		
CRC アクセラレータ			Yes		
ウォッチドッグタイマ			1ch. (SW) + 1ch. (HW)		
外部割込み			16 pin (最大)+ NMI × 1		
I/O ポート			63 pin (最大)	80 pin (最大)	100 pin (最大)
12 ビット A/D コンバータ			16ch. (3 unit)	24ch. (3 unit)	
12 ビット D/A コンバータ			2 unit (最大)		
クロック監視機能(CSV)			Yes		
低電圧検出機能(LVD)			2ch.		
内蔵 CR	高速		4 MHz		
	低速		100 kHz		
デバッグ機能			SWJ-DP/ETM		
ユニーク ID			Yes		

<注意事項>

- 各製品に搭載される周辺機能の信号は、パッケージの端子数制限により、すべて割り当てることはできません。ご使用される機能に応じて、I/O ポートのポートリロケート機能を用いて、端子を割り当ててください。
- 内蔵CRのクロック周波数精度については、「12.4.3 内蔵CR 発振規格」を参照してください。

2. パッケージと品種対応

パッケージ \ 品種名	S6E2H14E0A S6E2H16E0A	S6E2H14F0A S6E2H16F0A	S6E2H14G0A S6E2H16G0A
LQFP: LQH080 (0.5-mm pitch)	○	-	-
LQFP: LQI100 (0.5-mm pitch)	-	○	-
LQFP: LQM120 (0.5-mm pitch)	-	-	○
FBGA: FDI121 (0.5-mm pitch)	-	-	○

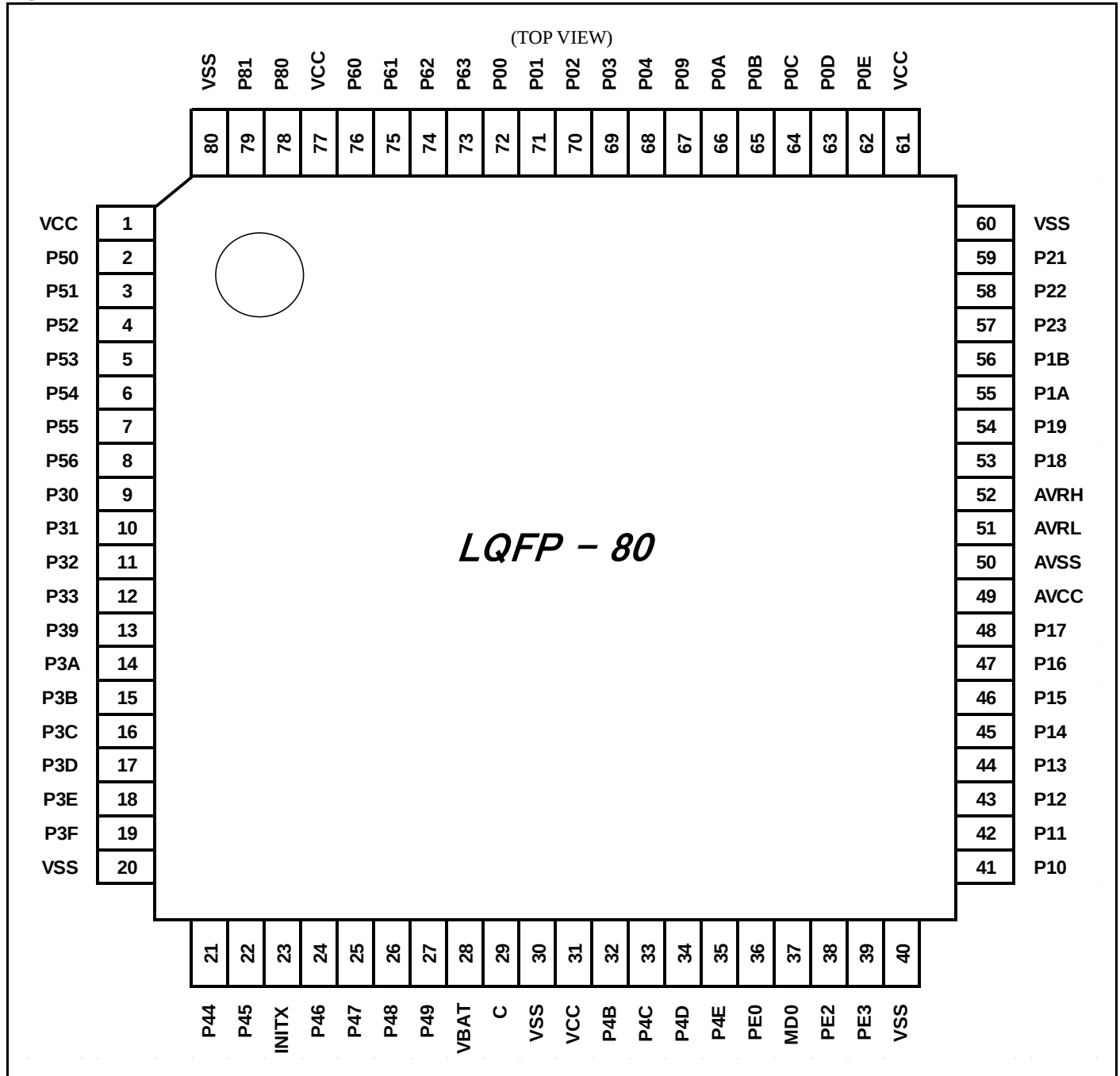
○: 対応

<注意事項>

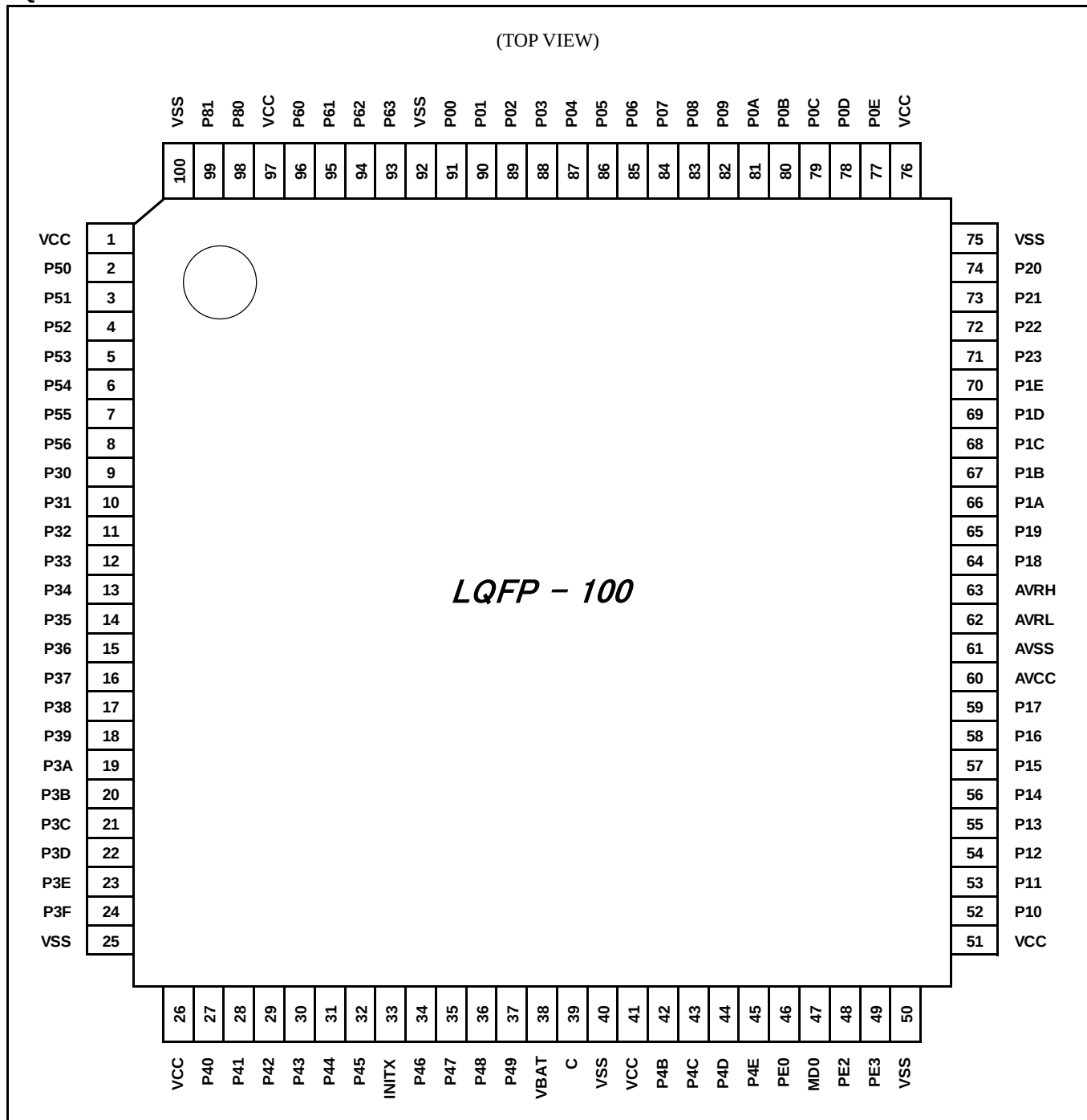
- 各パッケージの詳細は「14. パッケージ・外形寸法図」を参照してください。

3. 端子配列図

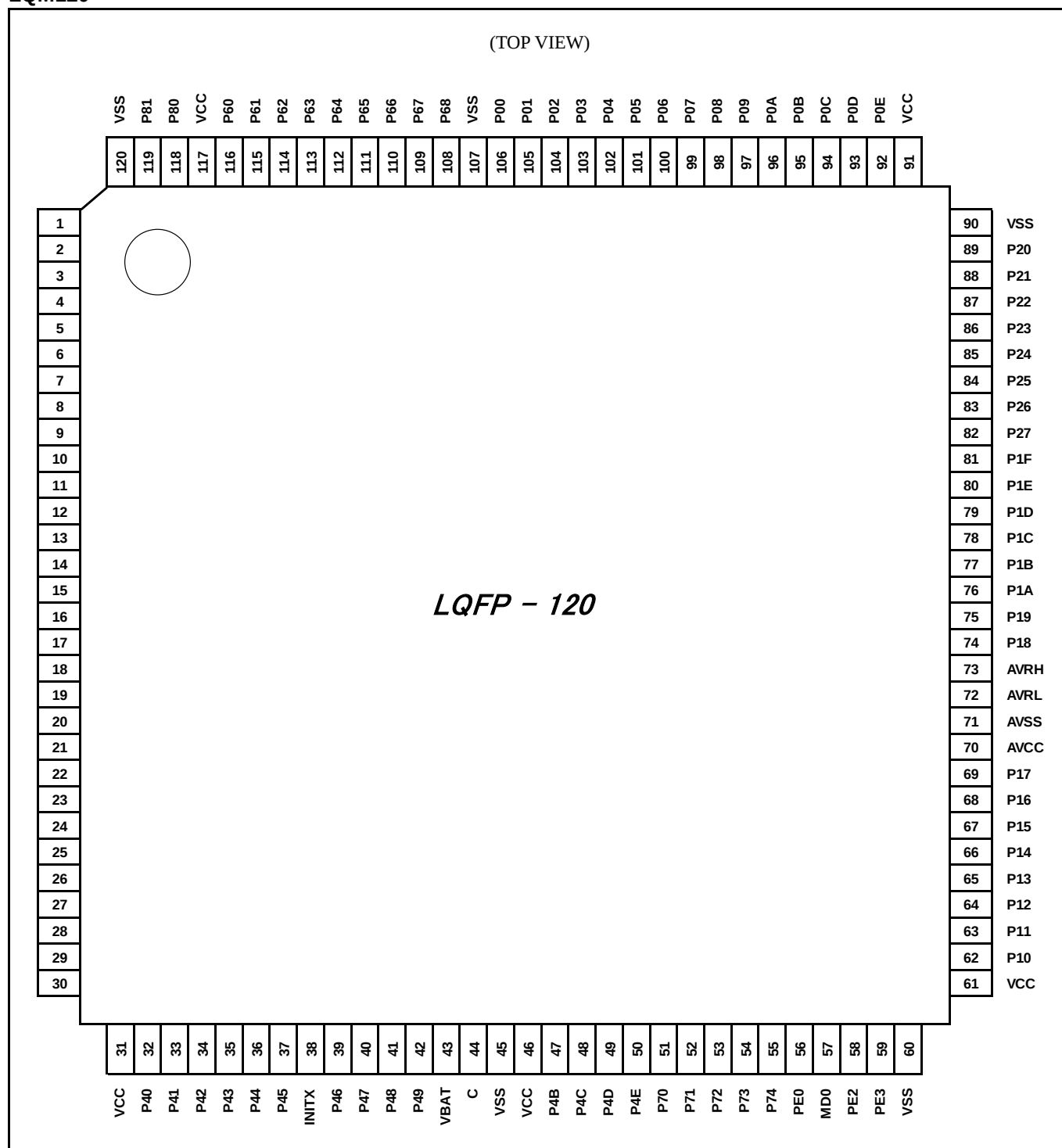
LQH080



LQI100



LQM120



FDI121

(TOP VIEW)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	VSS	P81	P80	VCC	TRSTX	VSS	P06	P0A	P0D	VCC	VSS
B	VCC	P60	P61	P63	TCK	TDO	P07	P0B	P0E	P24	P20
C	P50	P51	P62	P64	TDI	TMS	P08	P0C	P25	P22	P21
D	P52	P53	P54	P65	P66	P05	P09	P26	P1E	P1D	P23
E	P30	P55	P56	P57	P67	P68	P27	P1C	P1B	P1A	P19
F	P34	P33	P32	P31	P58	P59	P1F	P18	P17	P16	AVRH
G	P35	P36	P37	P38	P5A	P5B	P72	P15	P14	P13	AVRL
H	P39	P3A	P3B	P3C	P43	P70	P71	P73	P12	P11	AVSS
J	P3D	P3E	P41	P45	P42	P4B	P4C	P4D	P74	P10	AVCC
K	VCC	P3F	P44	X1A	P48	P49	VCC	P4E	MD0	VSS	VCC
L	VSS	P40	INITX	X0A	VBAT	C	VSS	MD1	X0	X1	VSS

4. 端子機能一覧

端子番号別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。これらの端子は 1 つのチャンネルに複数の機能があり、それぞれの機能ごとに端子名があります。拡張ポート機能レジスタ (EPFR) によって利用する端子名を選択してください。

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
1	1	1	B1	VCC	-	-
2	2	2	C1	P50	E	K
				CTS4_0		
				AIN0_2		
				RTO10_0 (PPG10_0)		
				INT00_0		
				MADATA00_0		
3	3	3	C2	P51	E	K
				RTS4_0		
				BIN0_2		
				RTO11_0 (PPG10_0)		
				INT01_0		
				MADATA01_0		
4	4	4	D1	P52	E	I
				SCK4_0 (SCL4_0)		
				ZIN0_2		
				RTO12_0 (PPG12_0)		
				MADATA02_0		
5	5	5	D2	P53	E	I
				TIOA1_2		
				SOT4_0 (SDA4_0)		
				RTO13_0 (PPG12_0)		
				MADATA03_0		
6	6	6	D3	P54	E	K
				TIOB1_2		
				SIN4_0		
				RTO14_0 (PPG14_0)		
				INT02_0		
				MADATA04_0		
7	7	7	E2	P55	E	K
				ADTG_1		
				SIN6_0		
				RTO15_0 (PPG14_0)		
				INT07_2		
				MADATA05_0		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
8	8	8	E3	P56	E	K
				SOT6_0 (SDA6_0)		
				DTT11X_0		
				INT08_2		
				MADATA06_0		
9	-	-	E4	P57	E	I
				SCK6_0 (SCL6_0)		
				MADATA07_0		
				RTO20_1		
10	-	-	F5	P58	E	K
				SIN4_2		
				AIN1_0		
				INT04_2		
				MADATA08_0		
				RTO21_1		
11	-	-	F6	P59	E	K
				SOT4_2 (SDA4_2)		
				BIN1_0		
				INT07_1		
				MADATA09_0		
				RTO22_1		
12	-	-	G5	P5A	E	I
				SCK4_2 (SCL4_2)		
				ZIN1_0		
				MADATA10_0		
				RTO23_1		
13	-	-	G6	P5B	E	I
				CTS4_2		
				MADATA11_0		
				RTO24_1		
14	9	9	E1	P30	E	Q
				TIOB0_1		
				RTS4_2		
				INT15_2		
				WKUP1		
-	-	-	-	MADATA07_0		
14	9	9	E1	MADATA12_0		
				RTO25_1		
15	10	10	F4	P31	I	K
				TIOB1_1		
				SIN3_1		
				INT09_2		
-	-	-	-	MADATA08_0		
15	10	10	F4	MADATA13_0		
				DTT12X_1		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
16	11	11	F3	P32	N	K
				TIOB2_1		
				SOT3_1 (SDA3_1)		
				INT10_1		
-	-	-	-	MADATA09_0	N	K
16				MADATA14_0		
17	12	12	F2	P33	N	K
				ADTG_6		
				TIOB3_1		
				SCK3_1 (SCL3_1)		
-	-	-	-	INT04_0	N	K
17				MADATA10_0		
18	13	-	F1	MADATA15_0	E	I
				P34		
				TIOB4_1		
				FRCK0_0		
-	-	-	-	MADATA11_0	E	I
18				MNALE_0		
19	14	-	G1	P35	E	K
				TIOB5_1		
				IC03_0		
				INT08_1		
-	-	-	-	MADATA12_0	E	K
19				MNCLE_0		
20	15	-	G2	P36	E	K
				SIN5_2		
				IC02_0		
				INT09_1		
-	-	-	-	MADATA13_0	E	K
20				MNWEX_0		
21	16	-	G3	P37	E	K
				SOT5_2 (SDA5_2)		
				IC01_0		
				INT05_2		
-	-	-	-	MADATA14_0	E	K
21				MNREX_0		
22	17	-	G4	P38	E	K
				SCK5_2 (SCL5_2)		
				IC00_0		
				INT06_2		
-	-	-	-	MADATA15_0	E	K
22				MADATA15_0		
23	18	13	H1	P39	L	I
				ADTG_2		
				DTTIOX_0		
				RTCCO_2		
				SUBOUT_2		
				MSDCLK_0		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
24	19	14	H2	P3A	G	I
				TIOA0_1		
				AIN0_0		
				RTO00_0 (PPG00_0)		
		-		MSDCKE_0		
25	20	15	H3	P3B	G	I
				TIOA1_1		
				BIN0_0		
				RTO01_0 (PPG00_0)		
		-		MRASX_0		
26	21	16	H4	P3C	G	I
				TIOA2_1		
				ZIN0_0		
				RTO02_0 (PPG02_0)		
		-		MCASX_0		
27	22	17	J1	P3D	G	I
				TIOA3_1		
				RTO03_0 (PPG02_0)		
				MAD00_0		
28	23	18	J2	P3E	G	I
				TIOA4_1		
				RTO04_0 (PPG04_0)		
				MAD01_0		
29	24	19	K2	P3F	G	I
				TIOA5_1		
				RTO05_0 (PPG04_0)		
				MAD02_0		
30	25	20	L1	VSS	-	-
31	26	-	K1	VCC	-	-
32	27	-	L2	P40	G	K
				TIOA0_0		
				RTO10_1 (PPG10_1)		
				INT12_1		
33	28	-	J3	P41	G	K
				TIOA1_0		
				RTO11_1 (PPG10_1)		
				INT13_1		
				AIN2_0		
34	29	-	J5	P42	G	I
				TIOA2_0		
				RTO12_1 (PPG12_1)		
				MSDWEX_0		
				BIN2_0		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
35	30	-	H5	P43	G	I
				ADTG_7		
				TIOA3_0		
				RTO13_1 (PPG12_1)		
				MCSX8_0		
				ZIN2_0		
36	31	21	K3	P44	R	J
				TIOA4_0		
				RTO14_1 (PPG14_1)		
				DA0		
37	32	22	J4	P45	R	J
				TIOB0_0		
				RTO15_1 (PPG14_1)		
				DA1		
38	33	23	L3	INITX	B	C
39	34	24	L4	P46	P	S
				X0A		
40	35	25	K4	P47	Q	T
				X1A		
41	36	26	K5	P48	O	U
				VREGCTL		
42	37	27	K6	P49	O	U
				VWAKEUP		
43	38	28	L5	VBAT	-	-
44	39	29	L6	C	-	-
45	40	30	L7	VSS	-	-
46	41	31	K7	VCC	-	-
47	42	32	J6	P4B	E	I
				TIOB1_0		
				SCS7_1		
				MAD03_0		
48	43	33	J7	P4C	N	I
				TIOB2_0		
				SCK7_1 (SCL7_1)		
				AIN1_2		
				MAD04_0		
49	44	34	J8	P4D	N	K
				TIOB3_0		
				SOT7_1 (SDA7_1)		
				BIN1_2		
				INT13_2		
				MAD05_0		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
50	45	35	K8	P4E	I	Q
				TIOB4_0		
				SIN7_1		
				ZIN1_2		
				FRCK1_1		
				INT11_1		
				WKUP2		
				MAD06_0		
51	-	-	H6	P70	E	I
				TIOA4_2		
				AIN0_1		
				IC13_1		
52	-	-	H7	P71	E	K
				TIOB4_2		
				BIN0_1		
				IC12_1		
				INT15_1		
53	-	-	G7	P72	E	K
				TIOA6_0		
				SIN2_0		
				ZIN0_1		
				IC11_1		
				INT14_2		
54	-	-	H8	P73	E	K
				TIOB6_0		
				SOT2_0 (SDA2_0)		
				IC10_1		
				INT03_2		
55	-	-	J9	P74	E	I
				SCK2_0 (SCL2_0)		
				DTI1X_1		
56	46	36	L8	PE0	C	E
				MD1		
57	47	37	K9	MD0	J	D
58	48	38	L9	PE2	A	A
				X0		
59	49	39	L10	PE3	A	B
				X1		
60	50	40	L11	VSS	-	-
61	51	-	K11	VCC	-	-
62	52	41	J10	P10	F	M
				AN00		
				SIN1_1		
				FRCK0_2		
				INT02_1		
				MAD07_0		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
63	53	42	H10	P11	F	L
				AN01		
				SOT1_1 (SDA1_1)		
				IC00_2		
				MAD08_0		
64	54	43	H9	P12	F	L
				AN02		
				SCK1_1 (SCL1_1)		
				IC01_2		
				RTCCO_1		
				SUBOUT_1		
65	55	44	G10	MAD09_0	F	M
				P13		
				AN03		
				SIN0_1		
				IC02_2		
				INT03_1		
66	56	45	G9	MAD10_0	F	L
				P14		
				AN04		
				SOT0_1 (SDA0_1)		
				IC03_2		
67	57	46	G8	MAD11_0	F	L
				P15		
				AN05		
				SCK0_1 (SCL0_1)		
				MAD12_0		
				ZIN2_2		
68	58	47	F10	RTO22_0	F	M
				P16		
				AN06		
				SIN2_2		
				INT14_1		
				MAD13_0		
69	59	48	F9	BIN2_2	F	P
				RTO21_0		
				P17		
				AN07		
				SOT2_2 (SDA2_2)		
				WKUP3		
70	60	49	J11	MAD14_0	-	-
				AIN2_2		
				RTO20_0		
71	61	50	H11	AVCC	-	-
72	62	51	G11	AVSS	-	-
73	63	52	F11	AVRL	-	-
				AVRH	-	-

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
74	64	53	F8	P18	F	L
				AN08		
				SCK2_2 (SCL2_2)		
				MAD15_0		
				DTTI2X_0		
75	65	54	E11	P19	F	M
				AN09		
				SIN4_1		
				IC00_1		
				INT05_1		
				MAD16_0		
76	66	55	E10	P1A	M	L
				AN10		
				SOT4_1 (SDA4_1)		
				IC01_1		
				MAD17_0		
77	67	56	E9	P1B	M	L
				AN11		
				SCK4_1 (SCL4_1)		
				IC02_1		
				MAD18_0		
78	68	-	E8	P1C	F	L
				AN12		
				CTS4_1		
				IC03_1		
				MAD19_0		
79	69	-	D10	P1D	F	L
				AN13		
				RTS4_1		
				DTTI0X_1		
				MAD20_0		
80	70	-	D9	P1E	F	L
				AN14		
				ADTG_5		
				FRCK0_1		
				MAD21_0		
81	-	-	F7	P1F	E	I
				ADTG_4		
				TIOB6_2		
				RTO05_1 (PPG04_1)		
82	-	-	E7	P27	E	K
				TIOA6_2		
				RTO04_1 (PPG04_1)		
				INT02_2		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
83	-	-	D8	P26	E	I
				TIOB5_0		
				SCK2_1 (SCL2_1)		
				RTO03_1 (PPG02_1)		
84	-	-	C9	P25	E	I
				TIOA5_0		
				SOT2_1 (SDA2_1)		
				RTO02_1 (PPG02_1)		
85	-	-	B10	P24	E	K
				SIN2_1		
				RTO01_1 (PPG00_1)		
				INT01_2		
86	71	57	D11	P23	F	L
				AN15		
				TIOA7_1		
		SCK0_0 (SCL0_0)				
		RTO00_1 (PPG00_1)				
		-		MAD22_0		
87	72	58	C10	P22	F	L
				CROUT_0		
				AN16		
		TIOB7_1				
		SOT0_0 (SDA0_0)				
		-		ZIN1_1		
		58		RTO23_0		
88	73	59	C11	P21	F	M
				AN17		
				SIN0_0		
		-		BIN1_1		
		59		INT06_1		
		-		MAD23_0		
		59		RTO24_0		
89	74	-	B11	P20	F	M
				AN18		
				AIN1_1		
				INT05_0		
				MAD24_0		
				RTO25_0		
90	75	60	A11	VSS	-	-
91	76	61	A10	VCC	-	-

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
92	77	62	B9	P0E	L	I
				TIOB5_2		
				SCS6_1		
				IC13_0		
				MDQM1_0		
93	78	63	A9	P0D	L	I
				TIOA5_2		
				SCK6_1 (SCL6_1)		
				IC12_0		
				MDQM0_0		
94	79	64	C8	P0C	L	I
				TIOA6_1		
				SOT6_1 (SDA6_1)		
				IC11_0		
				MALE_0		
95	80	65	B8	P0B	L	K
				TIOB6_1		
				SIN6_1		
				IC10_0		
				INT00_1		
				MCSX0_0		
96	81	66	A8	P0A	L	K
				SIN1_0		
				FRCK1_0		
				INT12_2		
				MCSX1_0		
97	82	67	D7	P09	M	N
		-		AN19		
		-		TRACED0		
		-		TIOA3_2		
		67		SOT1_0 (SDA1_0)		
		67		MCSX5_0		
		67		IC23_1		
		67		IC23_1		
98	83	-	C7	P08	F	N
				AN20		
				TRACED1		
				TIOB3_2		
				SCK1_0 (SCL1_0)		
				MCSX4_0		
				IC22_1		
				IC22_1		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
99	84	-	B7	P07	M	N
				AN21		
				TRACED2		
				TIOA0_2		
				SCK7_0 (SCL7_0)		
				MCLKOUT_0		
				IC21_1		
100	85	-	A7	P06	F	N
				AN22		
				TRACED3		
				TIOB0_2		
				SOT7_0 (SDA7_0)		
				MCSX3_0		
				IC20_1		
101	86	-	D6	P05	F	O
				AN23		
				ADTG_0		
				TRACECLK		
				SIN7_0		
				INT01_1		
				MCSX2_0		
102	87	68	B6	P04	E	G
				TDO		
				SWO		
103	88	69	C6	P03	E	G
				TMS		
				SWDIO		
104	89	70	C5	P02	E	H
				TDI		
				MCSX6_0		
105	90	71	B5	P01	E	G
				TCK		
				SWCLK		
106	91	72	A5	P00	E	H
				TRSTX		
				MCSX7_0		
107	92	-	A6	VSS	-	-
108	-	-	E6	P68	E	K
				TIOB7_2		
				SCK3_0 (SCL3_0)		
				INT00_2		
109	-	-	E5	P67	E	I
				TIOA7_2		
				SOT3_0 (SDA3_0)		

端子番号				端子名	入出力 回路 形式	端子状態 形式
LQFP120	LQFP100	LQFP80	FBGA121			
110	-	-	D5	P66	E	K
				ADTG_8		
				SIN3_0		
				INT11_2		
111	-	-	D4	P65	E	I
				TIOB7_0		
				SCK5_1 (SCL5_1)		
112	-	-	C4	P64	E	K
				TIOA7_0		
				SOT5_1 (SDA5_1)		
				INT10_2		
113	93	73	B4	P63	E	K
	-	-		CROUT_1		
	-	-		SIN5_1		
	-	-		INT03_0		
	93	73		MWEX_0		
	-	-		IC23_0		
114	94	74	C3	P62	I	K
				ADTG_3		
				SIN5_0		
				INT04_1		
				MOEX_0		
				IC22_0		
115	95	75	B3	P61	E	I
				TIOB2_2		
				SOT5_0 (SDA5_0)		
				RTCCO_0		
				SUBOUT_0		
				ZIN2_1		
116	96	76	B2	P60	I	F
				TIOA2_2		
				SCK5_0 (SCL5_0)		
				NMIX		
				WKUP0		
				MRDY_0		
				FRCK2_0		
117	97	77	A4	VCC	-	-
118	98	78	A3	P80	E *1	I
				BIN2_1		
				IC21_0		
119	99	79	A2	P81	E *1	I
				AIN2_1		
				IC20_0		
120	100	80	A1	VSS	-	-
-	-	-	K10	VSS	-	-

*1 プルアップ抵抗制御なし

端子機能別

XXX_1, XXX_2 のように、「_(アンダバー)」がついている端子の、「_」以降の数字はリロケーションポート番号を示しています。

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
ADC	ADTG_0	A/D コンバータ外部トリガ入力端子	101	86	-	D6
	ADTG_1		7	7	7	E2
	ADTG_2		23	18	13	H1
	ADTG_3		114	94	74	C3
	ADTG_4		81	-	-	F7
	ADTG_5		80	70	-	D9
	ADTG_6		17	12	12	F2
	ADTG_7		35	30	-	H5
	ADTG_8		110	-	-	D5
	AN00	A/D コンバータアナログ入力端子。 ANxx は ADC ch.xx を示す。	62	52	41	J10
	AN01		63	53	42	H10
	AN02		64	54	43	H9
	AN03		65	55	44	G10
	AN04		66	56	45	G9
	AN05		67	57	46	G8
	AN06		68	58	47	F10
	AN07		69	59	48	F9
	AN08		74	64	53	F8
	AN09		75	65	54	E11
	AN10		76	66	55	E10
	AN11		77	67	56	E9
	AN12		78	68	-	E8
	AN13		79	69	-	D10
	AN14		80	70	-	D9
	AN15		86	71	57	D11
	AN16		87	72	58	C10
	AN17		88	73	59	C11
	AN18		89	74	-	B11
	AN19		97	82	67	D7
	AN20		98	83	-	C7
	AN21		99	84	-	B7
	AN22		100	85	-	A7
	AN23		101	86	-	D6
ベース タイマ 0	TIOA0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOA 端子	32	27	-	L2
	TIOA0_1		24	19	14	H2
	TIOA0_2		99	84	-	B7
	TIOB0_0	ベースタイマ ch.0 の TIOB 端子	37	32	22	J4
	TIOB0_1		14	9	9	E1
	TIOB0_2		100	85	-	A7
ベース タイマ 1	TIOA1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOA 端子	33	28	-	J3
	TIOA1_1		25	20	15	H3
	TIOA1_2		5	5	5	D2
	TIOB1_0	ベースタイマ ch.1 の TIOB 端子	47	42	32	J6
	TIOB1_1		15	10	10	F4
	TIOB1_2		6	6	6	D3
ベース タイマ 2	TIOA2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOA 端子	34	29	-	J5
	TIOA2_1		26	21	16	H4
	TIOA2_2		116	96	76	B2
	TIOB2_0	ベースタイマ ch.2 の TIOB 端子	48	43	33	J7
	TIOB2_1		16	11	11	F3
	TIOB2_2		115	95	75	B3

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
ベース タイマ 3	TIOA3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOA 端子	35	30	-	H5
	TIOA3_1		27	22	17	J1
	TIOA3_2		97	82	67	D7
	TIOB3_0	ベースタイマ ch.3 の TIOB 端子	49	44	34	J8
	TIOB3_1		17	12	12	F2
	TIOB3_2		98	83	-	C7
ベース タイマ 4	TIOA4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOA 端子	36	31	21	K3
	TIOA4_1		28	23	18	J2
	TIOA4_2		51	-	-	H6
	TIOB4_0	ベースタイマ ch.4 の TIOB 端子	50	45	35	K8
	TIOB4_1		18	13	-	F1
	TIOB4_2		52	-	-	H7
ベース タイマ 5	TIOA5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOA 端子	84	-	-	C9
	TIOA5_1		29	24	19	K2
	TIOA5_2		93	78	63	A9
	TIOB5_0	ベースタイマ ch.5 の TIOB 端子	83	-	-	D8
	TIOB5_1		19	14	-	G1
	TIOB5_2		92	77	62	B9
ベース タイマ 6	TIOA6_0	ベースタイマ ch.6 の TIOA 端子	53	-	-	G7
	TIOA6_1		94	79	64	C8
	TIOA6_2		82	-	-	E7
	TIOB6_0	ベースタイマ ch.6 の TIOB 端子	54	-	-	H8
	TIOB6_1		95	80	65	B8
	TIOB6_2		81	-	-	F7
ベース タイマ 7	TIOA7_0	ベースタイマ ch.7 の TIOA 端子	112	-	-	C4
	TIOA7_1		86	71	57	D11
	TIOA7_2		109	-	-	E5
	TIOB7_0	ベースタイマ ch.7 の TIOB 端子	111	-	-	D4
	TIOB7_1		87	72	58	C10
	TIOB7_2		108	-	-	E6
デバッグ	SWCLK	シリアルワイヤデバッグインタフェースクロック入力端子	105	90	71	B5
	SWDIO	シリアルワイヤデバッグインタフェースデータ入出力端子	103	88	69	C6
	SWO	シリアルワイヤビューワ出力端子	102	87	68	B6
	TCK	JTAG テストクロック入力端子	105	90	71	B5
	TDI	JTAG テストデータ入力端子	104	89	70	C5
	TDO	JTAG デバッグデータ出力端子	102	87	68	B6
	TMS	JTAG テストモード状態入出力端子	103	88	69	C6
	TRACECLK	ETM のトレース CLK 出力端子	101	86	-	D6
	TRACED0	ETM のトレースデータ出力端子	97	82	-	D7
	TRACED1		98	83	-	C7
	TRACED2		99	84	-	B7
	TRACED3		100	85	-	A7
	TRSTX	JTAG テストリセット入力端子	106	91	72	A5

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
外部 バス	MAD00_0	外部バスインタフェースアドレスバス	27	22	17	J1
	MAD01_0		28	23	18	J2
	MAD02_0		29	24	19	K2
	MAD03_0		47	42	32	J6
	MAD04_0		48	43	33	J7
	MAD05_0		49	44	34	J8
	MAD06_0		50	45	35	K8
	MAD07_0		62	52	41	J10
	MAD08_0		63	53	42	H10
	MAD09_0		64	54	43	H9
	MAD10_0		65	55	44	G10
	MAD11_0		66	56	45	G9
	MAD12_0		67	57	46	G8
	MAD13_0		68	58	47	F10
	MAD14_0		69	59	48	F9
	MAD15_0		74	64	53	F8
	MAD16_0		75	65	54	E11
	MAD17_0		76	66	55	E10
	MAD18_0		77	67	56	E9
	MAD19_0		78	68	-	E8
	MAD20_0		79	69	-	D10
	MAD21_0		80	70	-	D9
	MAD22_0		86	71	-	D11
	MAD23_0		88	73	-	C11
	MAD24_0		89	74	-	B11

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
外部バス	MCSX0_0	外部バスインタフェースチップセレクト出力端子	95	80	65	B8
	MCSX1_0		96	81	66	A8
	MCSX2_0		101	86	-	D6
	MCSX3_0		100	85	-	A7
	MCSX4_0		98	83	-	C7
	MCSX5_0		97	82	67	D7
	MCSX6_0		104	89	70	C5
	MCSX7_0		106	91	72	A5
	MCSX8_0		35	30	-	H5
	MADATA00_0	外部バスインタフェースデータバス	2	2	2	C1
	MADATA01_0		3	3	3	C2
	MADATA02_0		4	4	4	D1
	MADATA03_0		5	5	5	D2
	MADATA04_0		6	6	6	D3
	MADATA05_0		7	7	7	E2
	MADATA06_0		8	8	8	E3
	MADATA07_0		9	9	9	E4
	MADATA08_0		10	10	10	F5
	MADATA09_0		11	11	11	F6
	MADATA10_0		12	12	12	G5
	MADATA11_0		13	13	-	G6
	MADATA12_0		14	14	-	E1
	MADATA13_0		15	15	-	F4
	MADATA14_0		16	16	-	F3
	MADATA15_0		17	17	-	F2
	MDQM0_0	外部バスインタフェースバイトマスク信号出力端子	93	78	63	A9
	MDQM1_0		92	77	62	B9
	MALE_0	マルチプレクス時アドレスラッチイネーブル信号	94	79	64	C8
	MRDY_0	外部 RDY 入力信号	116	96	76	B2
	MCLKOUT_0	外部バスクロック出力端子	99	84	-	B7
	MNALE_0	NAND フラッシュ出力端子をコントロールする外部バスインタフェース ALE 信号	18	-	-	F1
	MNCLE_0	NAND フラッシュ出力端子をコントロールする外部バスインタフェース CLE 信号	19	-	-	G1
	MNREX_0	NAND フラッシュをコントロールする外部バスインタフェースリード許可信号	21	-	-	G3
	MNWEX_0	NAND フラッシュをコントロールする外部バスインタフェースライト許可信号	20	-	-	G2
	MOEX_0	SRAM の外部バスインタフェースリード許可信号	114	94	74	C3
	MWEX_0	SRAM の外部バスインタフェースライト許可信号	113	93	73	B4
外部バス	MSDCLK_0	SDRAM インタフェース SDRAM クロック出力端子	23	18	-	H1
	MSDCKE_0	SDRAM インタフェース SDRAM クロックイネーブル端子	24	19	-	H2
	MRASX_0	SDRAM インタフェース SDRAM ロウアクティブ端子	25	20	-	H3
	MCASX_0	SDRAM インタフェース SDRAM カラムアクティブ端子	26	21	-	H4
	MSDWEX_0	SDRAM インタフェース SDRAM ライトイネーブル端子	34	29	-	J5

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
外部割込み	INT00_0	外部割込み要求 00 の入力端子	2	2	2	C1
	INT00_1		95	80	65	B8
	INT00_2		108	-	-	E6
	INT01_0	外部割込み要求 01 の入力端子	3	3	3	C2
	INT01_1		101	86	-	D6
	INT01_2		85	-	-	B10
	INT02_0	外部割込み要求 02 の入力端子	6	6	6	D3
	INT02_1		62	52	41	J10
	INT02_2		82	-	-	E7
	INT03_0	外部割込み要求 03 の入力端子	113	93	73	B4
	INT03_1		65	55	44	G10
	INT03_2		54	-	-	H8
	INT04_0	外部割込み要求 04 の入力端子	17	12	12	F2
	INT04_1		114	94	74	C3
	INT04_2		10	-	-	F5
	INT05_0	外部割込み要求 05 の入力端子	89	74	-	B11
	INT05_1		75	65	54	E11
	INT05_2		21	16	-	G3
	INT06_1	外部割込み要求 06 の入力端子	88	73	59	C11
	INT06_2		22	17	-	G4
	INT07_1	外部割込み要求 07 の入力端子	11	-	-	F6
	INT07_2		7	7	7	E2
	INT08_1	外部割込み要求 08 の入力端子	19	14	-	G1
	INT08_2		8	8	8	E3
	INT09_1	外部割込み要求 09 の入力端子	20	15	-	G2
	INT09_2		15	10	10	F4
	INT10_1	外部割込み要求 10 の入力端子	16	11	11	F3
	INT10_2		112	-	-	C4
	INT11_1	外部割込み要求 11 の入力端子	50	45	35	K8
	INT11_2		110	-	-	D5
	INT12_1	外部割込み要求 12 の入力端子	32	27	-	L2
	INT12_2		96	81	66	A8
	INT13_1	外部割込み要求 13 の入力端子	33	28	-	J3
	INT13_2		49	44	34	J8
	INT14_1	外部割込み要求 14 の入力端子	68	58	47	F10
	INT14_2		53	-	-	G7
	INT15_1	外部割込み要求 15 の入力端子	52	-	-	H7
	INT15_2		14	9	9	E1
	NMIX	ノンマスカブル割込み入力端子	116	96	76	B2

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
GPIO	P00	汎用入出力ポート 0	106	91	72	A5
	P01		105	90	71	B5
	P02		104	89	70	C5
	P03		103	88	69	C6
	P04		102	87	68	B6
	P05		101	86	-	D6
	P06		100	85	-	A7
	P07		99	84	-	B7
	P08		98	83	-	C7
	P09		97	82	67	D7
	P0A		96	81	66	A8
	P0B		95	80	65	B8
	P0C		94	79	64	C8
	P0D		93	78	63	A9
	P0E		92	77	62	B9
	P10	汎用入出力ポート 1	62	52	41	J10
	P11		63	53	42	H10
	P12		64	54	43	H9
	P13		65	55	44	G10
	P14		66	56	45	G9
	P15		67	57	46	G8
	P16		68	58	47	F10
	P17		69	59	48	F9
	P18		74	64	53	F8
	P19		75	65	54	E11
	P1A		76	66	55	E10
	P1B		77	67	56	E9
	P1C		78	68	-	E8
	P1D		79	69	-	D10
	P1E		80	70	-	D9
	P1F		81	-	-	F7
	P20	汎用入出力ポート 2	89	74	-	B11
	P21		88	73	59	C11
	P22		87	72	58	C10
	P23		86	71	57	D11
	P24		85	-	-	B10
	P25		84	-	-	C9
	P26		83	-	-	D8
	P27		82	-	-	E7
	P30	汎用入出力ポート 3	14	9	9	E1
	P31		15	10	10	F4
	P32		16	11	11	F3
	P33		17	12	12	F2
	P34		18	13	-	F1
	P35		19	14	-	G1
	P36		20	15	-	G2
	P37		21	16	-	G3
	P38		22	17	-	G4
	P39		23	18	13	H1
	P3A		24	19	14	H2
	P3B		25	20	15	H3
	P3C		26	21	16	H4
	P3D		27	22	17	J1
	P3E		28	23	18	J2
	P3F		29	24	19	K2

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
GPIO	P40	汎用入出力ポート 4	32	27	-	L2
	P41		33	28	-	J3
	P42		34	29	-	J5
	P43		35	30	-	H5
	P44		36	31	21	K3
	P45		37	32	22	J4
	P46		39	34	24	L4
	P47		40	35	25	K4
	P48		41	36	26	K5
	P49		42	37	27	K6
	P4B		47	42	32	J6
	P4C		48	43	33	J7
	P4D		49	44	34	J8
	P4E		50	45	35	K8
	P50	汎用入出力ポート 5	2	2	2	C1
	P51		3	3	3	C2
	P52		4	4	4	D1
	P53		5	5	5	D2
	P54		6	6	6	D3
	P55		7	7	7	E2
	P56		8	8	8	E3
	P57		9	-	-	E4
	P58		10	-	-	F5
	P59		11	-	-	F6
	P5A		12	-	-	G5
	P5B		13	-	-	G6
	P60	汎用入出力ポート 6	116	96	76	B2
	P61		115	95	75	B3
	P62		114	94	74	C3
	P63		113	93	73	B4
	P64		112	-	-	C4
	P65		111	-	-	D4
	P66		110	-	-	D5
	P67		109	-	-	E5
	P68		108	-	-	E6
	P70	汎用入出力ポート 7	51	-	-	H6
	P71		52	-	-	H7
	P72		53	-	-	G7
	P73		54	-	-	H8
	P74		55	-	-	J9
	P80	汎用入出力ポート 8	118	98	78	A3
	P81		119	99	79	A2
	PE0	汎用入出力ポート E	56	46	36	L8
	PE2		58	48	38	L9
	PE3		59	49	39	L10

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
マルチファンクションシリアル 0	SIN0_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 の入力端子	88	73	59	C11
	SIN0_1		65	55	44	G10
	SOT0_0 (SDA0_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT0 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA0 として機能します。	87	72	58	C10
	SOT0_1 (SDA0_1)		66	56	45	G9
	SCK0_0 (SCL0_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.0 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK0 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL0 として機能します。	86	71	57	D11
	SCK0_1 (SCL0_1)		67	57	46	G8
マルチファンクションシリアル 1	SIN1_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 の入力端子	96	81	66	A8
	SIN1_1		62	52	41	J10
	SOT1_0 (SDA1_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT1 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA1 として機能します。	97	82	67	D7
	SOT1_1 (SDA1_1)		63	53	42	H10
	SCK1_0 (SCL1_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.1 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK1 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL1 として機能します。	98	83	-	C7
	SCK1_1 (SCL1_1)		64	54	43	H9
マルチファンクションシリアル 2	SIN2_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 の入力端子	53	-	-	G7
	SIN2_1		85	-	-	B10
	SIN2_2		68	58	47	F10
	SOT2_0 (SDA2_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT2 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA2 として機能します。	54	-	-	H8
	SOT2_1 (SDA2_1)		84	-	-	C9
	SOT2_2 (SDA2_2)		69	59	48	F9
	SCK2_0 (SCL2_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.2 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK2 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL2 として機能します。	55	-	-	J9
	SCK2_1 (SCL2_1)		83	-	-	D8
	SCK2_2 (SCL2_2)		74	64	53	F8

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
マルチファンクションシリアル 3	SIN3_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 の入力端子	110	-	-	D5
	SIN3_1		15	10	10	F4
	SOT3_0 (SDA3_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときには SOT3 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SDA3 として機能します。	109	-	-	E5
	SOT3_1 (SDA3_1)		16	11	11	F3
	SCK3_0 (SCL3_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.3 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときには SCK3 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SCL3 として機能します。	108	-	-	E6
	SCK3_1 (SCL3_1)		17	12	12	F2
マルチファンクションシリアル 4	SIN4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の入力端子	6	6	6	D3
	SIN4_1		75	65	54	E11
	SIN4_2		10	-	-	F5
	SOT4_0 (SDA4_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときには SOT4 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SDA4 として機能します。	5	5	5	D2
	SOT4_1 (SDA4_1)		76	66	55	E10
	SOT4_2 (SDA4_2)		11	-	-	F6
	SCK4_0 (SCL4_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときには SCK4 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SCL4 として機能します。	4	4	4	D1
	SCK4_1 (SCL4_1)		77	67	56	E9
	SCK4_2 (SCL4_2)		12	-	-	G5
	CTS4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の CTS 入力端子	2	2	2	C1
	CTS4_1		78	68	-	E8
	CTS4_2		13	-	-	G6
	RTS4_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.4 の RTS 出力端子	3	3	3	C2
	RTS4_1		79	69	-	D10
	RTS4_2		14	9	9	E1
マルチファンクションシリアル 5	SIN5_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 の入力端子	114	94	74	C3
	SIN5_1		113	-	-	B4
	SIN5_2		20	15	-	G2
	SOT5_0 (SDA5_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときには SOT5 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SDA5 として機能します。	115	95	75	B3
	SOT5_1 (SDA5_1)		112	-	-	C4
	SOT5_2 (SDA5_2)		21	16	-	G3
	SCK5_0 (SCL5_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.5 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときには SCK5 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときには SCL5 として機能します。	116	96	76	B2
	SCK5_1 (SCL5_1)		111	-	-	D4
	SCK5_2 (SCL5_2)		22	17	-	G4

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
マルチファンクションシリアル 6	SIN6_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 の入力端子	7	7	7	E2
	SIN6_1		95	80	65	B8
	SOT6_0 (SDA6_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT6 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA6 として機能します。	8	8	8	E3
	SOT6_1 (SDA6_1)		94	79	64	C8
	SCK6_0 (SCL6_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK6 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL6 として機能します。	9	-	-	E4
	SCK6_1 (SCL6_1)		93	78	63	A9
	SCS6_1	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.6 のシリアルチップセレクト端子	92	77	62	B9
マルチファンクションシリアル 7	SIN7_0	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 の入力端子	101	86	-	D6
	SIN7_1		50	45	35	K8
	SOT7_0 (SDA7_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 の出力端子。UART/CSIO/LIN 端子(動作モード 0~3)として使用するときは SOT7 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SDA7 として機能します。	100	85	-	A7
	SOT7_1 (SDA7_1)		49	44	34	J8
	SCK7_0 (SCL7_0)	マルチファンクションシリアルインタフェース ch.7 のクロック I/O 端子。CSIO 端子(動作モード 2)として使用するときは SCK7 として、I ² C 端子(動作モード 4)として使用するときは SCL7 として機能します。	99	84	-	B7
	SCK7_1 (SCL7_1)		48	43	33	J7
	SCS7_1	マルチファンクションシリアルインタフェースの ch.7 シリアルチップセレクト端子	47	42	32	J6

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
多機能 タイマ 0	DTTI0X_0	多機能タイマ 0 の RTO00~RTO05 出力を制御する波形ジェネレータの入力信号	23	18	13	H1
	DTTI0X_1		79	69	-	D10
	FRCK0_0	16 ビットフリーランタイム ch.0 の外部クロック入力端子	18	13	-	F1
	FRCK0_1		80	70	-	D9
	FRCK0_2		62	52	41	J10
	IC00_0	多機能タイマ 0 の 16 ビットインプットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャネル数を示します。	22	17	-	G4
	IC00_1		75	65	54	E11
	IC00_2		63	53	42	H10
	IC01_0		21	16	-	G3
	IC01_1		76	66	55	E10
	IC01_2		64	54	43	H9
	IC02_0		20	15	-	G2
	IC02_1		77	67	56	E9
	IC02_2		65	55	44	G10
	IC03_0		19	14	-	G1
	IC03_1		78	68	-	E8
	IC03_2		66	56	45	G9
	RTO00_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG00 として機能します。	24	19	14	H2
	RTO00_1 (PPG00_1)		86	71	57	D11
	RTO01_0 (PPG00_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG00 として機能します。	25	20	15	H3
	RTO01_1 (PPG00_1)		85	-	-	B10
	RTO02_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG02 として機能します。	26	21	16	H4
	RTO02_1 (PPG02_1)		84	-	-	C9
	RTO03_0 (PPG02_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG02 として機能します。	27	22	17	J1
	RTO03_1 (PPG02_1)		83	-	-	D8
	RTO04_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG04 として機能します。	28	23	18	J2
	RTO04_1 (PPG04_1)		82	-	-	E7
	RTO05_0 (PPG04_0)	多機能タイマ 0 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG0 出力モードで使用するときは、PPG04 として機能します。	29	24	19	K2
	RTO05_1 (PPG04_1)		81	-	-	F7

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
多機能 タイマ 1	DTT1X_0	多機能タイマ 1 の RTO10~RTO15 出力を制御する波形ジェネレータの入力信号	8	8	8	E3
	DTT1X_1		55	-	-	J9
	FRCK1_0	16 ビットフリーランタイム ch.1 の外部クロック入力端子	96	81	66	A8
	FRCK1_1		50	45	35	K8
	IC10_0	多機能タイマ 1 の 16 ビットインプットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャンネル数を示します。	95	80	65	B8
	IC10_1		54	-	-	H8
	IC11_0		94	79	64	C8
	IC11_1		53	-	-	G7
	IC12_0		93	78	63	A9
	IC12_1		52	-	-	H7
	IC13_0		92	77	62	B9
	IC13_1		51	-	-	H6
	RTO10_0 (PPG10_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG10 として機能します。	2	2	2	C1
	RTO10_1 (PPG10_1)		32	27	-	L2
	RTO11_0 (PPG10_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG10 として機能します。	3	3	3	C2
	RTO11_1 (PPG10_1)		33	28	-	J3
	RTO12_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG12 として機能します。	4	4	4	D1
	RTO12_1 (PPG12_1)		34	29	-	J5
	RTO13_0 (PPG12_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG12 として機能します。	5	5	5	D2
	RTO13_1 (PPG12_1)		35	30	-	H5
	RTO14_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG14 として機能します。	6	6	6	D3
	RTO14_1 (PPG14_1)		36	31	21	K3
	RTO15_0 (PPG14_0)	多機能タイマ 1 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG1 出力モードで使用するときは、PPG14 として機能します。	7	7	7	E2
	RTO15_1 (PPG14_1)		37	32	22	J4

端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
多機能 タイマ 2	DTTI2X_0	多機能タイマ 2 の RTO20~RTO25 出力を制御する波形ジェネレータの入力信号	74	64	53	F8
	DTTI2X_1		15	10	10	F4
	FRCK2_0	16 ビットフリーランタイム ch.2 の外部クロック入力端子	116	96	76	B2
	FRCK2_1		101	86	-	D6
	IC20_0	多機能タイマ 2 の 16 ビットインプットキャプチャの入力端子。 ICxx は、チャンネル数を示します。	119	99	79	A2
	IC20_1		100	85	-	A7
	IC21_0		118	98	78	A3
	IC21_1		99	84	-	B7
	IC22_0		114	94	74	C3
	IC22_1		98	83	-	C7
	IC23_0		113	93	73	B4
	IC23_1		97	82	67	D7
	RTO20_0 (PPG20_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG20 として機能します。	69	59	48	F9
	RTO20_1 (PPG20_1)		9	-	-	E4
	RTO21_0 (PPG20_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG20 として機能します。	68	58	47	F10
	RTO21_1 (PPG20_1)		10	-	-	F5
	RTO22_0 (PPG22_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG22 として機能します。	67	57	46	G8
	RTO22_1 (PPG22_1)		11	-	-	F6
	RTO23_0 (PPG22_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG22 として機能します。	87	72	58	C10
	RTO23_1 (PPG22_1)		12	-	-	G5
	RTO24_0 (PPG24_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG24 として機能します。	88	73	59	C11
	RTO24_1 (PPG24_1)		13	-	-	G6
	RTO25_0 (PPG24_0)	多機能タイマ 2 の波形ジェネレータ出力端子。 PPG2 出力モードで使用するときは、PPG24 として機能します。	89	74	-	B11
	RTO25_1 (PPG24_1)		14	9	9	E1
クアッド カウンタ 0	AIN0_0	QPRC ch.0 の AIN 入力端子	24	19	14	H2
	AIN0_1		51	-	-	H6
	AIN0_2		2	2	2	C1
	BIN0_0	QPRC ch.0 の BIN 入力端子	25	20	15	H3
	BIN0_1		52	-	-	H7
	BIN0_2		3	3	3	C2
	ZIN0_0	QPRC ch.0 の ZIN 入力端子	26	21	16	H4
	ZIN0_1		53	-	-	G7
	ZIN0_2		4	4	4	D1
クアッド カウンタ 1	AIN1_0	QPRC ch.1 の AIN 入力端子	10	-	-	F5
	AIN1_1		89	74	-	B11
	AIN1_2		48	43	33	J7
	BIN1_0	QPRC ch.1 の BIN 入力端子	11	-	-	F6
	BIN1_1		88	73	-	C11
	BIN1_2		49	44	34	J8
	ZIN1_0	QPRC ch.1 の ZIN 入力端子	12	-	-	G5
	ZIN1_1		87	72	-	C10
	ZIN1_2		50	45	35	K8

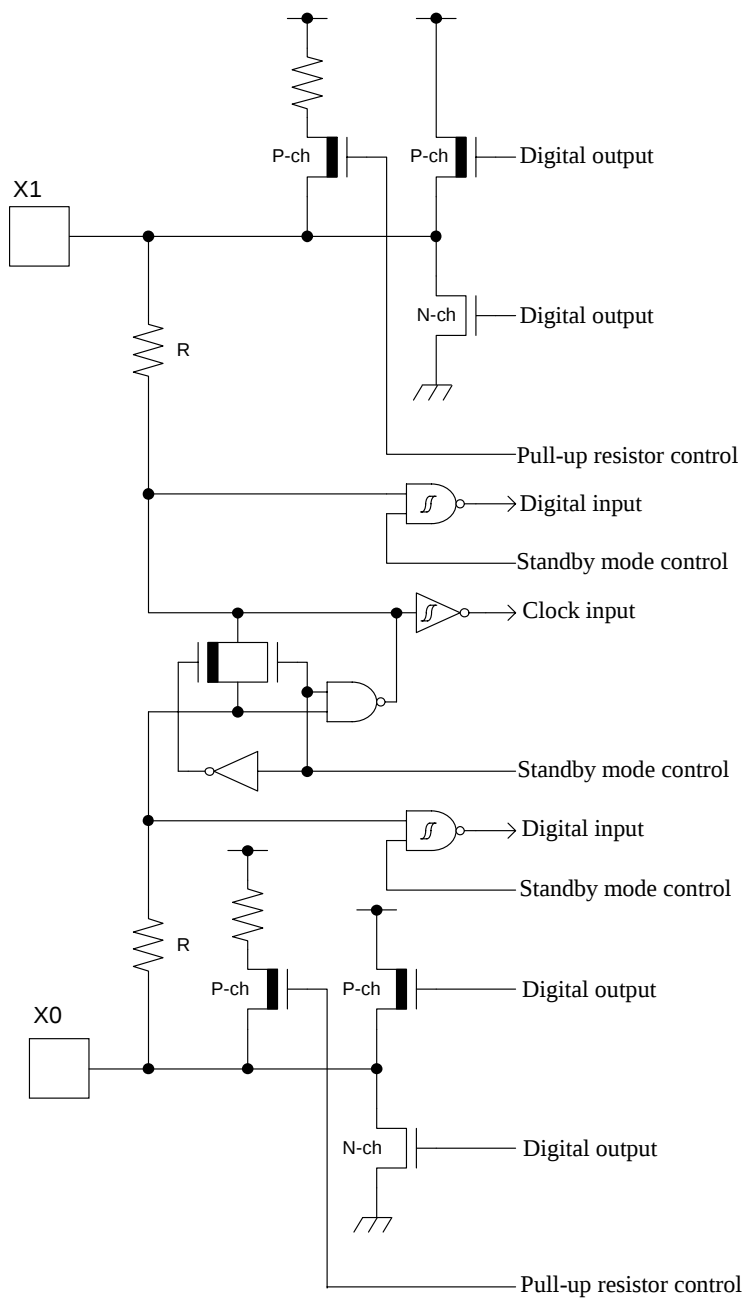
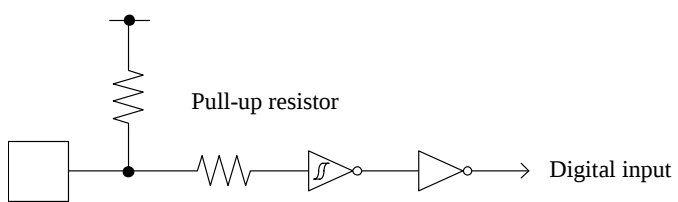
端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
クアッド カウンタ 2	AIN2_0	QPRC ch.2 の AIN 入力端子	33	28	-	J3
	AIN2_1		119	99	79	A2
	AIN2_2		69	59	48	F9
	BIN2_0	QPRC ch.2 の BIN 入力端子	34	29	-	J5
	BIN2_1		118	98	78	A3
	BIN2_2		68	58	47	F10
	ZIN2_0	QPRC ch.2 の ZIN 入力端子	35	30	-	H5
	ZIN2_1		115	95	75	B3
	ZIN2_2		67	57	46	G8
リアル タイム クロック	RTCCO_0	リアルタイムクロックの 0.5 秒パルス出力端子	115	95	75	B3
	RTCCO_1		64	54	43	H9
	RTCCO_2		23	18	13	H1
	SUBOUT_0	サブクロック出力端子	115	95	75	B3
	SUBOUT_1		64	54	43	H9
	SUBOUT_2		23	18	13	H1
低消費電力	WKUP0	ディープスタンバイモード復帰信号入力端子 0	116	96	76	B2
	WKUP1	ディープスタンバイモード復帰信号入力端子 1	14	9	9	E1
	WKUP2	ディープスタンバイモード復帰信号入力端子 2	50	45	35	K8
	WKUP3	ディープスタンバイモード復帰信号入力端子 3	69	59	48	F9
DAC	DA0	D/A コンバータ ch.0 のアナログ出力端子	36	31	21	K3
	DA1	D/A コンバータ ch.1 のアナログ出力端子	37	32	22	J4
VBAT	VREGCTL	オンボードレギュレータ制御用端子	41	36	26	K5
	VWAKEUP	ハイバネーション状態からの復帰信号入力端子	42	37	27	K6
Reset	INITX	外部リセット入力端子。 INITX=L のとき、リセットが有効。	38	33	23	L3
Mode	MD1	モード 1 端子。 フラッシュメモリのシリアル書込み時は、MD1=L を入力してください。	56	46	36	L8
	MD0	モード 0 端子。 通常動作時は、MD0=L を入力してください。フラッシュメモリのシリアル書込み時は、MD0=H を入力してください。	57	47	37	K9
Power	VCC	電源端子	1	1	1	B1
			31	26	-	K1
			46	41	31	K7
			61	51	-	K11
			91	76	61	A10
			117	97	77	A4
GND	VSS	GND 端子	107	92	-	A6
			30	25	20	L1
			45	40	30	L7
			60	50	40	L11
			90	75	60	A11
			120	100	80	A1
			-	-	-	K10
Clock	X0	メインクロック(発振)入力端子	58	48	38	L9
	X1	メインクロック(発振)I/O 端子	59	49	39	L10
	X0A	サブクロック(発振)入力端子	39	34	24	L4
	X1A	サブクロック(発振)I/O 端子	40	35	25	K4
	CROUT_0	高速内蔵 CR 発振クロック出力ポート	87	72	58	C10
	CROUT_1		113	93	73	B4

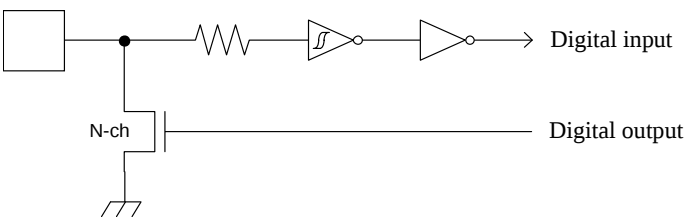
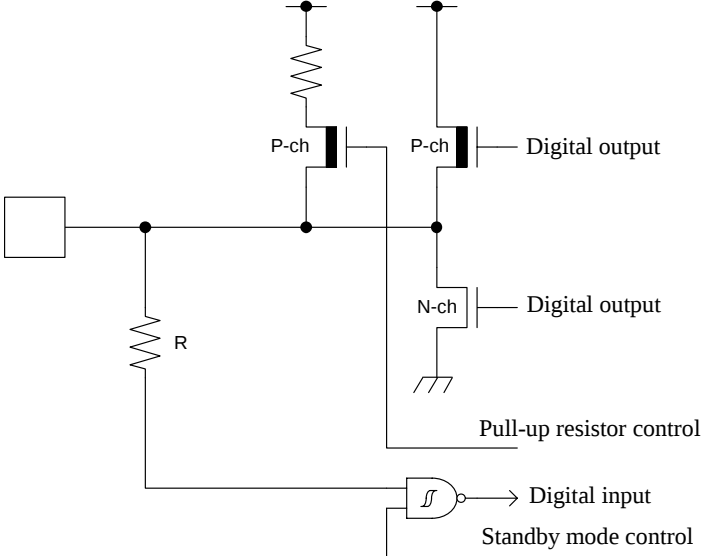
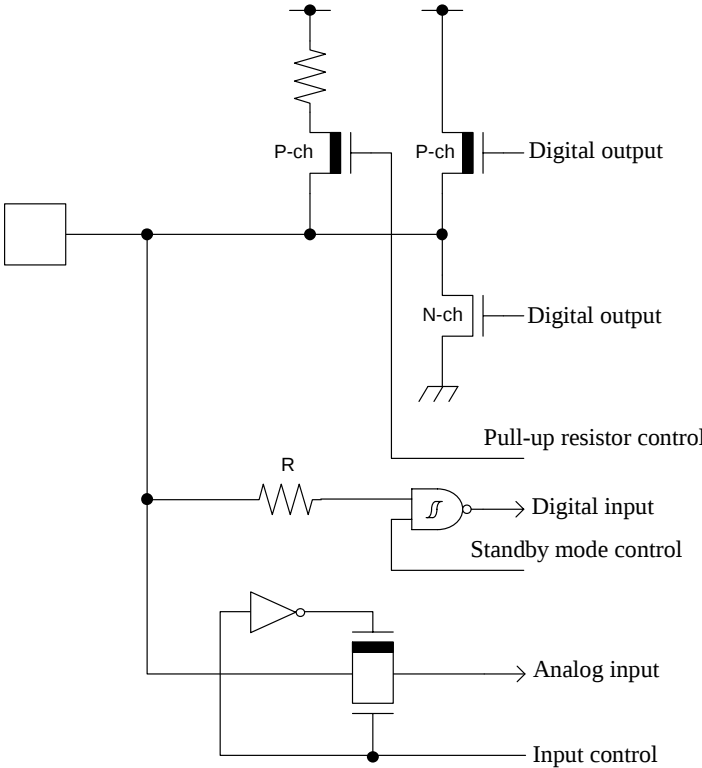
端子機能	端子名	機能説明	端子番号			
			LQFP 120	LQFP 100	LQFP 80	FBGA 121
ADC Power	AVCC	A/D コンバータ, D/A コンバータの アナログ電源端子	70	60	49	J11
	AVRL	A/D コンバータのアナログ基準電圧入力端子	72	62	51	G11
	AVRH	A/D コンバータのアナログ基準電圧入力端子	73	63	52	F11
VBAT Power	VBAT	VBAT 電源端子バックアップ電源（電池など）やシ ステム電源からの供給	43	38	28	L5
ADC GND	AVSS	A/D コンバータ, D/A コンバータの GND 端子	71	61	50	H11
C 端子	C	電源安定化容量端子	44	39	29	L6

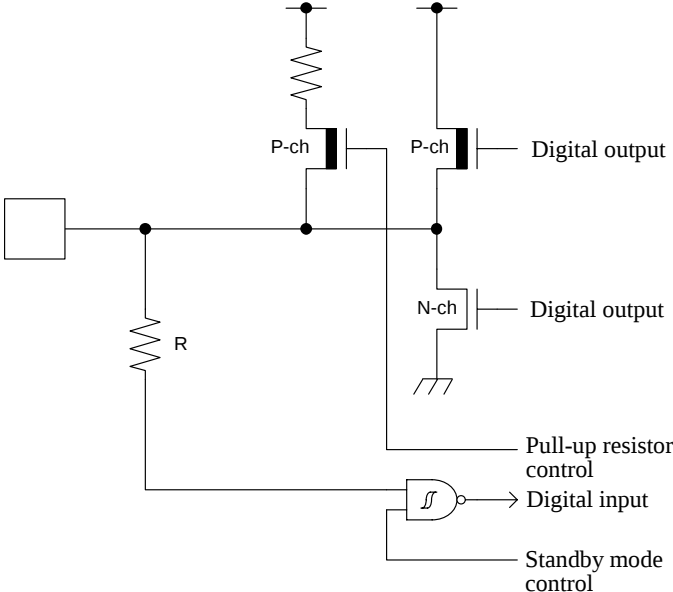
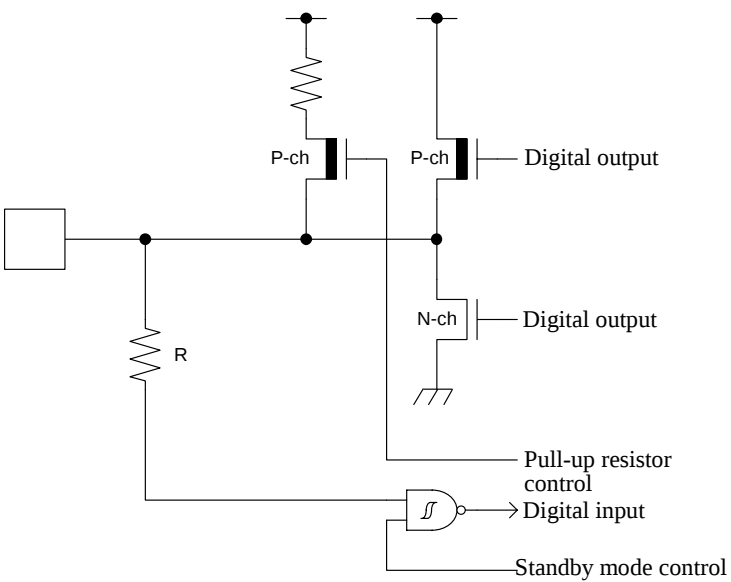
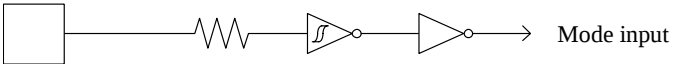
<注意事項>

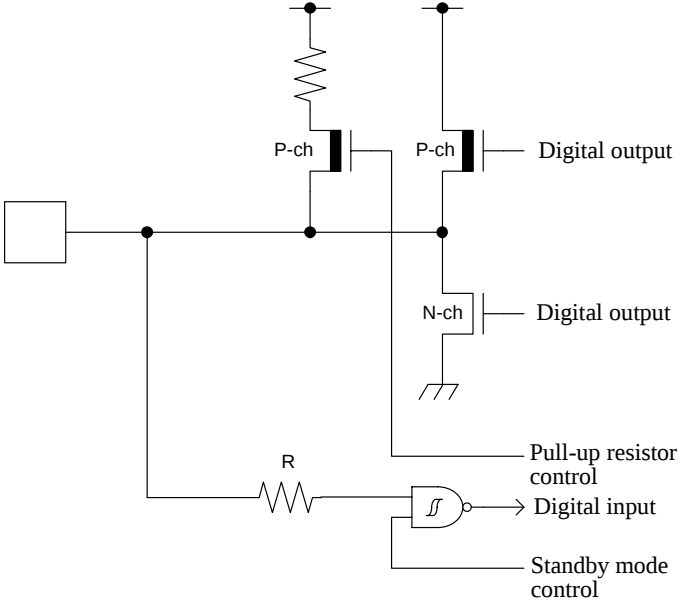
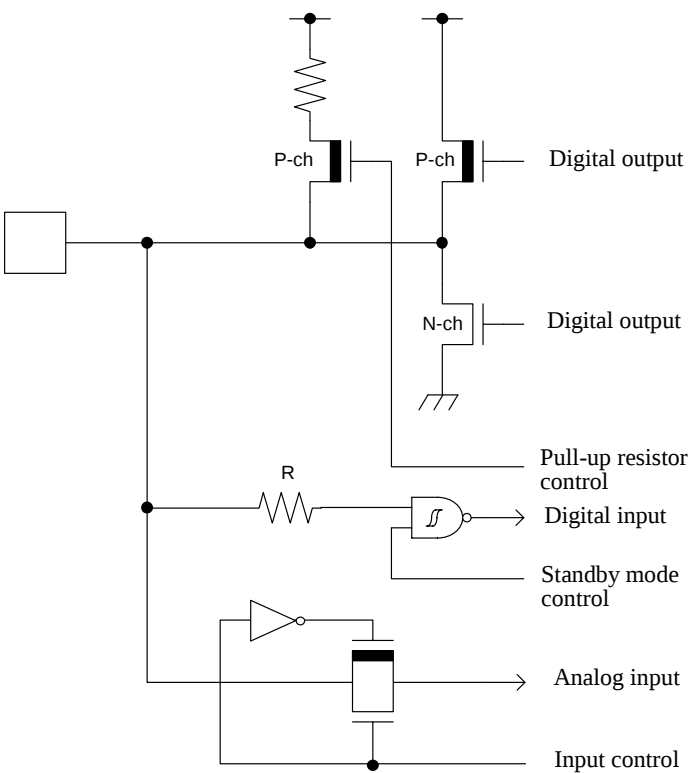
- 本デバイスには、JTAG 標準のテストアクセスポート(TAP)が搭載されていますが、IEEE 1149.1-2001 に完全に準拠していません。32bit の ID 番号は、他シリーズの ID 番号と重なる場合があります。また、JTAG 端子は TAP コントローラへのアクセス以外の目的に対しても使用されます。

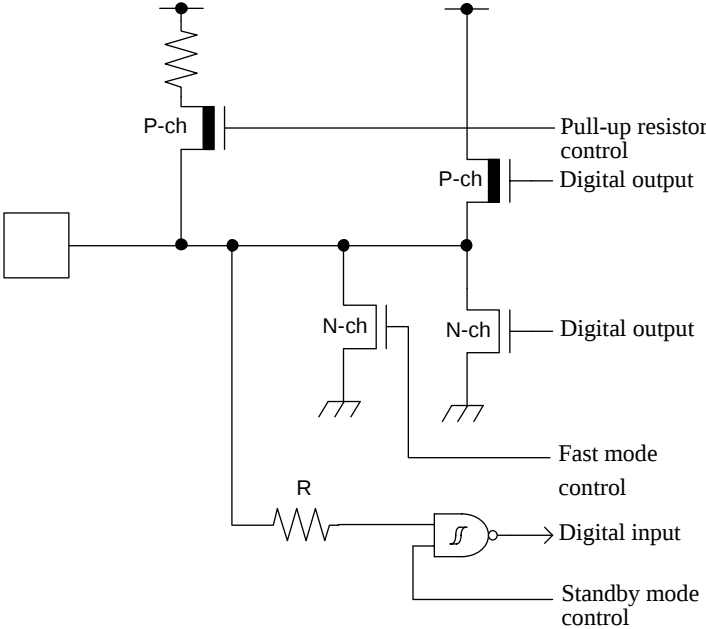
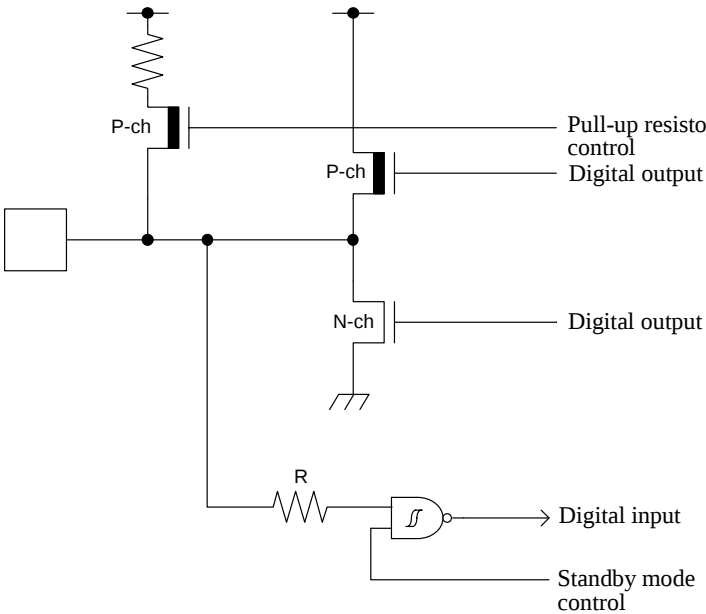
5. 入出力回路形式

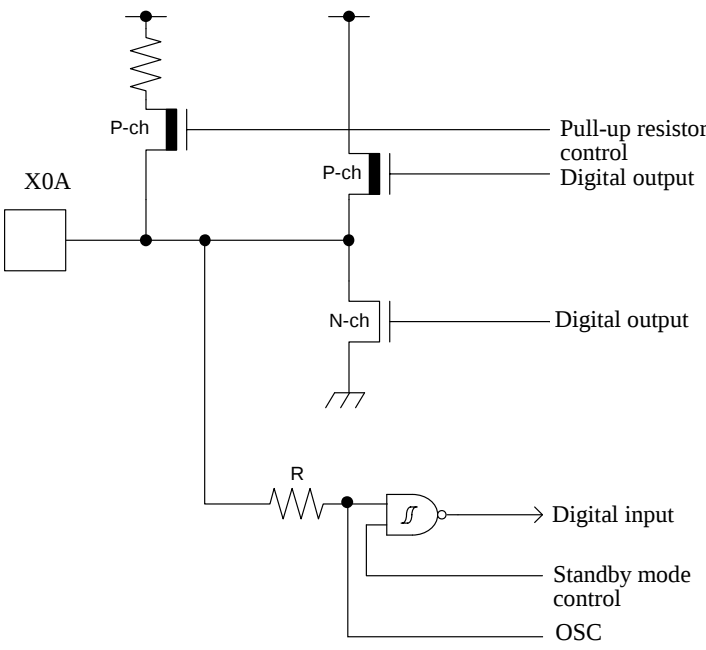
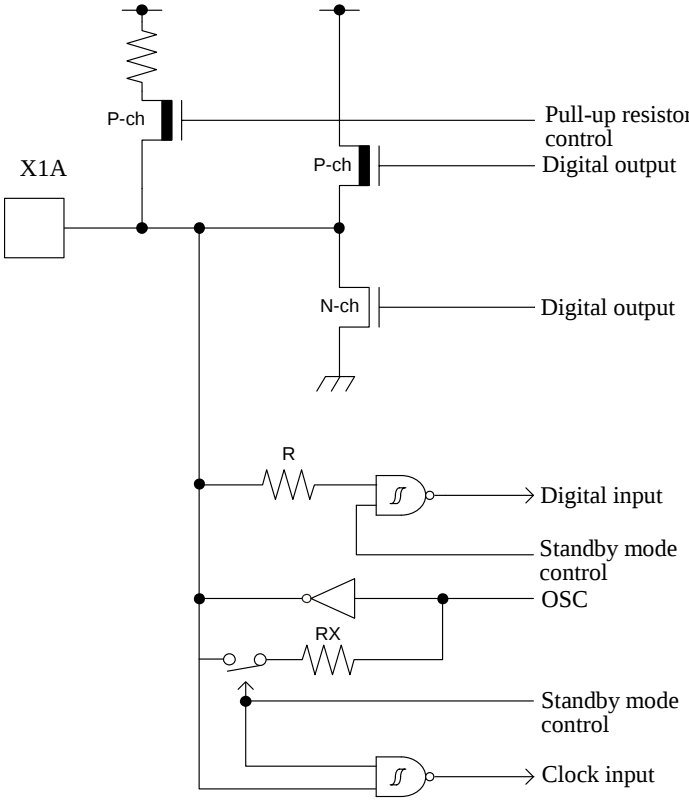
分類	回路	備考
A		メイン発振/GPIO 切換え可能 メイン発振機能選択時 - 発振帰還抵抗：約 1 MΩ - スタンバイ制御あり - GPIO 機能選択時 - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - I_{OH} = -4 mA, I_{OL} = 4 mA
B		- CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ

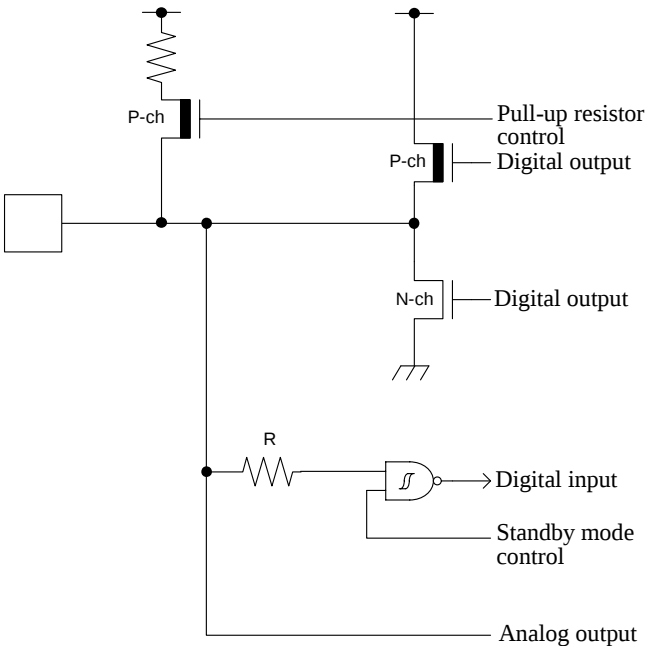
分類	回路	備考
C		- オープンドレイン出力 - CMOS レベルヒステリシス入力
E		- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗 : 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。
F		- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 入力制御あり - アナログ入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗 : 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。

分類	回路	備考
G	 Diagram description: A digital output stage. A P-channel MOSFET (P-ch) and an N-channel MOSFET (N-ch) are connected in a push-pull configuration. The P-ch MOSFET's source is connected to a pull-up resistor R, which is connected to a digital input signal. The N-ch MOSFET's source is connected to ground. The gates of both MOSFETs are connected to a digital input signal. The output of the P-ch MOSFET is labeled 'Digital output'. The output of the N-ch MOSFET is labeled 'Digital output'. A 'Pull-up resistor control' input is connected to the gate of the P-ch MOSFET. A 'Standby mode control' input is connected to the gate of the N-ch MOSFET.	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗 : 約 50 kΩ - $I_{OH} = -12 \text{ mA}$, $I_{OL} = 12 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。
I	 Diagram description: A digital output stage similar to category G. It features a P-channel MOSFET (P-ch) and an N-channel MOSFET (N-ch) in a push-pull configuration. The P-ch MOSFET's source is connected to a pull-up resistor R, which is connected to a digital input signal. The N-ch MOSFET's source is connected to ground. The gates of both MOSFETs are connected to a digital input signal. The output of the P-ch MOSFET is labeled 'Digital output'. The output of the N-ch MOSFET is labeled 'Digital output'. A 'Pull-up resistor control' input is connected to the gate of the P-ch MOSFET. A 'Standby mode control' input is connected to the gate of the N-ch MOSFET.	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - 5V トレラント - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗 : 約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - PZR レジスタ制御可能
J	 Diagram description: A mode input signal path. A digital input signal is connected to a resistor, which is then connected to an inverter. The output of the inverter is connected to a mode input signal.	CMOS レベルヒステリシス入力

分類	回路	備考
L	 P-ch Digital output N-ch Digital output Pull-up resistor control Digital input Standby mode control	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -8 \text{ mA}$, $I_{OL} = 8 \text{ mA}$ - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。
M	 P-ch Digital output N-ch Digital output Pull-up resistor control Digital input Standby mode control Analog input Input control	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 入力制御あり - アナログ入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -8 \text{ mA}$, $I_{OL} = 8 \text{ mA}$

分類	回路	備考
N		- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 5V トレラント - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ (GPIO) - $I_{OL} = 20 \text{ mA}$ (Fast Mode Plus) - I²C 端子として使用するとき、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にオフです。
O		- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - 5V トレラント - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - IO の設定はペリフェラルマニュアル『本編』の『VBAT ドメイン』の章を参照してください

分類	回路	備考
P	 Pull-up resistor control Digital output Digital output Digital input Standby mode control OSC	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - IO の設定はペリフェラルマニュアル『本編』の『VBAT ドメイン』の章を参照してください
Q	 Pull-up resistor control Digital output Digital output Digital input Standby mode control OSC Standby mode control Clock input	サブ発振/GPIO 切換え可能 サブ発振機能選択時 - 発振帰還抵抗：約 10 MΩ - スタンバイ制御あり GPIO 機能選択時 - CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -4 \text{ mA}$, $I_{OL} = 4 \text{ mA}$ - IO の設定はペリフェラルマニュアル『本編』の『VBAT ドメイン』の章を参照してください

分類	回路	備考
R	 Pull-up resistor control Digital output Digital output Digital input Standby mode control Analog output	- CMOS レベル出力 - CMOS レベルヒステリシス入力 - アナログ出力 - ブルアップ抵抗制御あり - スタンバイ制御あり - ブルアップ抵抗：約 50 kΩ - $I_{OH} = -12 \text{ mA}$, $I_{OL} = 12 \text{ mA}$ (4.5V~5.5V) - $I_{OH} = -8 \text{ mA}$, $I_{OL} = 8 \text{ mA}$ (2.7V~4.5V)

6. 取扱上のご注意

半導体デバイスは、ある確率で故障します。また、半導体デバイスの故障は、使用される条件(回路条件、環境条件など)によっても大きく左右されます。

以下に、半導体デバイスをより信頼性の高い状態で使用していただくために、注意・配慮しなければならない事項について説明します。

6.1 設計上の注意事項

ここでは、半導体デバイスを使用して電子機器の設計を行う際に注意すべき事項について述べます。

絶対最大定格の遵守

半導体デバイスは、過剰なストレス（電圧、電流、温度など）が加わると破壊する可能性があります。この限界値を定めたものが絶対最大定格です。従って、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

推奨動作条件の遵守

推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は、全てこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を越えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。

本資料に記載されていない項目、使用条件、論理組み合わせでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

端子の処理と保護

半導体デバイスには、電源および各種入出力端子があります。これらに対して以下の注意が必要です。

(1) 過電圧・過電流の防止

各端子に最大定格を超える電圧・電流が印加されると、デバイスの内部に劣化が生じ、著しい場合には破壊に至ります。機器の設計の際には、このような過電圧・過電流の発生を防止してください。

(2) 出力端子の保護

出力端子を電源端子または他の出力端子とショートしたり、大きな容量負荷を接続すると大電流が流れる場合があります。この状態が長時間続くとデバイスが劣化しますので、このような接続はしないようにしてください。

(3) 未使用入力端子の処理

インピーダンスの非常に高い入力端子は、オープン状態で使用すると動作が不安定になる場合があります。適切な抵抗を介して電源端子やグランド端子に接続してください。

ラッチアップ

半導体デバイスは、基板上に P 型と N 型の領域を形成することにより構成されます。外部から異常な電圧が加えられた場合、内部の寄生 PNP 接合（サイリスタ構造）が導通して、数百 mA を越える大電流が電源端子に流れ続けることがあります。これをラッチアップと呼びます。この現象が起きるとデバイスの信頼性を損ねるだけでなく、破壊に至り発熱・発煙・発火の恐れもあります。これを防止するために、以下の点にご注意ください。

(1) 最大定格以上の電圧が端子に加わることが無いようにしてください。異常なノイズ、サージ等にも注意してください。

(2) 電源投入シーケンスを考慮し、異常な電流が流れないようにしてください。

安全等の規制と規格の遵守

世界各国では、安全や、電磁妨害等の各種規制と規格が設けられています。お客様が機器を設計するに際しては、これらの規制と規格に適合するようお願いいたします。

フェイル・セーフ設計

半導体デバイスは、ある確率で故障が発生します。半導体デバイスが故障しても、結果的に人身事故、火災事故、社会的な損害を生じさせないよう、お客様は、装置の冗長設計、延焼対策設計、過電流防止設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。

用途に関する注意

本資料に記載された製品は、通常の産業用、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御をいう）、ならびに極めて高い信頼性が要求される用途（海底中継器、宇宙衛星をいう）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。当社は、これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。

6.2 パッケージ実装上の注意事項

パッケージには、リード挿入形と表面実装形があります。いずれの場合も、はんだ付け時の耐熱性に関する品質保証は、当社の推奨する条件での実装に対してのみ適用されます。実装条件の詳細については営業部門までお問い合わせください。

リード挿入形

リード挿入形パッケージのプリント板への実装方法は、プリント板へ直接はんだ付けする方法とソケットを使用してプリント板に実装する方法とがあります。

プリント板へ直接はんだ付けする場合は、プリント板のスルーホールにリード挿入後、噴流はんだによるフローはんだ方法（ウェーブソルダリング法）が一般的に使用されます。この場合、はんだ付け実装時には、通常最大定格の保存温度を上回る熱ストレスがリード部分に加わります。当社の実装推奨条件で実装してください。

ソケット実装方法でご使用になる場合、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理が異なるとき、長時間経過後、接触不良を起こすことがあります。このため、ソケットの接点の表面処理と IC のリードの表面処理の状態を確認してから実装することをお勧めします。

表面実装形

表面実装形パッケージは、リード挿入形と比較して、リードが細く薄いため、リードが変形し易い性質をもっています。また、パッケージの多ピン化に伴い、リードピッチも狭く、リード変形によるオープン不良や、はんだブリッジによるショート不良が発生しやすいため、適切な実装技術が必要となります。

当社ははんだリフロー方法を推奨し、製品ごとに実装条件のランク分類を実施しています。当社推奨のランク分類に従って実装してください。

鉛フリーパッケージ

FBGA パッケージの Sn-Ag-Cu 系ボール品を Sn-Pb 共晶はんだにて実装した場合、使用状況により接合強度が低下することがありますのでご注意ください。

半導体デバイスの保管について

プラスチックパッケージは樹脂でできているため、自然の環境に放置することにより吸湿します。吸湿したパッケージに実装時の熱が加わった場合、界面剥離発生による耐湿性の低下やパッケージクラックが発生することがあります。以下の点にご注意ください。

- (1) 急激な温度変化のある所では製品に水分の結露が起こります。このような環境を避けて、温度変化の少ない場所に保管してください。
- (2) 製品の保管場所はドライボックスの使用を推奨します。相対湿度 70%RH 以下、温度 5°C～30°C で保管をお願いします。ドライパッケージを開封した場合には湿度 40%～70%RH を推奨いたします。
- (3) 当社では必要に応じて半導体デバイスの梱包材として防湿性の高いアルミラミネート袋を用い、乾燥剤としてシリカゲルを使用しております。半導体デバイスはアルミラミネート袋に入れて密封して保管してください。
- (4) 腐食性ガスの発生する場所や塵埃の多い所は避けてください。

ベーキングについて

吸湿したパッケージはベーキング（加熱乾燥）を実施することにより除湿することが可能です。ベーキングは、当社の推奨する条件で実施してください。

条件:125°C/24 時間

静電気

半導体デバイスは静電気による破壊を起こしやすいため、以下の点についてご注意ください。

- (1) 作業環境の相対湿度は 40 %～70%RH にしてください。
除電装置（イオン発生装置）の使用なども必要に応じて検討してください。
- (2) 使用するコンベア、半田槽、半田ゴテ、および周辺付帯設備は大地に接地してください。
- (3) 人体の帯電防止のため、指輪または腕輪などから高抵抗（1 MΩ 程度）で大地に接地したり、導電性の衣服・靴を着用し、床に導電マットを敷くなど帯電電荷を最小限に保つようにしてください。
- (4) 治具、計器類は、接地または帯電防止化を実施してください。
- (5) 組立完了基板の収納時、発泡スチロールなどの帯電し易い材料の使用は避けてください。

6.3 使用環境に関する注意事項

半導体デバイスの信頼性は、先に述べました周囲温度とそれ以外の環境条件にも依存します。ご使用にあたっては、以下の点にご注意ください。

(1) 湿度環境

高湿度環境下での長期の使用は、デバイス自身だけでなくプリント基板等にもリーク性の不具合が発生する場合があります。高湿度が想定される場合は、防湿処理を施す等の配慮をお願いします。

(2) 静電気放電

半導体デバイスの直近に高電圧に帯電したものが存在すると、放電が発生し誤動作の原因となることがあります。このような場合、帯電の防止または放電の防止の処置をお願いします。

(3) 腐食性ガス、塵埃、油

腐食性ガス雰囲気中や、塵埃、油等がデバイスに付着した状態で使用すると、化学反応によりデバイスに悪影響を及ぼす場合があります。このような環境下でご使用の場合は、防止策についてご検討ください。

(4) 放射線・宇宙線

一般のデバイスは、設計上、放射線、宇宙線にさらされる環境を想定しておりません。したがって、これらを遮蔽してご使用ください。

(5) 発煙・発火

樹脂モールド型のデバイスは、不燃性ではありません。発火物の近くでは、ご使用にならないでください。発煙・発火しますと、その際に毒性を持ったガスが発生する恐れがあります。

その他、特殊な環境下でのご使用をお考えの場合は、営業部門にご相談ください。

7. デバイス使用上の注意

電源端子について

VCC, VSS 端子が複数ある場合、デバイス設計上はラッチアップなどの誤動作を防止するためにデバイス内部で同電位にすべきものどうしを接続してありますが、不要輻射の低減・グランドレベルの上昇によるストロブ信号の誤動作の防止・総出力電流規格を遵守などのために、必ずそれらすべてを外部で電源およびグランドに接続してください。また、電流供給源からできる限り低インピーダンスで本デバイスの各電源端子と GND 端子に接続してください。

さらに、本デバイスの近くで各電源端子 と GND 端子の間に 0.1 μF 程度のセラミックコンデンサをバイパスコンデンサとして接続することを推奨します。

電源端子について

電源電圧の変動が VCC の推奨動作条件内においても、急激な変化があると誤動作することがあります。安定化の基準として VCC は、商用周波数 (50 Hz~60 Hz) におけるリップル変動(ピークピーク値) を推奨動作条件内の 10%以内にしてください。かつ電源切換えによる瞬間変動の過渡変動率は 0.1 V/ μs 以下にしてください。

水晶発振回路について

X0/X1, X0A/X1A 端子の近辺のノイズは本デバイスの誤動作の原因となります。X0/X1, X0A/X1A 端子および水晶発振子さらにグランドへのバイパスコンデンサはできる限り近くに配置するようにプリント板を設計してください。

また、X0/X1, X0A/X1A 端子の周りをグランドで囲むようなプリント板アートワークは安定した動作を期待できるため、強く推奨します。

実装基板にて、使用する水晶振動子の発振評価を実施してください。

サブクロック用水晶振動子について

本シリーズのサブクロック発振回路は消費電流を低く抑えた設計を行っており、増幅度が低い回路となっています。安定した発振をさせるためサブクロック用水晶振動子には、以下の条件を満たす水晶振動子の使用を推奨します。

■表面実装タイプ

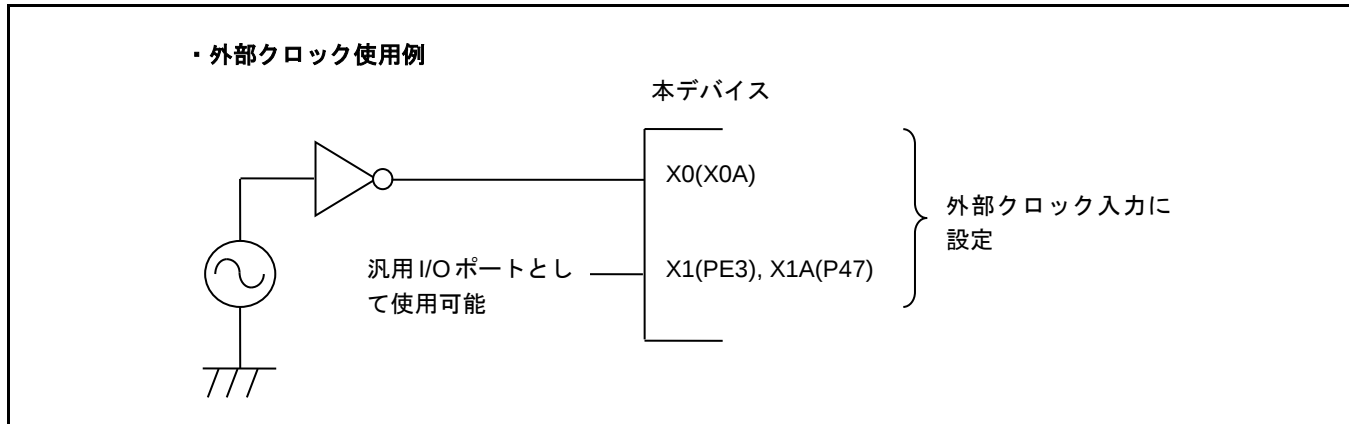
サイズ: 3.2 mm $\times$ 1.5 mm 以上
負荷容量: 6 pF~7 pF 程度

■リードタイプ

負荷容量: 6 pF~7 pF 程度

外部クロック使用時の注意

メインクロックの入力として外部クロックを使用する場合は、X0/X1 端子を外部クロック入力に設定し、X0 端子にクロックを入力してください。X1(PE3)端子は汎用 I/O ポートとして使用できます。
同様にサブクロックの入力として外部クロックを使用する場合は、X0A/X1A 端子を外部クロック入力に設定し、X0A 端子にクロックを入力してください。X1A(P47)端子は汎用 I/O ポートとして使用できます。

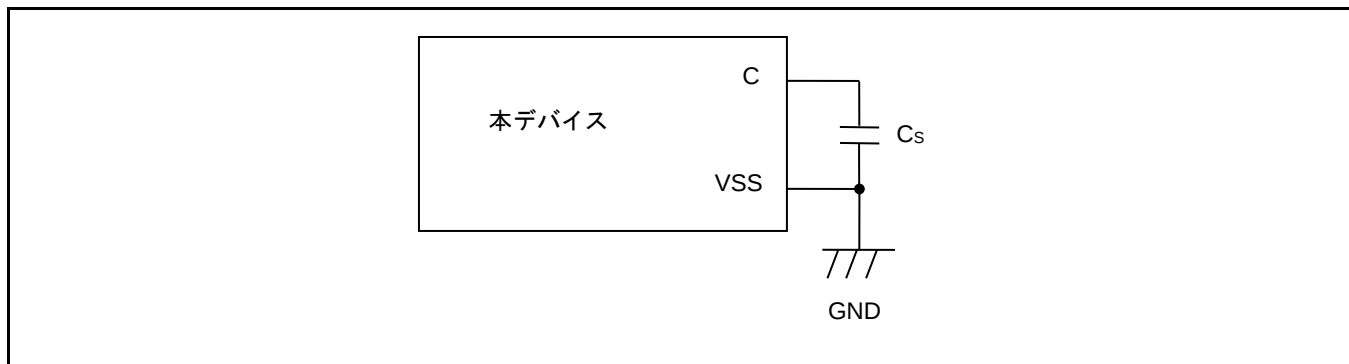


マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合の扱いについて

マルチファンクションシリアル端子を I²C 端子として使用する場合、デジタル出力 P-ch トランジスタは常にディセーブルです。しかし、I²C 端子もほかの端子と同様に、デバイスの電気的特性を守り、電源をオフにしたまま外部 I²C バスシステムへ接続してはいけません。

C 端子について

本シリーズはレギュレータを内蔵しています。必ず C 端子と GND 端子の間にレギュレータ用の平滑コンデンサ(C_s)を接続してください。平滑コンデンサにはセラミックコンデンサまたは同程度の周波数特性のコンデンサを使用してください。
なお、積層セラミックコンデンサは、温度による容量値の変化幅に特性(F 特性, Y5V 特性)を持つものがあります。コンデンサの温度特性を確認し、使用条件において規格値を満たすコンデンサを使用してください。
本シリーズでは 4.7 μ F 程度の平滑コンデンサを推奨します。



モード端子(MD0)について

モード端子(MD0)は VCC 端子または VSS 端子に直接接続してください。内蔵フラッシュメモリ書換えなどの目的で、モード端子レベルを変更できるようにプルアップまたはプルダウンをする場合には、ノイズによりデバイスが意図せずテストモードに入るのを防止するため、プルアップまたはプルダウンに使用する抵抗値はできるだけ低く抑えると共に、モード端子から VCC 端子または VSS 端子への距離を最小にし、できるだけ低インピーダンスで接続するようにプリント基板を設計してください。

電源投入時について

電源を投入/切断する際は同時か、あるいは次の順番で投入/切断を行ってください。すべての電源の投入後に正常動作します。

VBAT のみ電源 on するには、VBAT と VCC を電源 on して、ハイバネーション制御してから VCC を電源 off することで可能です。ハイバネーション制御については、FM4 ペリフェラルマニュアル(002-04856)の CHAPTER 7-2: VBAT ドメイン(A)を参照ください。なお、A/D コンバータおよび D/A コンバータを使用しない場合でも、AVCC = VCC レベル、AVSS = VSS レベルに接続してください。

投入時:	VBAT → VCC VCC → AVCC → AVRH
切断時:	AVRH → AVCC → VCC VCC → VBAT

シリアル通信について

シリアル通信においては、ノイズなどにより間違ったデータを受信する可能性があります。そのため、ノイズを抑えるボードの設計をしてください。

また、万が一ノイズなどの影響により誤ったデータを受信した場合を考慮し、最後にデータのチェックサムなどを付加してエラー検出を行ってください。エラーが検出された場合には、再送を行うなどの処理をしてください。

メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品の特性差について

メモリサイズの異なる製品間およびフラッシュメモリ製品と MASK 製品ではチップレイアウトやメモリ構造の違いにより消費電流や ESD, ラッチアップ, ノイズ特性, 発振特性等を含めた電気的特性が異なります。

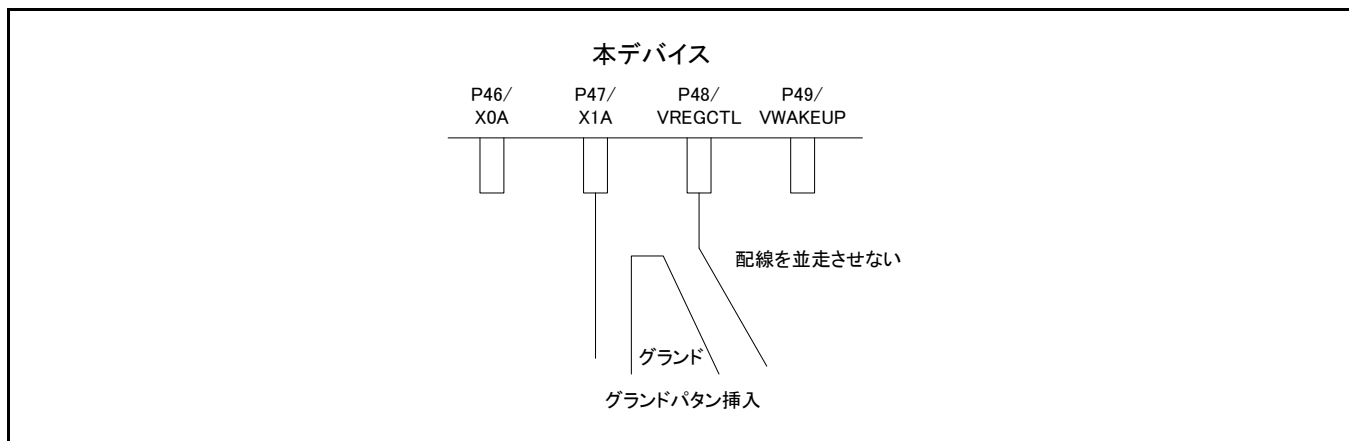
お客様にて同一シリーズの別製品に切り換えて使用する際は、電気的特性の評価を行ってください。

5 V トレラント I/O のプルアップ機能について

5 V トレラント I/O のプルアップ機能使用時は VCC 電圧以上の信号を入力してはいけません。

基板上の隣接配線について

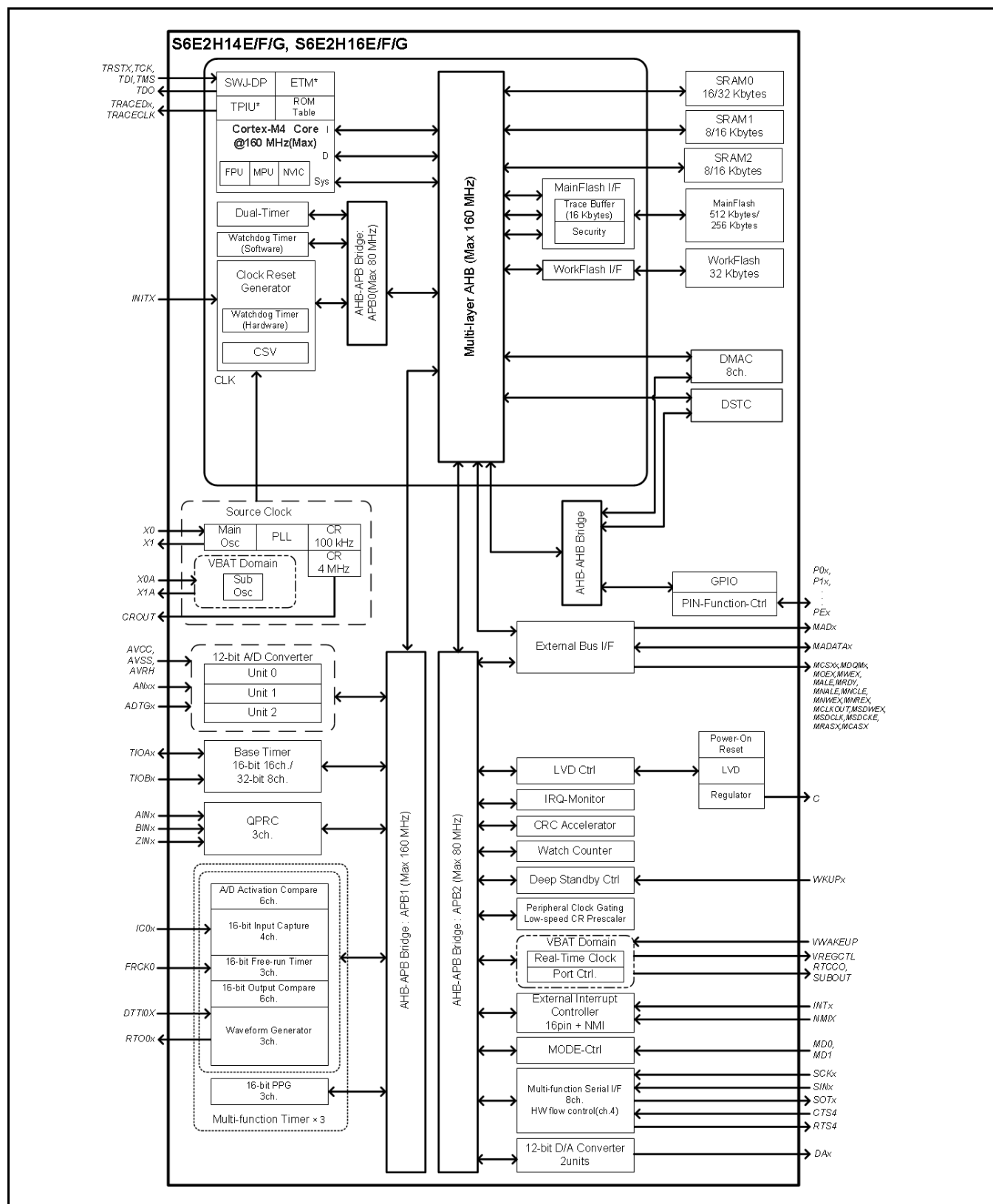
水晶発振回路 X1A と P48/VREGCTL の配線を隣接して並走させると、P48/VREGCTL の変化で X1A にノイズが載り、発振が誤カウントする可能性があります。それを避けるために、両者の配線の距離をできるだけ離し、間にグラウンドパタンを挿入してください。



デバッグ機能を兼用している端子について

TDO/TMS/TDI/TCK/TRSTX, SWO/SWDIO/SWCLK と兼用している端子は出力のみで使用してください。入力として使用してはいけません。

8. ブロックダイアグラム



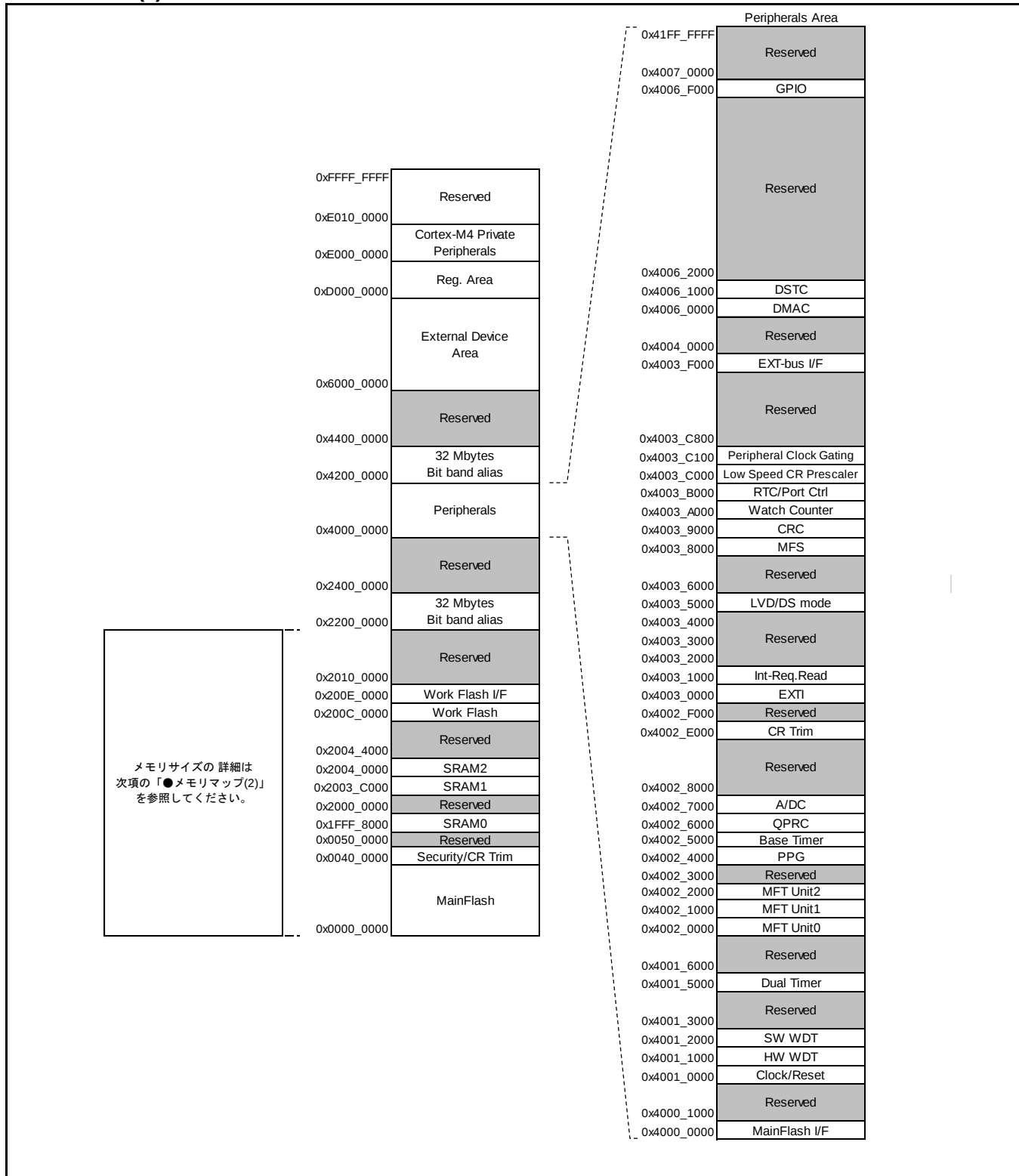
*: S6E2H14E0A, S6E2H16E0A では、ETM は使用できません。

9. メモリサイズ

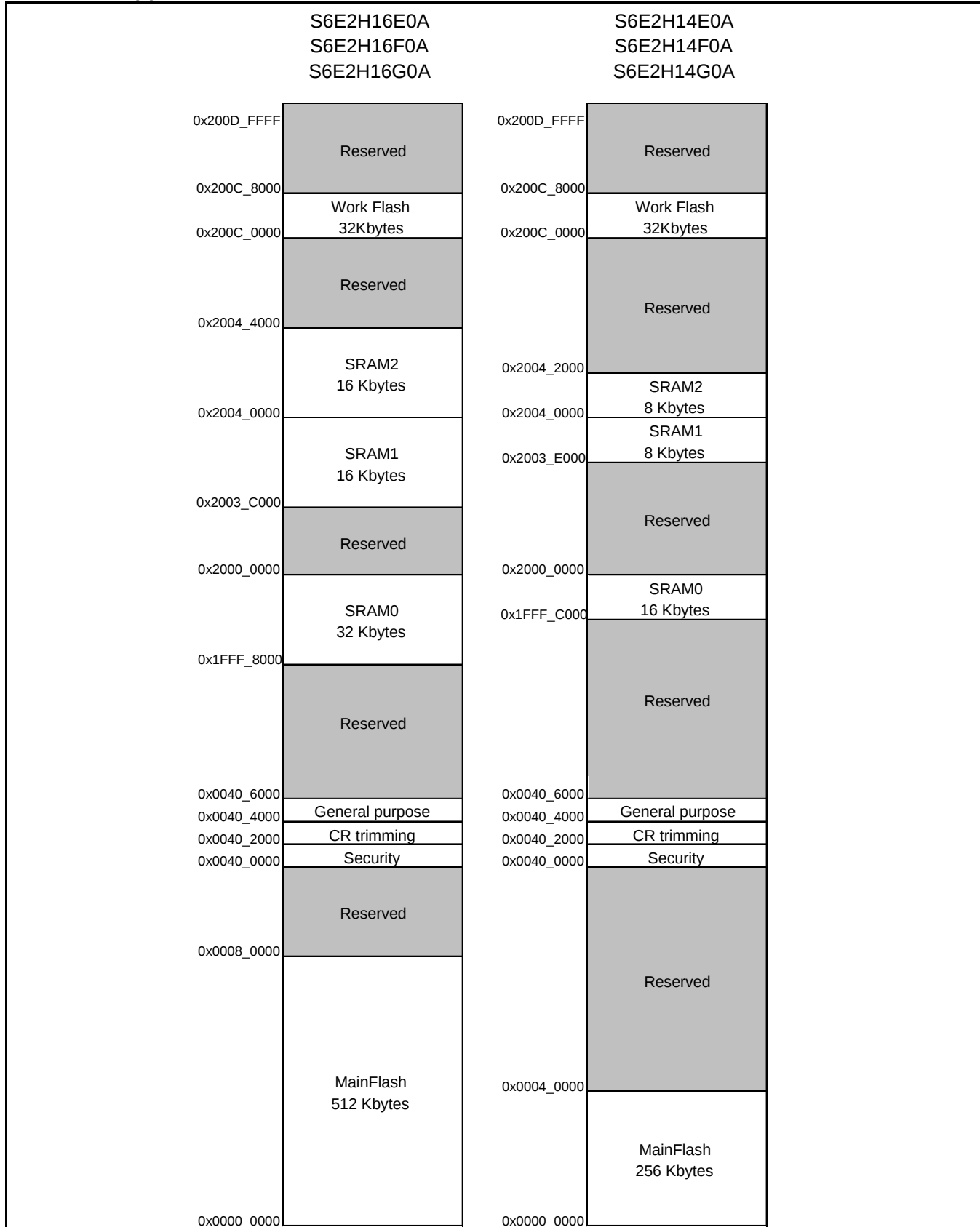
メモリサイズについては、「1. 品種構成」の「メモリサイズ」を参照してください。

10. メモリマップ

メモリマップ (1)



メモリマップ (2)



ペリフェラル・アドレスマップ

スタート アドレス	エンド アドレス	バス	周辺機能
0x4000_0000	0x4000_0FFF	AHB	MainFlash I/F レジスタ
0x4000_1000	0x4000_FFFF		予約
0x4001_0000	0x4001_0FFF	APB0	クロック・リセット制御
0x4001_1000	0x4001_1FFF		ハードウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_2000	0x4001_2FFF		ソフトウェアウォッチドッグタイマ
0x4001_3000	0x4001_4FFF		予約
0x4001_5000	0x4001_5FFF		デュアルタイマ
0x4001_6000	0x4001_FFFF		予約
0x4002_0000	0x4002_0FFF		多機能タイマ unit0
0x4002_1000	0x4002_1FFF		多機能タイマ unit1
0x4002_2000	0x4002_2FFF	APB1	多機能タイマ unit2
0x4002_3000	0x4003_FFFF		予約
0x4002_4000	0x4002_4FFF		PPG
0x4002_5000	0x4002_5FFF		ベースタイマ
0x4002_6000	0x4002_6FFF		クアッドカウンタ
0x4002_7000	0x4002_7FFF		A/D コンバータ
0x4002_8000	0x4002_DFFF		予約
0x4002_E000	0x4002_EFFF		内蔵 CR トリミング
0x4002_F000	0x4002_FFFF		予約
0x4003_0000	0x4003_0FFF	APB2	外部割込み
0x4003_1000	0x4003_1FFF		割込み要因確認レジスタ
0x4003_2000	0x4003_4FFF		予約
0x4003_3000	0x4003_3FFF		D/A コンバータ
0x4003_4000	0x4003_4FFF		予約
0x4003_5000	0x4003_57FF		低電圧検出
0x4003_5800	0x4003_5FFF		ディープスタンバイ制御部
0x4003_6000	0x4003_7FFF		予約
0x4003_8000	0x4003_8FFF		マルチファンクションシリアル
0x4003_9000	0x4003_9FFF		CRC
0x4003_A000	0x4003_AFFF		時計カウンタ
0x4003_B000	0x4003_BFFF		RTC/Port Ctrl
0x4003_C000	0x4003_C0FF		低速 CR 補正
0x4003_C100	0x4003_C7FF		周辺クロック停止
0x4003_C800	0x4003_EFFF		予約
0x4003_F000	0x4003_FFFF		外部バス I/F
0x4004_0000	0x4005_FFFF	AHB	予約
0x4006_0000	0x4006_0FFF		DMAC レジスタ
0x4006_1000	0x4006_1FFF		DSTC レジスタ
0x4006_2000	0x4006_EFFF		予約
0x4006_F000	0x4006_FFFF		GPIO
0x4006_7000	0x41FF_FFFF		予約
0x200E_0000	0x200E_FFFF	AHB	WorkFlash I/F レジスタ

11. 各 CPU ステートにおける端子状態

端子の状態として使用している語句は、以下の意味を持ちます。

■INITX=0

INITX 端子が L レベルの期間です。

■INITX=1

INITX 端子が H レベルの期間です。

■SPL=0

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が 0 に設定された状態です。

■SPL=1

スタンバイモードコントロールレジスタ(STB_CTL)のスタンバイ端子レベル設定ビット(SPL)が 1 に設定された状態です。

■入力可

入力機能が使用可能な状態です。

■内部入力"0"固定

入力機能が使用できない状態です。内部入力は L に固定されます。

■Hi-Z

端子駆動用トランジスタを駆動禁止状態にし、端子を Hi-Z にします。

■設定不可

設定できません。

■直前状態保持

本モードに遷移する直前の状態を保持します。
内蔵されている周辺機能が動作中であれば、その周辺機能にしたがいます。
ポートとして使用している場合は、その状態を保持します。

■アナログ入力可

アナログ入力が許可されています。

■トレース出力

トレース機能が使用可能な状態です。

■GPIO 選択

ディープスタンバイモード時、汎用 I/O ポートに切り換わります。

■設定禁止

仕様制限により設定禁止です。

端子状態一覧表

端子状態形式	グループ機能名	パワーオンリセットまたは低電圧検出状態	INITX入力状態	デバイス内部リセット状態	ランモードまたはスリープモード状態	タイマモード、RTCモードまたはストップモード状態		ディープスタンバイRTCモードまたはディープスタンバイストップモード状態		ディープスタンバイモード復帰直後状態
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定		電源安定		電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-
A	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	メイン水晶 発振入力端子/ 外部メイン クロック入力 選択時	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
B	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	外部メイン クロック入力 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態保持
	メイン水晶 発振出力端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 または 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	直前状態保持/ 発振停止時*1は Hi-Z/ 内部入力"0"固定					
C	INITX 入力端子	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可
D	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
E	モード 入力端子	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可
	GPIO 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 入力可	GPIO 選択	Hi-Z/ 入力可	GPIO 選択
F	NMIX 選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	WKUP 入力可	Hi-Z/ WKUP 入力可	GPIO 選択
	上記以外の リソース選択 時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定						
	GPIO 選択時									直前状態保持

端子状態形式	グループ機能名	パワーオンリセットまたは低電圧検出状態	INITX入力状態	デバイス内部リセット状態	ランモードまたはスリープモード状態	タイマモード、RTCモードまたはストップモード状態		ディープスタンバイRTCモードまたはディープスタンバイストップモード状態		ディープスタンバイモード復帰直後状態
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定		電源安定		電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-
G	JTAG選択時	Hi-Z	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持
	GPIO選択時	設定不可	設定不可	設定不可			Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択
H	JTAG選択時	Hi-Z	プルアップ/ 入力可	プルアップ/ 入力可	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持
	上記以外のリソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可			Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択
	GPIO選択時									
I	リソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択
	GPIO選択時									
J	アナログ出力選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	*2	*3	GPIO選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択
	上記以外のリソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可		直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			
	GPIO選択時									
K	外部割込み許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	GPIO選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO選択
	上記以外のリソース選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			
	GPIO選択時									

端子状態形式	グループ機能名	パワーオンリセットまたは低電圧検出状態	INITX入力状態	デバイス内部リセット状態	ランモードまたはスリープモード状態	タイマモード, RTC モードまたはストップモード状態		ディープスタンバイ RTC モードまたはディープスタンバイストップモード状態		ディープスタンバイモード復帰直後状態
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定		電源安定		電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-
L	アナログ入力選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可
	上記以外のリソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	GPIO 選択時									
M	アナログ入力選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可
	外部割込み許可選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態保持	直前状態保持	直前状態保持	GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	上記以外のリソース選択時						Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			
	GPIO 選択時									

端子状態形式	グループ機能名	パワーオンリセットまたは低電圧検出状態	INITX入力状態	デバイス内部リセット状態	ランモードまたはスリープモード状態	タイマモード, RTC モードまたはストップモード状態		ディープスタンバイ RTC モードまたはディープスタンバイストップモード状態		ディープスタンバイモード復帰直後状態
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定		電源安定		電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-
N	アナログ入力選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可
	トレース選択時						トレース 出力			
	上記以外のリソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持		GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	GPIO 選択時						Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			
O	アナログ入力選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可
	トレース選択時						トレース 出力			
	外部割込み許可選択時						直前状態 保持			
	上記以外のリソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持		GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	GPIO 選択時						Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			
P	アナログ入力選択時	Hi-Z	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定/ アナログ 入力可
	WKUP 許可時						直前状態 保持	WKUP 入力可	Hi-Z/ WKUP 入力可	
	上記以外のリソース選択時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持		GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択
	GPIO 選択時						Hi-Z/ 内部入力 "0"固定			

端子状態形式	グループ機能名	パワーオンリセット または 低電圧検出 状態	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ランモード または スリープ モード 状態	タイマモード, RTC モード, または ストップモード 状態		ディープスタンバイ RTC モード または ディープスタンバイ ストップモード 状態		ディープ スタンバイ モード 復帰直後 状態
		電源不安定	電源安定		電源安定	電源安定		電源安定		電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-
Q	WKUP 許可時	設定不可	設定不可	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	WKUP 入力可	Hi-Z/ WKUP 入力可	GPIO 選択
	外部割込み許可 選択時									
	上記以外の リソース選択 時	Hi-Z	Hi-Z/ 入力可	Hi-Z/ 入力可			Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	GPIO 選択 内部入力 "0"固定	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定	
	GPIO 選択時									

*1: サブタイマ, 低速 CR タイマモード, ストップモード, RTC モード, ディープスタンバイ RTC モード, ディープスタンバイストップモードは発振が停止します。

*2: タイマモード状態は直前状態保持、RTC モードまたはストップモード状態は GPIO 選択/内部入力 0 固定です。

*3: タイマモード状態は直前状態保持、RTC モードまたはストップモード状態は Hi-Z/内部入力 0 固定です。

VBAT ドメイン端子状態一覧表

VBAT 端子状態形式	グループ機能名	VBAT パワー オン リセット *1	INITX 入力 状態	デバイス 内部 リセット 状態	ラン モード または スリープ モード 状態	タイマモード, RTC モード, または ストップモード 状態		ディープスタンバイ RTC モード または ディープスタンバイ ストップモード 状態		ディープ スタンバイ モード 復帰直後 状態	VBAT RTC モード 状態	VBAT RTC モード 復帰直後 状態
		電源不安 定	電源安定	電源安定	電源安定	電源安定		電源安定		電源安定	電源安 定	電源安定
		-	INITX=0	INITX=1	INITX=1	INITX=1		INITX=1		INITX=1	-	-
		-	-	-	-	SPL=0	SPL=1	SPL=0	SPL=1	-	-	-
S	GPIO 選択時	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	GPIO 選択	設定禁 止	-
	サブ水晶 発振 入力端子 / 外部サブ クロック 入力選択 時	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	入力可	直前状 態 保持	直前状態 保持
T	GPIO 選択時	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	GPIO 選択	設定禁 止	-
	外部サブ クロック 入力 選択時	設定不可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状 態 保持	直前状態 保持
	サブ水晶 発振出力 端子	Hi-Z/ 内部入力 "0"固定 または 入力可	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持/ 発振 停止時は Hi-Z*2	直前状態 保持/ 発振 停止時は Hi-Z *2	直前状態 保持/ 発振 停止時は Hi-Z *2	直前状態 保持/ 発振 停止時は Hi-Z *2	直前状態 保持	直前状 態 保持	直前状態 保持
U	リソース 選択時	Hi-Z	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状態 保持	直前状 態 保持	直前状態 保持
	GPIO 選択時											

*1: VBAT,VCC 電源投入状態

*2: WTOSCCNT レジスタの連携制御ビット(SOSCNTRL)が 0 の場合は直前状態保持。

WTOSCCNT レジスタの連携制御ビット(SOSCNTRL)が 1 の場合は、ストップモード、ディープスタンバイストップモード時に発振が停止します。

12. 電気的特性

12.1 絶対最大定格

項目	記号	定格値		単位	備考
		最小	最大		
電源電圧*1,*2	V _{CC}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
電源電圧(V _{BAT}) *1,*3	V _{BAT}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
アナログ電源電圧*1,*4	AV _{CC}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
アナログ基準電圧*1,*4	AV _{RH}	V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	
入力電圧*1	V _I	V _{SS} - 0.5	V _{CC} + 0.5 (≦6.5 V)	V	
		V _{SS} - 0.5	V _{SS} + 6.5	V	5 V トレラント
アナログ端子入力電圧*1	V _{IA}	V _{SS} - 0.5	AV _{CC} + 0.5 (≦6.5 V)	V	
出力電圧*1	V _O	V _{SS} - 0.5	V _{CC} + 0.5 (≦6.5 V)	V	
"L"レベル最大出力電流*5	I _{OL}	-	10	mA	4 mA タイプ
			20	mA	8 mA タイプ
			20	mA	12 mA タイプ
			22.4	mA	I ² C Fm+
"L"レベル平均出力電流*6	I _{OLAV}	-	4	mA	4 mA タイプ
			8	mA	8 mA タイプ
			12	mA	12 mA タイプ
			20	mA	I ² C Fm+
"L"レベル最大総出力電流	ΣI _{OL}	-	100	mA	
"L"レベル平均総出力電流*7	ΣI _{OLAV}	-	50	mA	
"H"レベル最大出力電流*5	I _{OH}	-	- 10	mA	4 mA タイプ
			20	mA	8 mA タイプ
			- 20	mA	12 mA タイプ
"H"レベル平均出力電流*6	I _{OHAV}	-	- 4	mA	4 mA タイプ
			8	mA	8 mA タイプ
			- 12	mA	12 mA タイプ
"H"レベル最大総出力電流	ΣI _{OH}	-	- 100	mA	
"H"レベル平均総出力電流*7	ΣI _{OHAV}	-	- 50	mA	
保存温度	T _{STG}	- 55	+ 150	°C	

*1: V_{SS} = AV_{SS} = 0 V を基準にした値です。

*2: V_{CC} は V_{SS} - 0.5 V より低くならないでください。

*3: V_{BAT} は V_{SS} - 0.5 V より低くならないでください。

*4: 電源投入時など V_{CC} + 0.5 V を超えてはいけません。

*5: 最大出力電流は、該当する端子 1 本のピーク値を規定します。

*6: 平均出力電流は、該当する端子 1 本に流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

*7: 平均総出力電流は、該当する端子すべてに流れる電流の 100 ms の期間内での平均電流を規定します。

<注意事項>

- 絶対最大定格を超えるストレス (電圧, 電流, 温度など) の印加は、半導体デバイスを破壊する可能性があります。したがって、定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

12.2 推奨動作条件

項目	記号	条件	規格値		単位	備考
			最小	最大		
電源電圧	V _{CC}	-	2.7*4	5.5	V	
電源電圧(VBAT)	V _{BAT}	-	2.7	5.5	V	
アナログ電源電圧	AV _{CC}	-	2.7	5.5	V	AV _{CC} =V _{CC}
基準電圧	AV _{RH}	-	*3	AV _{CC}	V	
平滑コンデンサ容量	C _S	-	1	10	μF	内蔵レギュレータ用*1
動作温度	ジャンクション温度	T _J	-	- 40	+ 125	°C
	周囲温度	T _A	-	- 40	*2	°C

*1: 平滑コンデンサの接続方法は、「デバイス使用上の注意」の「C 端子について」を参照してください。

*2: 周囲温度(T_A)の最大温度は、ジャンクション温度(T_J)を超えない範囲まで保証可能です。
周囲温度(T_A)の計算式を以下に示します。

$$T_A (\text{Max}) = T_J (\text{Max}) - P_d (\text{Max}) \times \theta_{ja}$$

P_d : 消費電力(W)
 θ_{ja} : パッケージ熱抵抗(°C/W)

$$P_d (\text{Max}) = V_{CC} \times I_{CC} (\text{Max}) + \sum (I_{OL} \times V_{OL}) + \sum ((V_{CC} - V_{OH}) \times (-I_{OH}))$$

I_{OL} : L レベル出力電流
 I_{OH} : H レベル出力電流
 V_{OL} : L レベル出力電圧
 V_{OH} : H レベル出力電圧

*3: アナログ基準電圧は、コンペアクロック周期によって規格値が異なります。

詳細は「12.5 12 ビット A/D コンバータ」の章を参照してください。

*4: 電源電圧が最小値未満かつ低電圧リセット/割込み検出電圧以上の間は、内蔵高速 CR クロック (メイン PLL 使用含む)または内蔵低速 CR クロックでの命令実行と低電圧検出のみ動作可能です。

各パッケージにおけるパッケージ熱抵抗と最大許容電力を以下に示します。
半導体デバイスは最大許容電力以下で動作が保証されます。

パッケージ熱抵抗と最大許容電力表

パッケージ	基板	熱抵抗 θ_{ja} (°C/W)	最大許容電力(mW)	
			T _A =+85°C	T _A =+105°C
LQH080 (0.5-mm pitch)	単層両面	82	488	244
	4 層	56	714	357
LQI100 (0.5-mm pitch)	単層両面	59	678	339
	4 層	39	1026	513
LQM120 (0.5-mm pitch)	単層両面	71	563	282
	4 層	50	800	400
FDI121 (0.5-mm pitch)	単層両面	63	635	317
	4 層	37	1081	540

<注意事項>

- 推奨動作条件は、半導体デバイスの正常な動作を確保するための条件です。電気的特性の規格値は、すべてこの条件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると、信頼性に悪影響を及ぼすことがあります。
データシートに記載されていない項目、使用条件、論理の組合せでの使用は、保証していません。記載されている以外の条件での使用をお考えの場合は、必ず事前に営業部門までご相談ください。

消費電力(Pd)の算出方法

消費電力は以下の式で表されます。

$$Pd = V_{CC} \times I_{CC} + \Sigma (I_{OL} \times V_{OL}) + \Sigma ((V_{CC} - V_{OH}) \times (-I_{OH}))$$

I_{OL} : L レベル出力電流

I_{OH} : H レベル出力電流

V_{OL} : L レベル出力電圧

V_{OH} : H レベル出力電圧

I_{CC} はデバイス内で消費される電流です。
以下に分解できます。

$$I_{CC} = I_{CC}(INT) + \Sigma I_{CC}(IO)$$

$I_{CC}(INT)$: レギュレータを通して内部 Logic, メモリなどで消費される電流

$\Sigma I_{CC}(IO)$: 出力端子にて消費される電流(I/O スイッチング電流)の合計

$I_{CC}(INT)$ については「3.直流規格」の「(1)電流規格」によって予測できます (本規格の値は端子固定時の値のため、 $I_{CC}(IO)$ は含んでいません)。

$I_{CC}(IO)$ についてはお客様のシステムに依存します。

以下の計算式により算出してください。

$$I_{CC}(IO) = (C_{INT} + C_{EXT}) \times V_{CC} \times f_{sw}$$

C_{INT} : 端子内部負荷容量

C_{EXT} : 出力端子の外部負荷容量

f_{sw} : 端子スイッチング周波数

項目	記号	条件	容量値
端子内部負荷容量	C_{INT}	4 mA タイプ	1.93 pF
		8 mA タイプ	3.45 pF
		12 mA タイプ	3.42 pF

お客様ご自身で消費電力を評価可能な場合には、 $I_{CC}(Max)$ の値は以下のように算出してください。

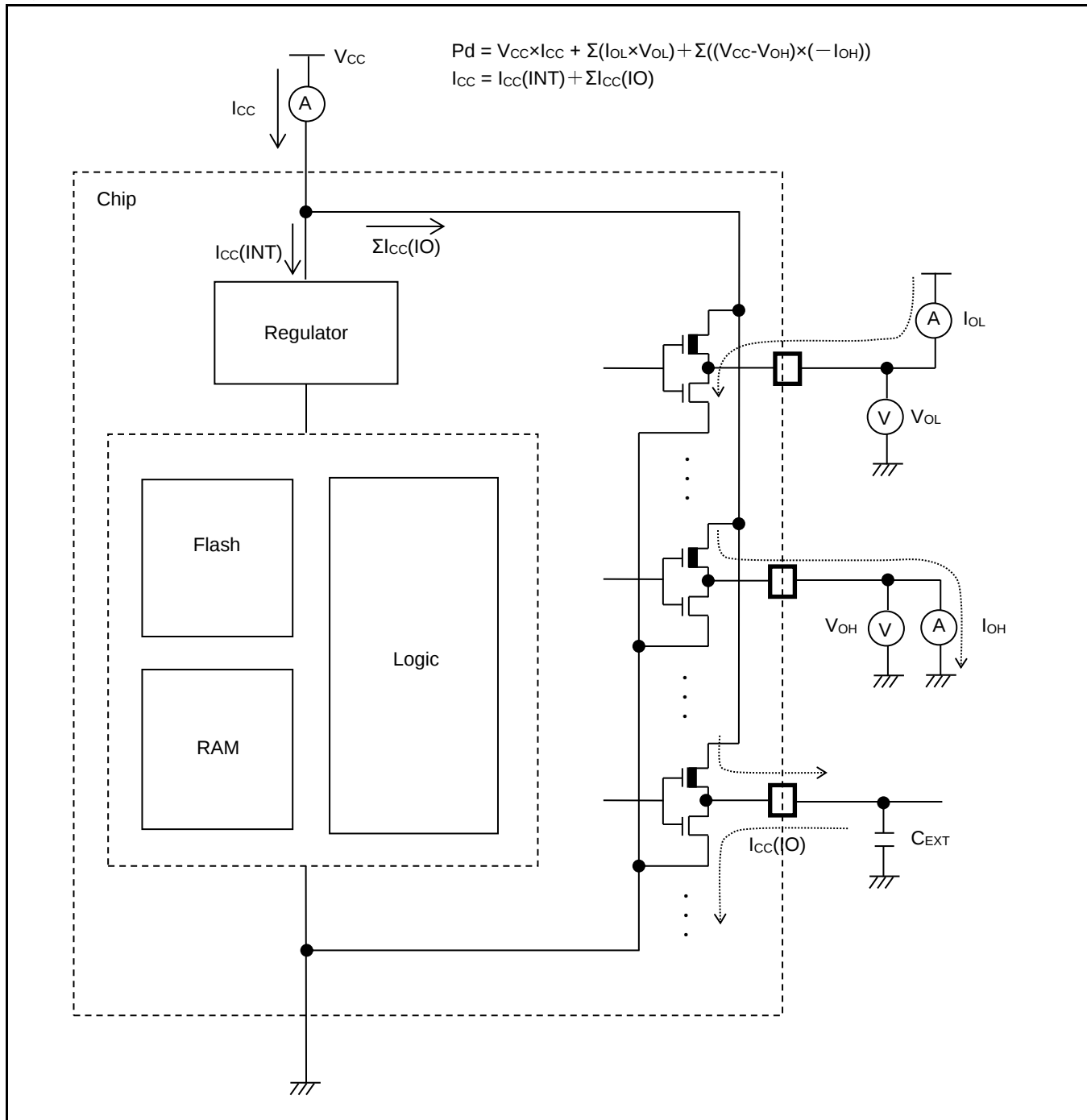
(1) 常温(+25°C)にて電流値 $I_{CC}(Typ)$ を測定

(2) (1)の値に動作時最大リーク電流値 $I_{CC}(leak_max)$ を加算

$$I_{CC}(Max) = I_{CC}(Typ) + I_{CC}(leak_max)$$

項目	記号	条件	電流値
動作時最大リーク電流	$I_{CC}(leak_max)$	$T_J = +125^\circ C$	16.8 mA
		$T_J = +105^\circ C$	8.6 mA
		$T_J = +85^\circ C$	5.8 mA

電流説明図



12.3 直流規格

12.3.1 電流規格

Table 12-1 通常動作(PLL)の標準と最大の消費電流, フラッシュ・メモリから実行しているとき
(フラッシュアクセラレータモードとトレースバッファ機能が有効)

項目	記号	端子名	条件	周波数*4	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{cc}	VCC	通常動作*5, *6 *9 (PLL)	160 MHz	51	71	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
				144 MHz	47	67		
				120 MHz	39	59		
				100 MHz	33	53		
				80 MHz	27	47		
				60 MHz	20	40		
				40 MHz	14	34		
				20 MHz	7.6	28		
				8 MHz	3.9	24		
				4 MHz	2.7	23		
				160 MHz	30	51	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
				144 MHz	28	48		
				120 MHz	23	43		
				100 MHz	20	40		
				80 MHz	16	36		
				60 MHz	12	32		
				40 MHz	8.7	29		
				20 MHz	5.0	25		
				8 MHz	2.8	23		
				4 MHz	2.1	22		

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK/2。

*5: フラッシュアクセラレータモード, トレースバッファ機能動作 (FRWTR.RWT = 10, FBFCR.BE = 1)のとき

*6: メインフラッシュメモリへのデータアクセスなし。

*7: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK2=HCLK/2, PCLK1=HCLK。

*8: フラッシュアクセラレータモード, トレースバッファ機能停止 (FRWTR.RWT = 10, FBFCR.BE = 0)のとき

*9: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-2 通常動作(PLL)の標準と最大の消費電流, データアクセスを含むコードがフラッシュ・メモリから実行しているとき(フラッシュアクセラレータモードとトレースバッファ機能が無効)

項目	記号	端子名	条件	周波数*7	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{cc}	VCC	通常動作*8 *9 (PLL)	160 MHz	56	76	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
				144 MHz	51	71		
				120 MHz	43	63		
				100 MHz	37	57		
				80 MHz	30	50		
				60 MHz	23	43		
				40 MHz	16	36		
				20 MHz	8.5	29		
				8 MHz	4.3	25		
				4 MHz	2.9	23		
				160 MHz	30	51	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
				144 MHz	28	48		
				120 MHz	24	44		
				100 MHz	20	41		
				80 MHz	17	37		
				60 MHz	13	33		
				40 MHz	9.2	30		
				20 MHz	5.3	26		
				8 MHz	3.0	23		
				4 MHz	2.2	23		

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK/2。

*5: フラッシュアクセラレータモード, トレースバッファ機能動作 (FRWTR.RWT = 10, FBFCR.BE = 1)のとき

*6: メインフラッシュメモリへのデータアクセスなし。

*7: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK2=HCLK/2, PCLK1=HCLK。

*8: フラッシュアクセラレータモード, トレースバッファ機能停止 (FRWTR.RWT = 10, FBFCR.BE = 0)のとき

*9: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-3 通常動作(PLL)の標準と最大の消費電流, データアクセスを含むコードがフラッシュ・メモリから実行しているとき (フラッシュ 0 サイクルウェイトモード, リードアクセス 0 ウェイト)

項目	記号	端子名	条件	周波数*4	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CC}	V _{CC}	通常動作*5 *6 (PLL)	72 MHz	38	58	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
				60 MHz	33	53		
				48 MHz	28	48		
				36 MHz	22	42		
				24 MHz	16	36		
				12 MHz	9.5	30		
				8 MHz	6.9	27		
				4 MHz	4.2	25		
				72 MHz	29	49	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
				60 MHz	26	46		
				48 MHz	22	42		
				36 MHz	18	38		
				24 MHz	13	33		
				12 MHz	7.8	28		
				8 MHz	5.8	26		
				4 MHz	3.7	24		

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK。

*5: 0 wait-cycle (FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000)のとき

*6: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-4 通常動作(PLL 以外)の標準と最大の消費電流, データアクセスを含むコードがフラッシュ・メモリから実行しているとき (フラッシュ 0 サイクルウェイトモード, リードアクセス 0 ウェイト)

項目	記号	端子名	条件	周波数*4	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CC}	V _{CC}	通常動作*5 (メイン発振)	4 MHz	4.0	24	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					3.2	24	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			通常動作*5 (内蔵高速 CR)	4 MHz	3.2	24	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					2.7	23	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			通常動作*5 *6 (サブ発振)	32 kHz	0.34	21	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					0.30	21	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			通常動作*5 (内蔵低速 CR)	100 kHz	0.36	21	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					0.33	21	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK/2。

*5: 0 wait-cycle (FRWTR.RWT = 00, FSYNDN.SD = 000)のとき

*6: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-5 Sleep 動作(PLL)の標準と最大の消費電流, PCLK0 = PCLK1 = PCLK2 = HCLK/2 のとき

項目	記号	端子名	条件	周波数*4	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CCS}	VCC	Sleep 動作*6 (PLL)	160 MHz	35	55	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
				144 MHz	32	52		
				120 MHz	27	47		
				100 MHz	23	43		
				80 MHz	18	39		
				60 MHz	14	34		
				40 MHz	9.9	30		
				20 MHz	5.5	26		
				8 MHz	3.1	23		
				4 MHz	2.3	23		
				160 MHz	14	35	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
				144 MHz	13	33		
				120 MHz	11	31		
				100 MHz	9.5	30		
				80 MHz	7.8	28		
				60 MHz	6.3	27		
				40 MHz	4.6	25		
				20 MHz	2.9	23		
				8 MHz	2.2	23		
				4 MHz	2.0	22		

Table 12-6 Sleep 動作(PLL)の標準と最大の消費電流, PCLK0 = PCLK1 = PCLK2 = HCLK のとき

項目	記号	端子名	条件	周波数*5	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CCS}	VCC	Sleep 動作*6 (PLL)	72 MHz	23	43	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
				60 MHz	19	39		
				48 MHz	16	36		
				36 MHz	12	32		
				24 MHz	8.5	29		
				12 MHz	5.1	25		
				8 MHz	3.9	24		
				4 MHz	2.7	23		
				72 MHz	8.8	29	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
				60 MHz	7.6	28		
				48 MHz	6.3	27		
				36 MHz	5.1	25		
				24 MHz	3.9	24		
				12 MHz	2.7	23		
				8 MHz	2.3	23		
				4 MHz	1.9	22		

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK/2。

*5: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK。

*6: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-7 Sleep 動作(PLL 以外)の標準と最大の消費電流, PCLK0 = PCLK1 = PCLK2 = HCLK/2 のとき

項目	記号	端子名	条件	周波数*4	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CCS}	VCC	Sleep 動作*5 (メイン発振)	4 MHz	2.1	22	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					1.3	22	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			Sleep 動作 (内蔵高速 CR)	4 MHz	1.3	22	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					0.8	21	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			Sleep 動作 (サブ発振)	32 kHz	0.28	21	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					0.27	21	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時
			Sleep 動作 (内蔵低速 CR)	100 kHz	0.29	21	mA	*3 周辺クロック すべて ON 時
					0.28	21	mA	*3 周辺クロック すべて OFF 時

*1: T_A=+25°C, V_{CC}=3.3 V

*2: T_J=+125°C, V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: 周波数は HCLK の値です。PCLK0=PCLK1=PCLK2=HCLK/2。

*5: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-8 ストップモード、タイマモード、RTC モードの標準と最大の消費電流

項目	記号	端子名	条件	周波数	規格値		単位	備考	
					標準*1	最大*2			
電源電流	I _{CCH}	VCC	ストップモード	-	0.21	0.94	mA	*3, *4 T _A =+25°C	
					-	7.6	mA	*3, *4 T _A =+85°C	
					-	10	mA	*3, *4 T _A =+105°C	
	I _{CCT}		タイマモード *5 (メイン発振)	4 MHz	1.4	2.1	mA	*3, *4 T _A =+25°C	
					-	8.8	mA	*3, *4 T _A =+85°C	
					-	11	mA	*3, *4 T _A =+105°C	
			タイマモード (内蔵高速 CR)	4 MHz	0.49	1.2	mA	*3, *4 T _A =+25°C	
					-	7.9	mA	*3, *4 T _A =+85°C	
					-	11	mA	*3, *4 T _A =+105°C	
			タイマモード (サブ発振)	32 kHz	0.23	0.96	mA	*3, *4 T _A =+25°C	
					-	7.6	mA	*3, *4 T _A =+85°C	
					-	10	mA	*3, *4 T _A =+105°C	
			タイマモード (内蔵低速 CR)	100 kHz	0.24	0.97	mA	*3, *4 T _A =+25°C	
					-	7.6	mA	*3, *4 T _A =+85°C	
					-	10	mA	*3, *4 T _A =+105°C	
			I _{CCR}	RTC モード (サブ発振)	32 kHz	0.21	0.94	mA	*3, *4 T _A =+25°C
						-	7.6	mA	*3, *4 T _A =+85°C
						-	10	mA	*3, *4 T _A =+105°C

*1: V_{CC}=3.3 V

*2: V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: LVD OFF 時

*5: 水晶振動子(4 MHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

Table 12-9 ディープスタンバイストップモード、ディープスタンバイ RTC モード、VBAT の標準と最大の消費電流

項目	記号	端子名	条件	周波数	規格値		単位	備考
					標準*1	最大*2		
電源電流	I _{CCHD}	VCC	ディープ スタンバイストップ モード (RAM OFF 時)	-	24	40	μA	*3, *4 T _A =+25°C
					-	640	μA	*3, *4 T _A =+85°C
					-	813	μA	*3, *4 T _A =+105°C
			41		146	μA	*3, *4 T _A =+25°C	
			-		1616	μA	*3, *4 T _A =+85°C	
			-		2059	μA	*3, *4 T _A =+105°C	
	I _{CCRD}	VCC	ディープ スタンバイ RTC モー ド*6 (RAM OFF 時)	32 kHz	24	40	μA	*3, *4 T _A =+25°C
					-	640	μA	*3, *4 T _A =+85°C
					-	813	μA	*3, *4 T _A =+105°C
			41		146	μA	*3, *4 T _A =+25°C	
			-		1616	μA	*3, *4 T _A =+85°C	
			-		2059	μA	*3, *4 T _A =+105°C	
	I _{CCVBA T}	VBAT	RTC 停止*7	-	0.015	0.14	μA	*3, *4, *5 T _A =+25°C
					-	4.0	μA	*3, *4, *5 T _A =+85°C
					-	9.4	μA	*3, *4, *5 T _A =+105°C
			1.3		2.4	μA	*3, *4 T _A =+25°C	
			-		6.2	μA	*3, *4 T _A =+85°C	
			-		12	μA	*3, *4 T _A =+105°C	

*1: V_{CC}=3.3 V

*2: V_{CC}=5.5 V

*3: 全ポート固定時

*4: LVD OFF 時

*5: サブ発振 OFF 時

*6: 水晶振動子(32 kHz)使用時(発振回路の消費電流を含む)

*7: VCC 電源投入後、RTC の設定を行った時

Table 12-10 低電圧検出回路, メインフラッシュメモリ書込み/消去の標準と最大の消費電流

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
低電圧 検出回路 (LVD) 電源電流	I _{CCLVD}	VCC	動作時	-	4	7	μA	割込み発生用
メインフラッシュメモリ 書込み/消去電流	I _{CCFLASH}		書込み/ 消去時	-	13.4	15.9	mA	
ワークフラッシュメモリ 書込み/消去電流	I _{CCWFLASH}		書込み/ 消去時	-	11.5	13.6	mA	*1

*1: フラッシュメモリへ書込み、または消去するときは電源電流 ICC にフラッシュ書込み/消去電流 I_{CCFLASH} が加算されます。

Table 12-11 ペリフェラル消費電流

クロック 系列	ペリフェラル	単位	周波数(MHz)			単位	備考
			40	80	160		
HCLK	GPIO	全ポート	0.16	0.32	0.62	mA	T _A =+25°C V _{CC} =3.3 V
	DMAC	-	0.68	1.35	2.63		
	DSTC	-	0.93	1.88	3.65		
	外部バス I/F	-	0.17	0.34	0.71		
PCLK1	ベースタイマ	4 ch.	0.18	0.37	0.73	mA	T _A =+25°C V _{CC} =3.3 V
	多機能タイマ/PPG	1 unit / 4 ch.	0.61	1.22	2.43		
	クアッドカウンタ	1 unit	0.04	0.07	0.14		
	A/DC	1 unit	0.22	0.44	0.88		
PCLK2	マルチファンクション シリアル	1 ch.	0.30	0.60	-	mA	T _A =+25°C V _{CC} =3.3 V

12.3.2 端子特性

($V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = AV_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
H レベル 入力電圧 (ヒステリシス入 力)	V_{IHS}	CMOS ヒステリシス入力端 子, MD0, MD1	-	$V_{CC} \times 0.8$	-	$V_{CC} + 0.3$	V	
		5 V トレラント入力端子	-	$V_{CC} \times 0.8$	-	$V_{SS} + 5.5$	V	
		I ² C Fm+ 兼用 入力端子	-	$V_{CC} \times 0.7$	-	$V_{SS} + 5.5$	V	
L レベル 入力電圧 (ヒステリシス入 力)	V_{ILS}	CMOS ヒステリシス入力端 子, MD0, MD1	-	$V_{SS} - 0.3$	-	$V_{CC} \times 0.2$	V	
		5 V トレラント 入力端子	-	$V_{SS} - 0.3$	-	$V_{CC} \times 0.2$	V	
		I ² C Fm+ 兼用 入力端子	-	V_{SS}	-	$V_{CC} \times 0.3$	V	
H レベル 出力電圧	V_{OH}	4 mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5 V$, $I_{OH} = -4 mA$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5 V$, $I_{OH} = -2 mA$					
		8 mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5 V$, $I_{OH} = -8 mA$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5 V$, $I_{OH} = -4 mA$					
		12 mA タイプ	$V_{CC} \geq 4.5 V$, $I_{OH} = -12 mA$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	
			$V_{CC} < 4.5 V$, $I_{OH} = -8 mA$					
		I ² C Fm+ 兼用	$V_{CC} \geq 4.5 V$, $I_{OH} = -4 mA$	$V_{CC} - 0.5$	-	V_{CC}	V	GPIO 時
			$V_{CC} < 4.5 V$, $I_{OH} = -3 mA$					

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
L レベル 出力電圧	V _{OL}	4 mA タイプ	V _{CC} ≥ 4.5 V, I _{OL} = 4 mA	V _{SS}	-	0.4	V	
			V _{CC} < 4.5 V, I _{OL} = 2 mA					
		8 mA タイプ	V _{CC} ≥ 4.5 V, I _{OH} = 8 mA	V _{SS}	-	0.4	V	
			V _{CC} < 4.5 V, I _{OH} = 4 mA					
		12 mA タイプ	V _{CC} ≥ 4.5 V, I _{OL} = 12 mA	V _{SS}	-	0.4	V	
			V _{CC} < 4.5 V, I _{OL} = 8 mA					
		I2C Fm+ 兼用	V _{CC} ≥ 4.5 V, I _{OH} = 4 mA	V _{SS}	-	0.4	V	GPIO 時
			V _{CC} < 4.5 V, I _{OH} = 3 mA					I ² C Fm+時
			V _{CC} ≤ 5.5 V, I _{OH} = 20 mA					
入力リーク 電流	I _{IL}	-	-	- 5	-	+5	μA	
プルアップ 抵抗値	R _{PU}	プルアップ 端子	V _{CC} ≥ 4.5 V	25	50	100	kΩ	
			V _{CC} < 4.5 V	30	80	200		
入力容量	C _{IN}	VCC, VBAT, VSS, AVCC, AVSS, AVRH 以外	-	-	5	15	pF	

12.4 交流規格

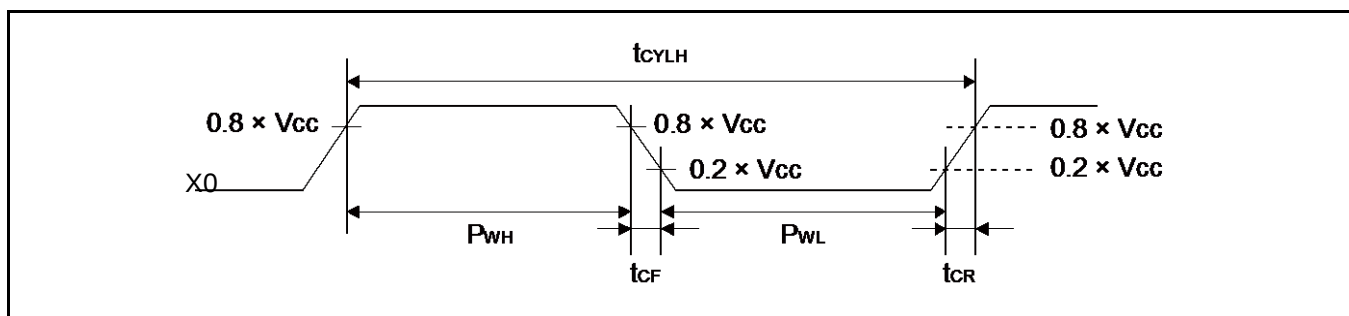
12.4.1 メインクロック入力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力周波数	f _{CH}	X0, X1	V _{CC} ≧ 4.5 V	4	48	MHz	水晶発振子接続時
			V _{CC} < 4.5 V	4	20		
			V _{CC} ≧ 4.5 V	4	48	MHz	外部クロック時
			V _{CC} < 4.5 V	4	20		
入力クロック周期	t _{CYLH}		V _{CC} ≧ 4.5 V	20.83	250	ns	外部クロック時
			V _{CC} < 4.5 V	50	250		
入力クロックパルス幅	-		P _{WH} /t _{CYLH} , P _{WL} /t _{CYLH}	45	55	%	外部クロック時
入力クロック立上り, 立下り時間	t _{CF} , t _{CR}		-	-	5	ns	外部クロック時
内部動作クロック*1 周波数	f _{CC}	-	-	-	160	MHz	ベースクロック (HCLK/FCLK)
	f _{CP0}	-	-	-	80	MHz	APB0 バスクロック*2
	f _{CP1}	-	-	-	160	MHz	APB1 バスクロック*2
	f _{CP2}	-	-	-	80	MHz	APB2 バスクロック*2
内部動作クロック*1 サイクル時間	t _{CYCC}	-	-	6.25	-	ns	ベースクロック (HCLK/FCLK)
	t _{CYCP0}	-	-	12.5	-	ns	APB0 バスクロック*2
	t _{CYCP1}	-	-	6.25	-	ns	APB1 バスクロック*2
	t _{CYCP2}	-	-	12.5	-	ns	APB2 バスクロック*2

*1: 各内部動作クロックの詳細については、『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 2-1:クロック』を参照してください。

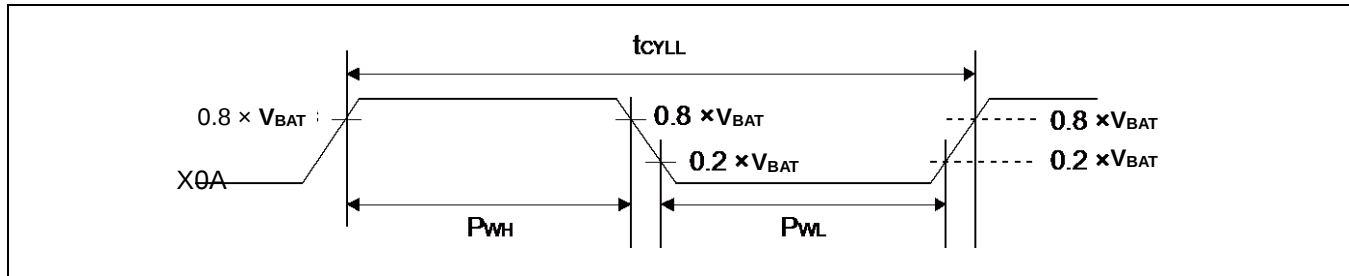
*2: 各ペリフェラルが接続されている APB バスについては「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。



12.4.2 サブクロック入力規格

($V_{BAT} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
入力周波数	$1/t_{CYLL}$	X0A, X1A	-	-	32.768	-	kHz	水晶発振接続時
			-	32	-	100	kHz	外部クロック時
入力クロック周期	t_{CYLL}		-	10	-	31.25	μs	外部クロック時
入力クロックパルス幅	-		P_{WH}/t_{CYLL} , P_{WL}/t_{CYLL}	45	-	55	%	外部クロック時



12.4.3 内蔵CR 発振規格

内蔵高速 CR

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	f_{CRH}	$T_J = -20^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$	3.92	4	4.08	MHz	トリミング時*1
		$T_J = -40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$	3.88	4	4.12		
		$T_J = -40^{\circ}C \sim +125^{\circ}C$	2.9	4	5		非トリミング時
周波数安定時間	t_{CRWT}	-	-		30	μs	*2

*1: 出荷時に設定されるフラッシュメモリ内の CR トリミング領域の値を周波数トリミング値/温度トリミング値に使用した場合

*2: トリミング値設定後に高速 CR クロックの周波数が安定するまでの時間です。

なお、トリミング値設定後、周波安定時間が経過するまでの期間も高速 CR クロックをソースクロックとして使用できます。

内蔵低速 CR

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
クロック周波数	f_{CRL}	-	50	100	150	kHz	

12.4.4 メインPLLの使用条件 (PLLの入カクロックにメインクロックを使用)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間*1 (LOCK UP 時間)	t _{LOCK}	200	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	f _{PLLI}	4	-	16	MHz	
PLL 通倍率	-	13	-	80	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	f _{PLLO}	200	-	320	MHz	
メイン PLL クロック周波数*2	f _{CLKPLL}	-	-	160	MHz	

*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER:クロック』を参照してください。

12.4.5 メインPLLの使用条件 (メインPLLの入カクロックに内蔵高速CR クロックを使用)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
PLL 発振安定待ち時間*1 (LOCK UP 時間)	t _{LOCK}	200	-	-	μs	
PLL 入力クロック周波数	f _{PLLI}	3.8	4	4.2	MHz	
PLL 通倍率	-	50	-	75	通倍	
PLL マクロ発振クロック周波数	f _{PLLO}	190	-	320	MHz	
メイン PLL クロック周波数*2	f _{CLKPLL}	-	-	160	MHz	

*1: PLL の発振が安定するまでの待ち時間

*2: メイン PLL クロック(CLKPLL)の詳細については、『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER:クロック』を参照してください。

<注意事項>

- メインPLLのソースクロックには、必ず周波数トリミングおよび温度トリミングを行った高速CR クロック(CLKHC)を入力してください。

12.4.6 リセット入力規格

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
リセット入力時間	t _{INITX}	INITX	-	500	-	ns	

12.4.7 パワーオンリセットタイミング

($V_{SS} = 0V$, $T_A = -40^{\circ}C \sim +105^{\circ}C$)

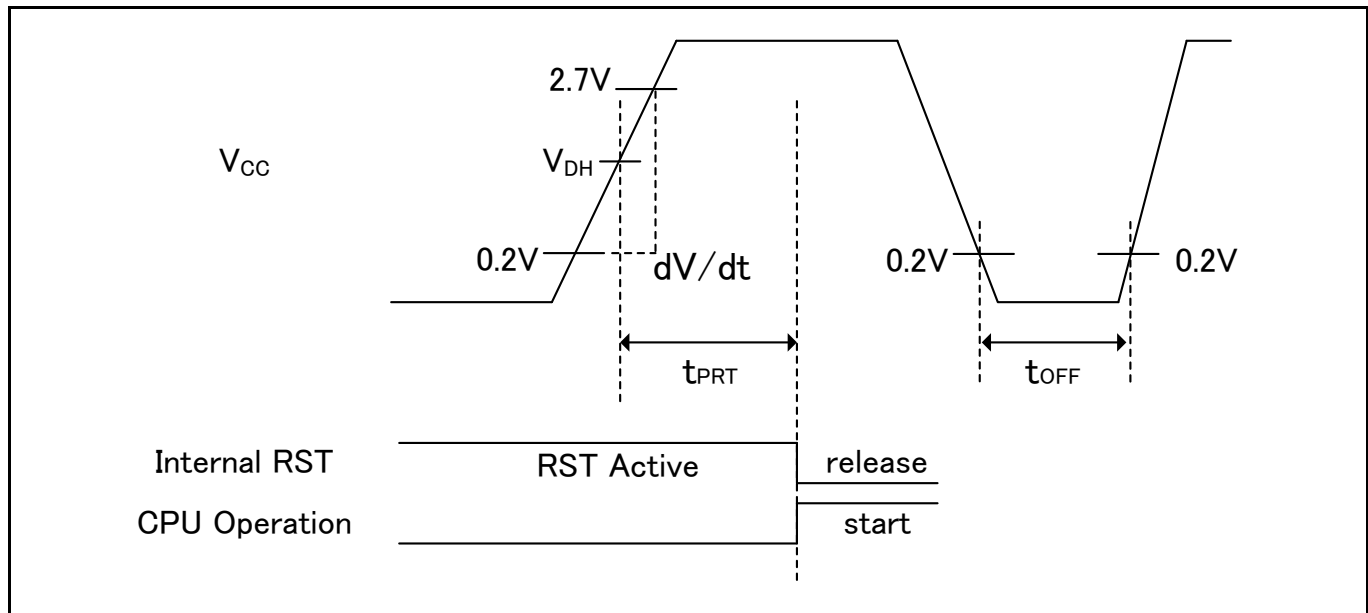
項目	記号	端子名	条件	規格値			単位	備考
				最小	標準	最大		
電源断時間	t_{OFF}	VCC	-	50	-	-	ms	*1
電源立上り速度	dV/dt		$V_{CC}: 0.2V \sim 2.70V$	1.3	-	1000	mV/ μs	*2
パワーオンリセット解除までの時間	t_{PRT}		-	0.33	-	0.60	ms	

*1: V_{CC} は t_{OFF} 最小期間中 0.2V 以下である必要があります。この状態が満たせない場合、誤った初期化が発生する可能性があります。

*2: この dV/dt 規格は cold start ($t_{OFF} > 50ms$) のパワーオン時に適用されます。

<注意事項>

- t_{OFF} は必ず満たす必要があります。もし t_{OFF} が満たせない場合は、起動時および電圧降下発生時に 12.4.6 に従い外部リセット (INTX) を入れて下さい。



用語解説

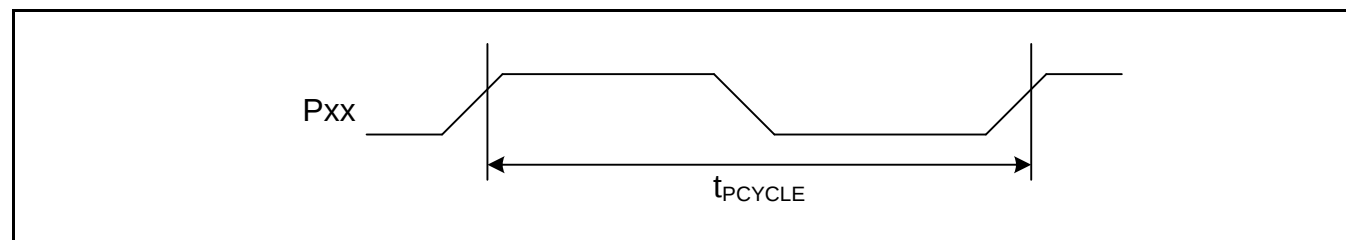
- VDH: 低電圧検出リセット解除電圧。
「12.7.低電圧検出特性」を参照してください。

12.4.8 GPIO 出力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
出力周波数	t_{PCYCLE}	P_{XX}^*	$V_{CC} \geq 4.5 V$	-	50	MHz
			$V_{CC} < 4.5 V$	-	32	MHz

*: GPIO が対象です。



12.4.9 外バスタイミング

外バスクロック出力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

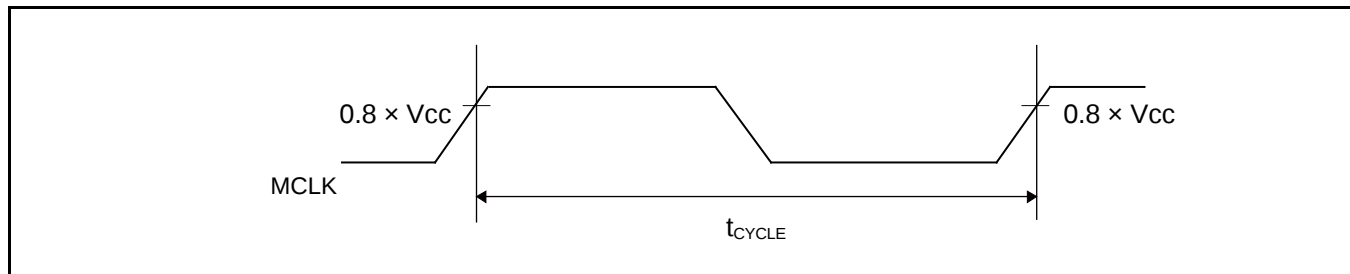
項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
出力周波数	t_{CYCLE}	MCLKOUT*1	$V_{CC} \geq 4.5V$	-	50*2	MHz
			$V_{CC} < 4.5V$	-	32*3	MHz

*1: 外バスクロック出力(MCLKOUT)は HCLK の分周クロックです。

設定の詳細は『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER: 外部バスインタフェース』を参照してください。

*2: AHB バスクロックが 100 MHz を超えるときは 4 分周以上の設定で MCLKOUT を生成してください。

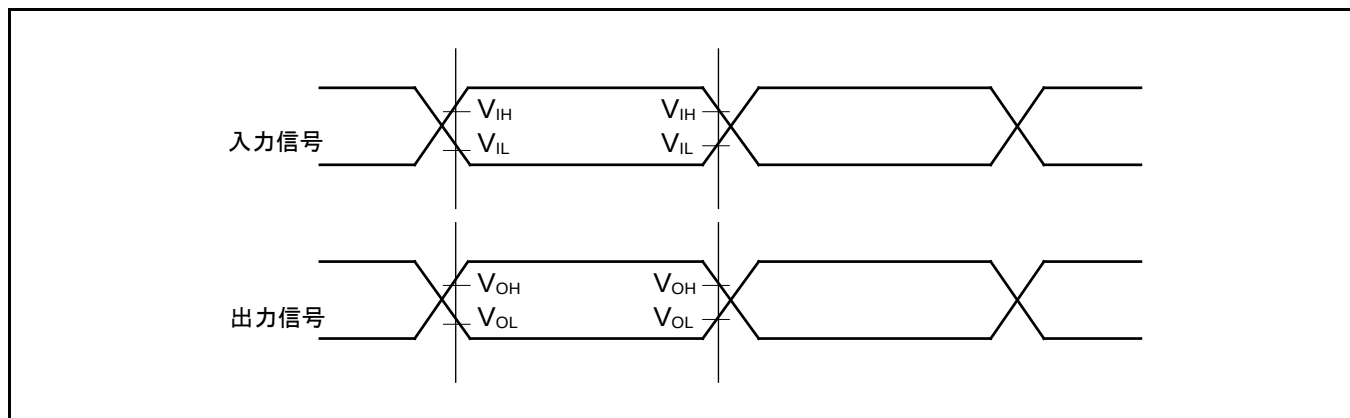
*3: AHB バスクロックが 64 MHz を超えるときは 4 分周以上の設定で MCLKOUT を生成してください。



外バス信号入出力規格

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	規格値	単位	備考
信号入力規格	V_{IH}	-	$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{IL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	
信号出力規格	V_{OH}		$0.8 \times V_{CC}$	V	
	V_{OL}		$0.2 \times V_{CC}$	V	



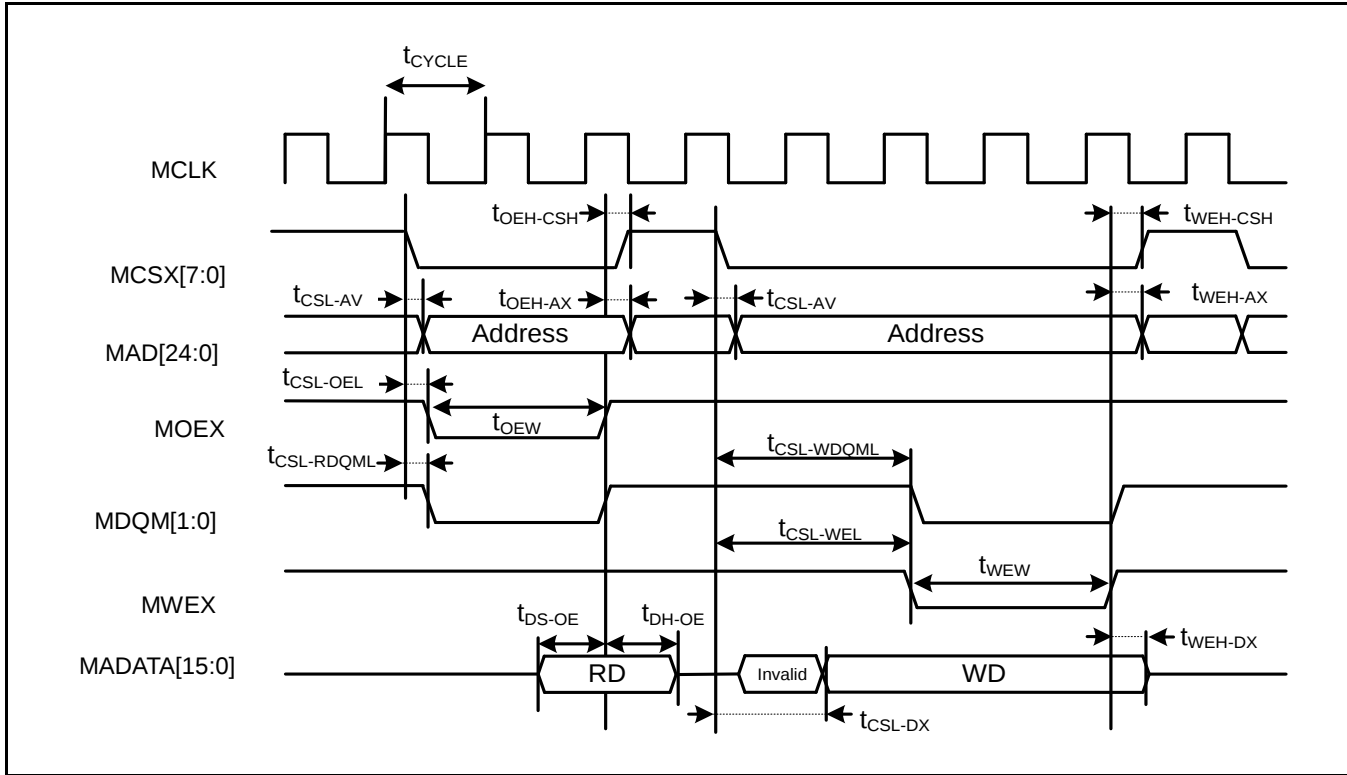
セパレートバスアクセス 非同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
MOEX 最小パルス幅	$t_{OE\bar{W}}$	MOEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 3$	-	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ アドレス 出力遅延時間	$t_{CSL - \bar{A}V}$	MCSX[7:0], MAD[24:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	-9 -12	+9 +12	ns
MOEX $\uparrow \rightarrow$ アドレス ホールド時間	$t_{OE\bar{H} - \bar{A}X}$	MOEX, MAD[24:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ MOEX $\downarrow$ 遅延時間	$t_{CSL - \bar{O}EL}$	MOEX, MCSX[7:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times m - 9$ $MCLK \times m - 12$	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MOEX $\uparrow \rightarrow$ MCSX $\uparrow$ 時間	$t_{OE\bar{H} - \bar{C}SH}$		$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ MDQM $\downarrow$ 遅延時間	$t_{CSL - \bar{R}DQ\bar{M}L}$	MCSX, MDQM[1:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times m - 9$ $MCLK \times m - 12$	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
データセットアップ $\rightarrow$ MOEX $\uparrow$ 時間	$t_{DS - \bar{O}E}$	MOEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	20 38	- -	ns
MOEX $\uparrow \rightarrow$ データホールド時間	$t_{DH - \bar{O}E}$	MOEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	-	ns
MWEX 最小パルス幅	$t_{WE\bar{W}}$	MWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 3$	-	ns
MWEX $\uparrow \rightarrow$ アドレス 出力遅延時間	$t_{WE\bar{H} - \bar{A}X}$	MWEX, MAD[24:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ MWEX $\downarrow$ 遅延時間	$t_{CSL - \bar{W}EL}$	MWEX, MCSX[7:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 9$ $MCLK \times n - 12$	$MCLK \times n + 9$ $MCLK \times n + 12$	ns
MWEX $\uparrow \rightarrow$ MCSX $\uparrow$ 遅延時間	$t_{WE\bar{H} - \bar{C}SH}$		$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ MDQM $\downarrow$ 遅延時間	$t_{CSL - \bar{W}DQ\bar{M}L}$	MCSX, MDQM[1:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 9$ $MCLK \times n - 12$	$MCLK \times n + 9$ $MCLK \times n + 12$	ns
MCSX $\downarrow \rightarrow$ データ出力時間	$t_{CSL - \bar{D}X}$	MCSX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK - 9$ $MCLK - 12$	$MCLK + 9$ $MCLK + 12$	ns
MWEX $\uparrow \rightarrow$ データホールド時間	$t_{WE\bar{H} - \bar{D}X}$	MWEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30pF$ 時 ($m=0 \sim 15$, $n=1 \sim 16$)



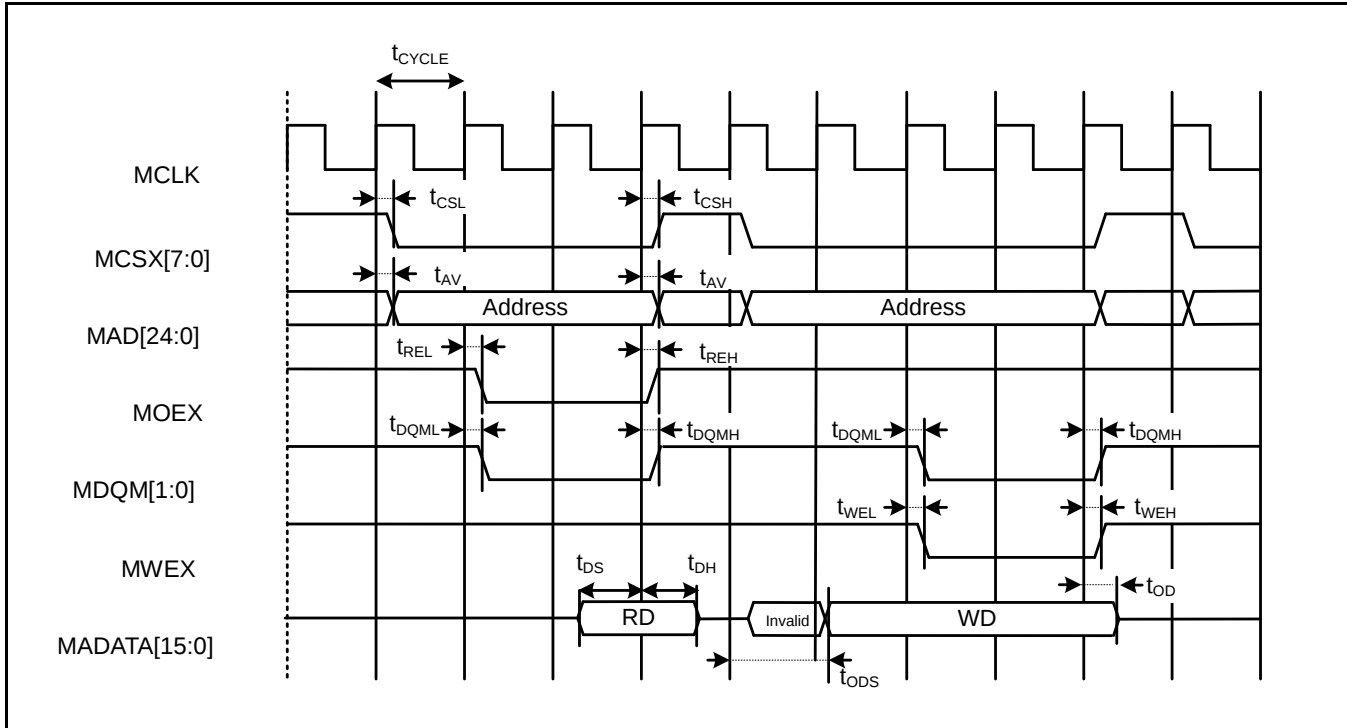
セパレートバスアクセス 同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
アドレス遅延時間	t _{AV}	MCLK, MAD[24:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MCSX 遅延時間	t _{CSL}	MCLK, MCSX[7:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{CSH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MOEX 遅延時間	t _{REL}	MCLK, MOEX	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{REH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
データセットアップ →MCLK ↑ 時間	t _{DS}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	19	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V	37		
MCLK ↑ → データホールド時間	t _{DH}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	0	-	ns
			V _{CC} < 4.5 V			
MWEX 遅延時間	t _{WEL}	MCLK, MWEX	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{WEH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MDQM[1:0] 遅延時間	t _{DQML}	MCLK, MDQM[1:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
	t _{DQMH}		V _{CC} ≥ 4.5 V	1	9	ns
			V _{CC} < 4.5 V		12	
MCLK ↑ → データ出力時間	t _{ODS}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	MCLK+1	MCLK+18	ns
			V _{CC} < 4.5 V		MCLK+24	
MCLK ↑ → データホールド時間	t _{OD}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≥ 4.5 V	1	18	ns
			V _{CC} < 4.5 V		24	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30pF$ 時



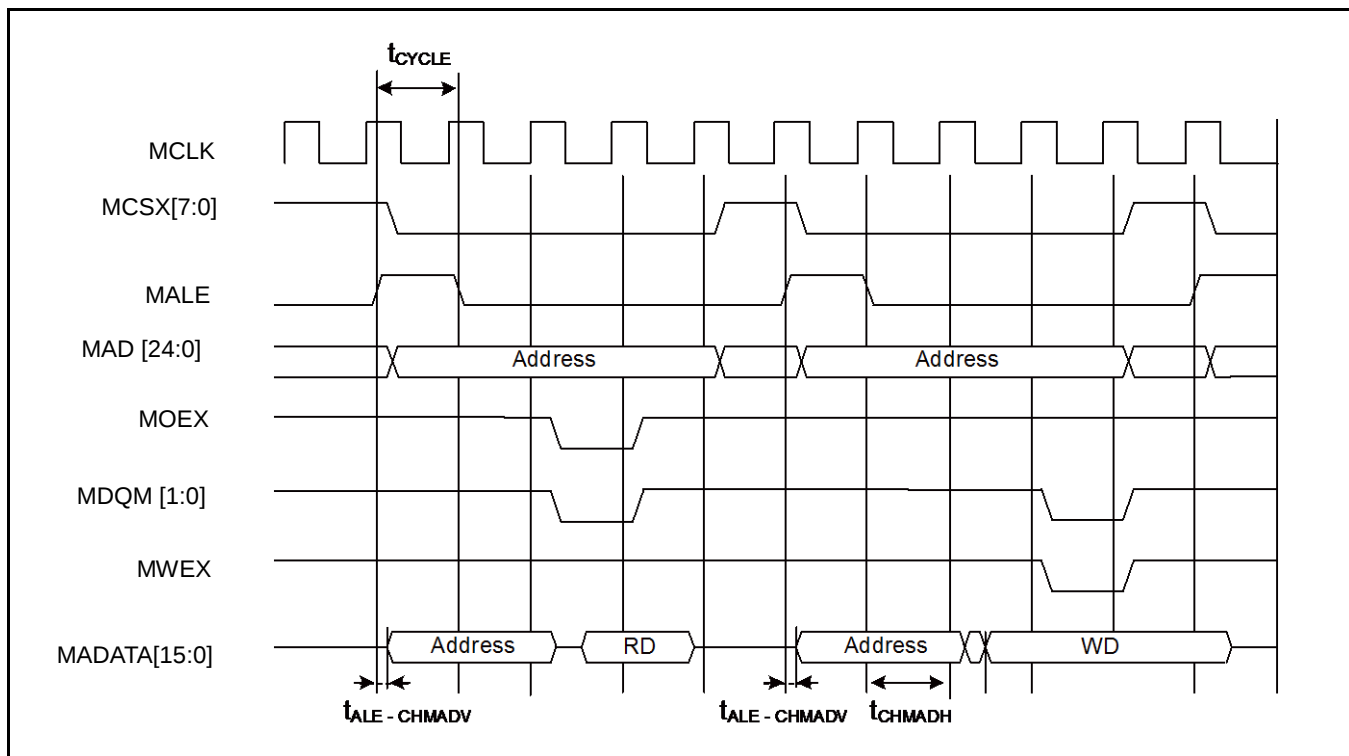
マルチプレクスバスアクセス 非同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
マルチプレクス アドレス遅延時間	tALE-CHMADV	MALE, MADATA[15:0]	VCC≧4.5 V	0	10	ns
			VCC < 4.5 V		20	
マルチプレクス アドレスホールド 時間	tCHMADH		VCC≧4.5 V	MCLK×n+0	MCLK×n+10	ns
			VCC < 4.5 V	MCLK×n+0	MCLK×n+20	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30pF$ 時 ($m=0 \sim 15$, $n=1 \sim 16$)



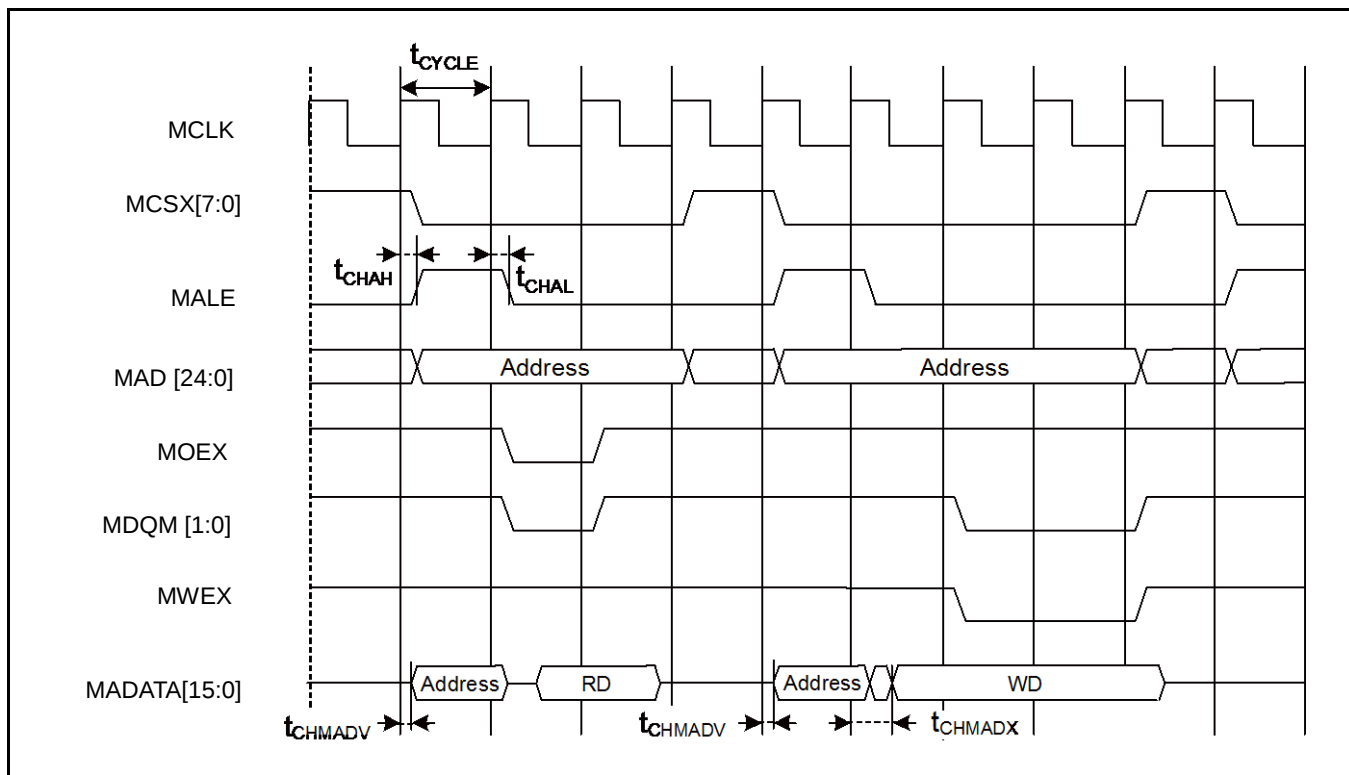
マルチプレクスバスアクセス 同期 SRAM モード

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
MALE 遅延時間	t _{CHAL}	MCLK, ALE	V _{CC} ≧ 4.5 V	1	9	ns	
			V _{CC} < 4.5 V		12	ns	
	t _{CHAH}		V _{CC} ≧ 4.5 V	1	9	ns	
			V _{CC} < 4.5 V		12	ns	
MCLK ↑ → マルチプレクス アドレス遅延時間	t _{CHMADV}	MCLK, MADATA[15:0]	V _{CC} ≧ 4.5 V	1	t _{OD}	ns	
	V _{CC} < 4.5 V						
MCLK ↑ → マルチプレクス データ出力時間	t _{CHMADX}		V _{CC} ≧ 4.5 V	1	t _{OD}	ns	
			V _{CC} < 4.5 V				

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時



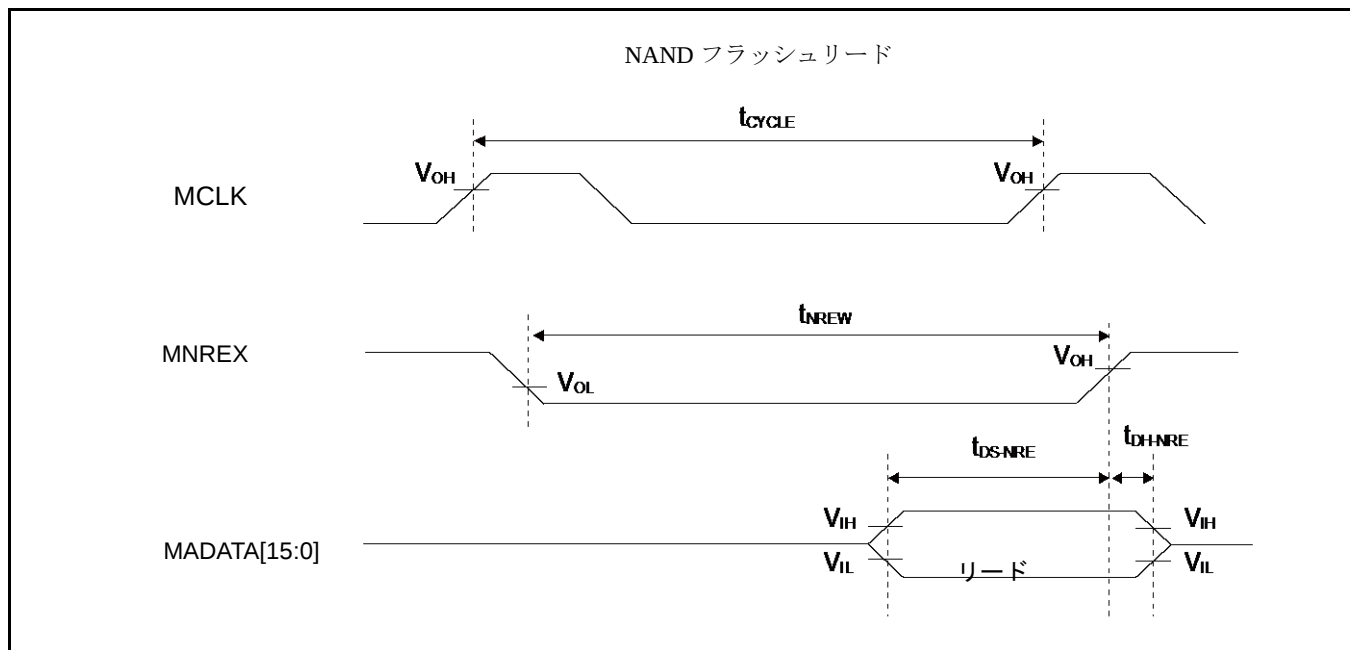
NAND フラッシュモード

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

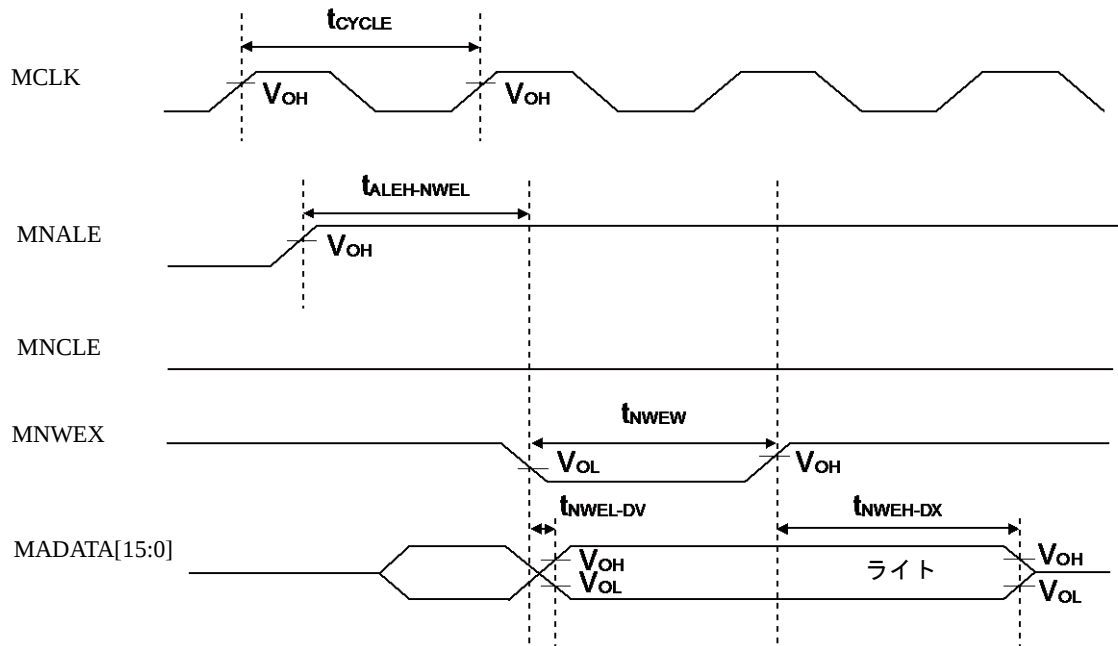
項目	記号	端子名	条件	規格値		単位
				最小	最大	
MNREX 最小パルス幅	t_{NREW}	MNREX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 3$	-	ns
データセットアップ →MNREX ↑時間	t_{DS-NRE}	MNREX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	20 38	- -	ns
MNREX ↑→ データホールド時間	t_{DH-NRE}	MNREX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	-	ns
MNALE ↑→ MNWEX 遅延時間	$t_{ALEH-NWEL}$	MNALE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times m - 9$ $MCLK \times m - 12$	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MNALE ↓→ MNWEX 遅延時間	$t_{ALEL-NWEL}$	MNALE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times m - 9$ $MCLK \times m - 12$	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MNCLE ↑→ MNWEX 遅延時間	$t_{CLEH-NWEL}$	MNCLE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times m - 9$ $MCLK \times m - 12$	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MNWEX ↑→ MNCLE 遅延時間	$t_{NWEH-CLEL}$	MNCLE, MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns
MNWEX 最小パルス幅	t_{NWEW}	MNWEX	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	$MCLK \times n - 3$	-	ns
MNWEX ↓→ データ出力時間	$t_{NWEL-DV}$	MNWEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	-9 -12	+9 +12	ns
MNWEX ↑→ データホールド時間	$t_{NWEH-DX}$	MNWEX, MADATA[15:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	0	$MCLK \times m + 9$ $MCLK \times m + 12$	ns

<注意事項>

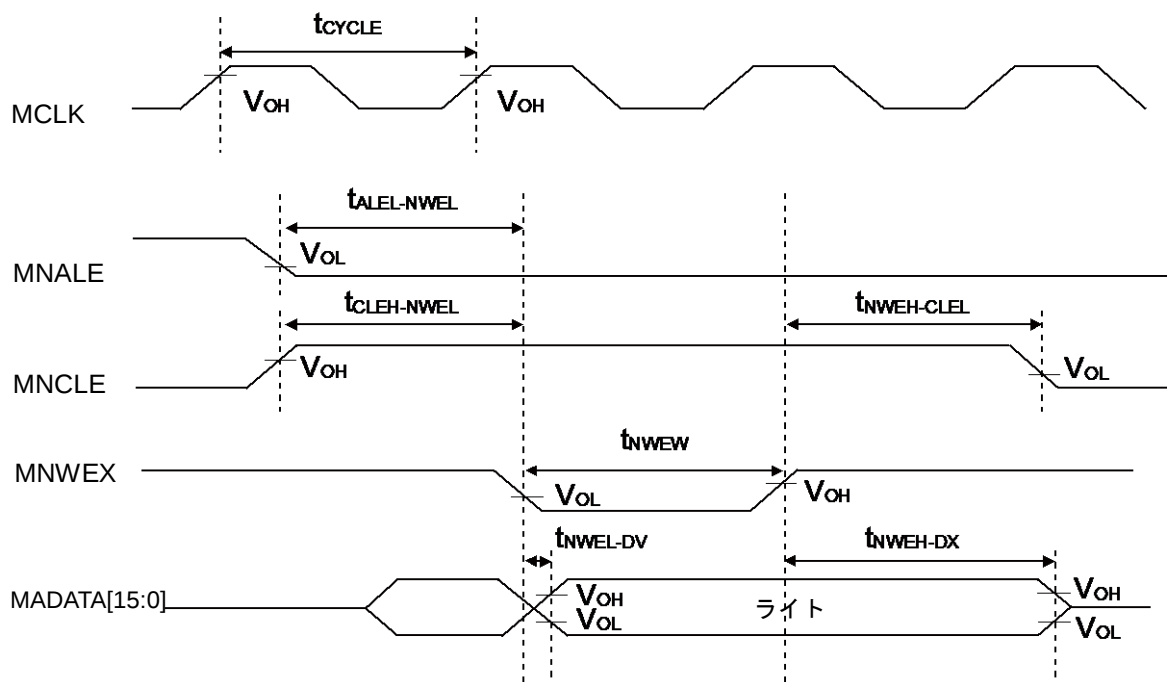
- 外部負荷容量 $C_L = 30 pF$ 時 ($m=0 \sim 15$, $n=1 \sim 16$)



NAND フラッシュアドレスライト



NAND フラッシュコマンドライト

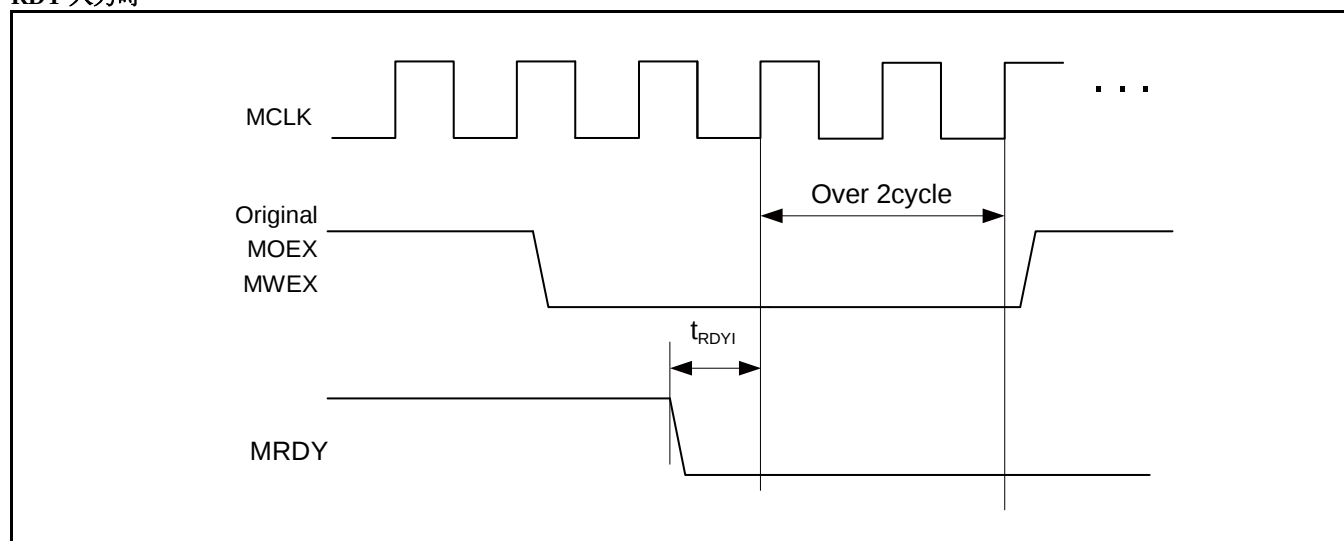


外部 RDY 入力タイミング

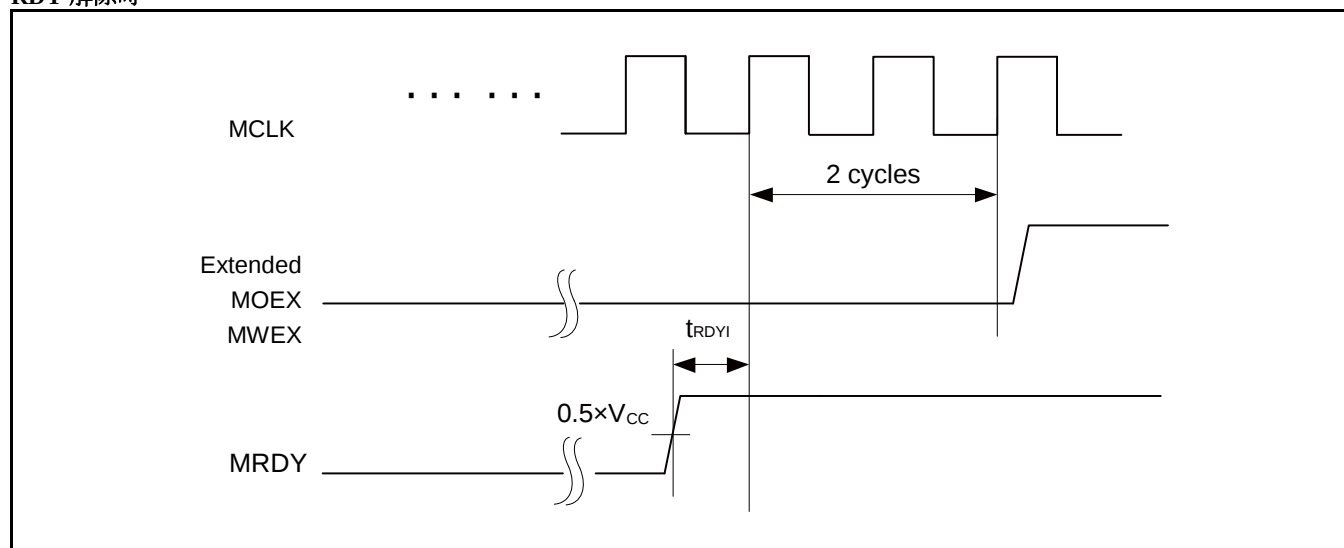
($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
MCLK ↑ MRDY 入力 セットアップ時間	t_{RDYI}	MCLK, MRDY	$V_{CC} \geq 4.5V$	19	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	37			

RDY 入力時



RDY 解除時



SDRAM モード

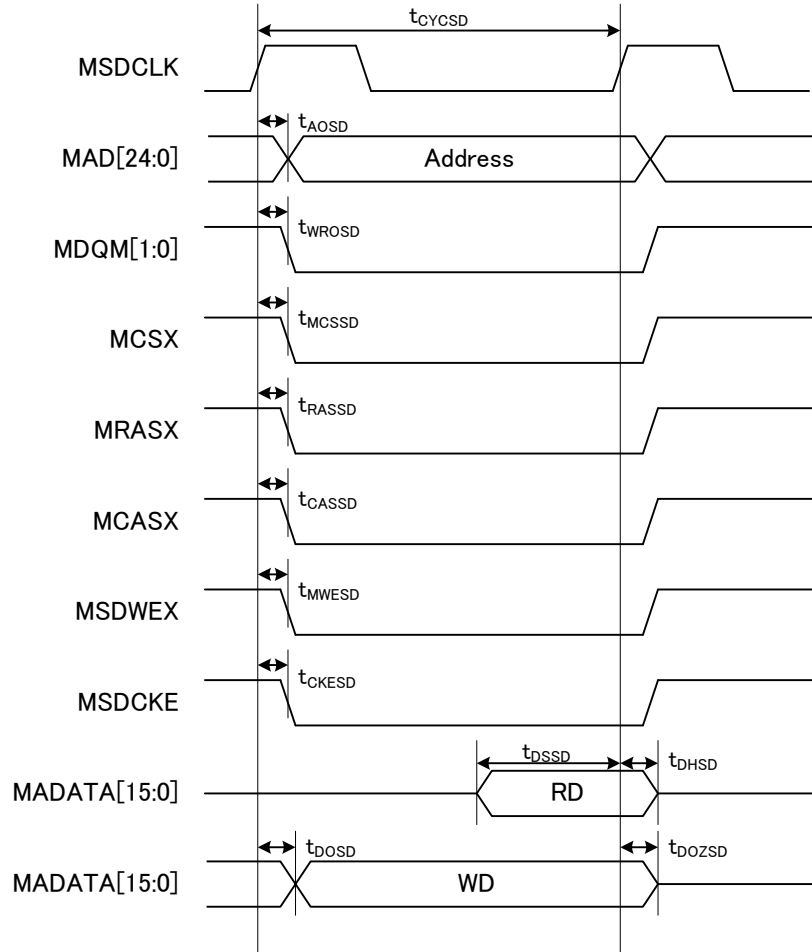
($V_{CC} = 2.7V \sim 3.6V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	規格値		単位
			最小	最大	
出力周波数	tCYCSD	MSDCLK	-	32	MHz
アドレス遅延時間	tAOSD	MSDCLK, MAD[15:0]	2	12	ns
MSDCLK ↑ → データ 出力遅延時間	tDOSD	MSDCLK, MADATA[31:0]	2	12	ns
MSDCLK ↑ → データ 出力 Hi-Z 時間	tDOZSD	MSDCLK, MADATA[31:0]	2	20	ns
MDQM[1:0]遅延時間	twROSD	MSDCLK, MDQM[1:0]	1	12	ns
MCSX 遅延時間	tMCSSD	MSDCLK, MCSX8	2	12	ns
MRASX 遅延時間	trASSD	MSDCLK, MRASX	2	12	ns
MCASX 遅延時間	tCASSD	MSDCLK, MCASX	2	12	ns
MSDWEX 遅延時間	tMWESD	MSDCLK, MSDWEX	2	12	ns
MSDCKE 遅延時間	tCKESD	MSDCLK, MSDCKE	2	12	ns
データセットアップ時間	tDSSD	MSDCLK, MADATA[31:0]	23	-	ns
データホールド時間	tDHSD	MSDCLK, MADATA[31:0]	0	-	ns

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時

SDRAM アクセス

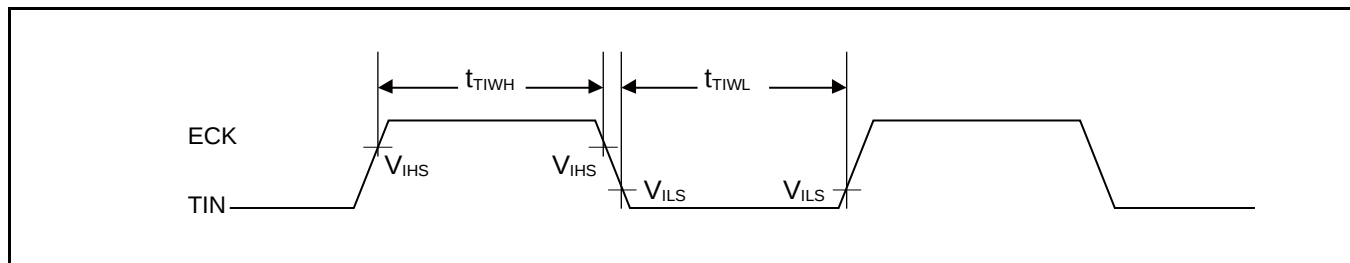


12.4.10 ベースタイマ入力タイミング

タイマ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

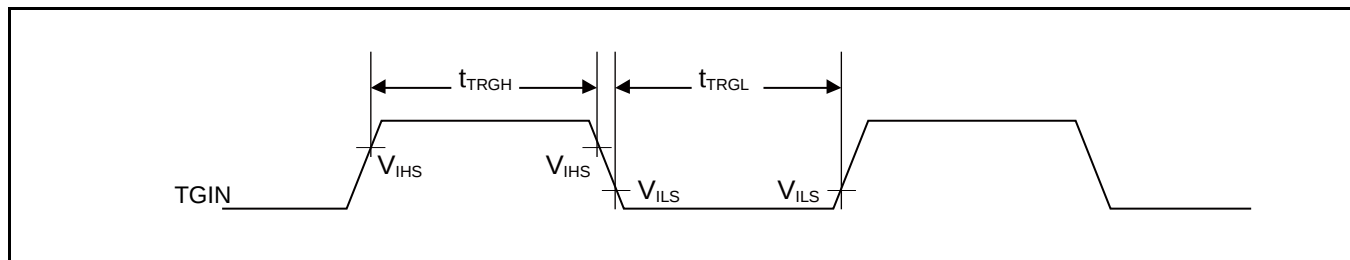
項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TIWH} , t_{TIWL}	TIOAn/TIOBn (ECK, TIN として使用するとき)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	



トリガ入力タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{TRGH} , t_{TRGL}	TIOAn/TIOBn (TGIN として使用するとき)	-	$2t_{CYCP}$	-	ns	



<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
ベースタイマが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。

12.4.11 CSIO タイミング

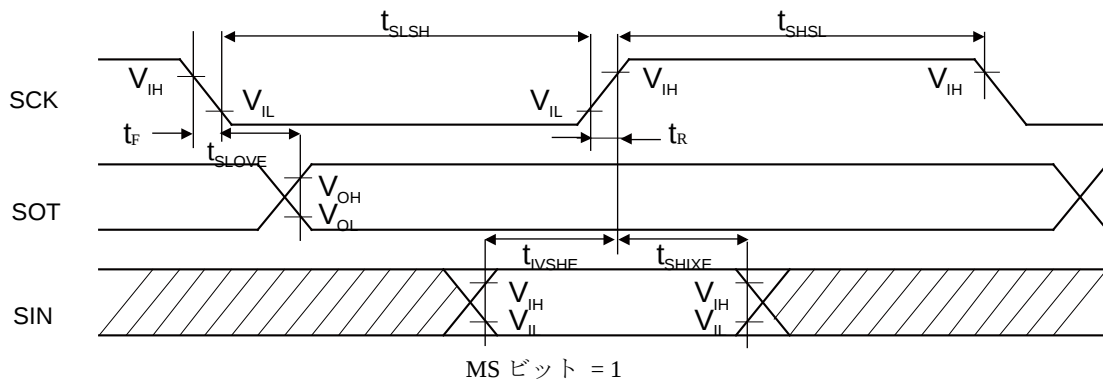
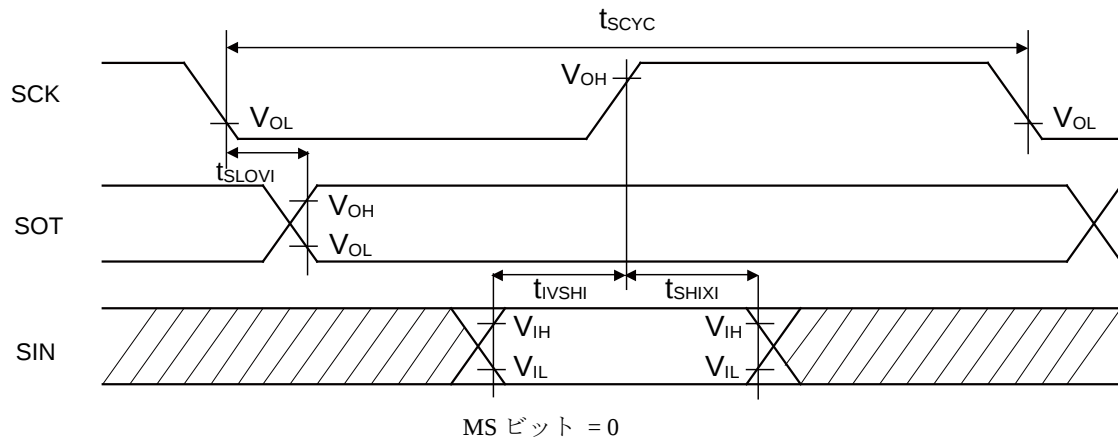
同期シリアル(SPI = 0, SCINV = 0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCK _x	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVI}	SCK _x , SOT _x		-30	+30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHI}	SCK _x , SIN _x		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXI}	SCK _x , SIN _x		0	-	0	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSH}	SCK _x	外部シフト クロック動作	$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCK _x		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVE}	SCK _x , SOT _x		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHE}	SCK _x , SIN _x		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXE}	SCK _x , SIN _x		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCK _x		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCK _x		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCLK_{x_0}, SOT_{x_1} の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時



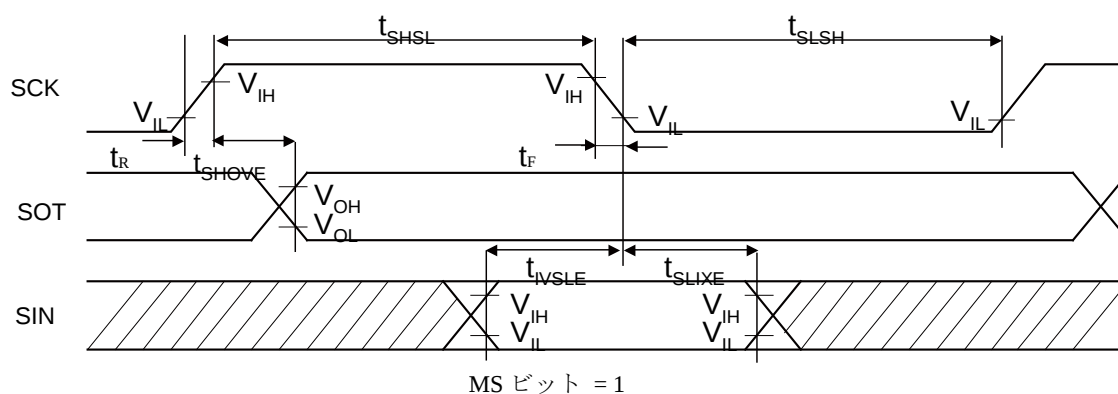
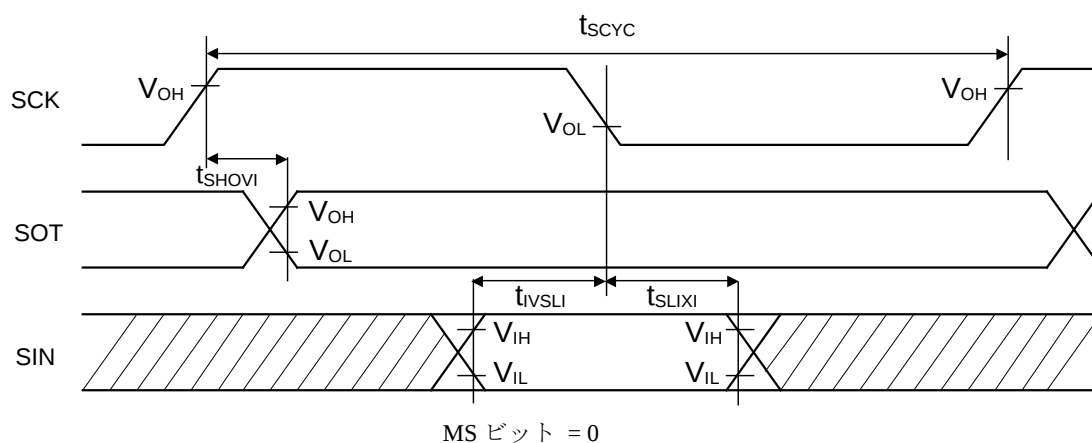
同期シリアル(SPI = 0, SCINV = 1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCKx, SOTx		-30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSLH}	SCKx	外部シフト クロック動作	$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCLKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時



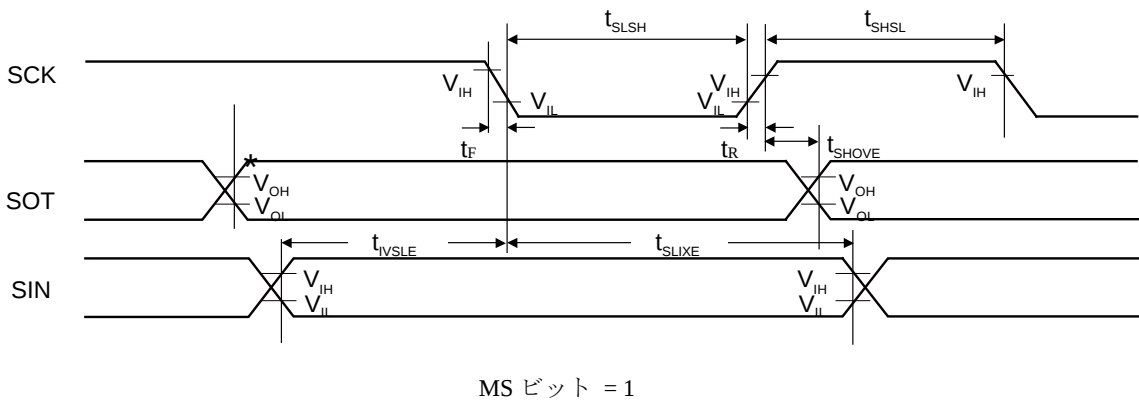
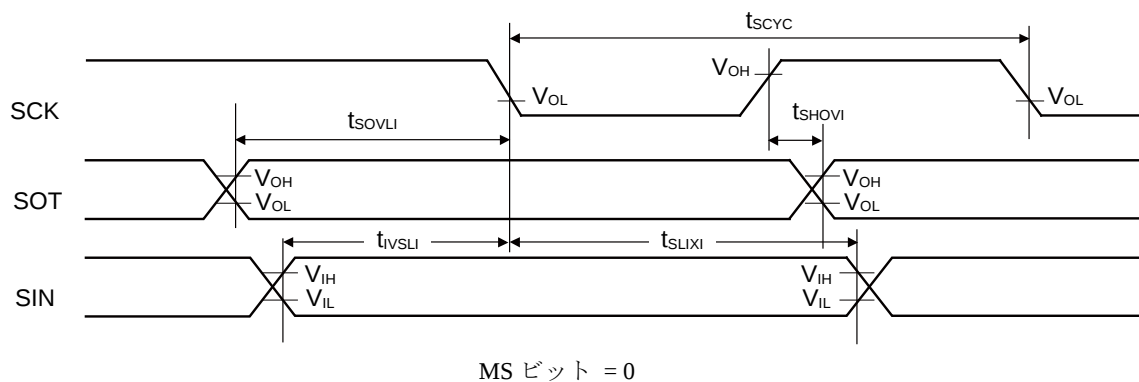
同期シリアル(SPI = 1, SCINV = 0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCKx, SOTx		-30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↓ 遅延時間	t_{SOVLI}	SCKx, SOTx		$2t_{CYCP} - 30$	-	$2t_{CYCP} - 30$	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSH}	SCKx		$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCKx	外部シフト クロック動作	$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCLKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時



*: TDR レジスタにライトすると変化

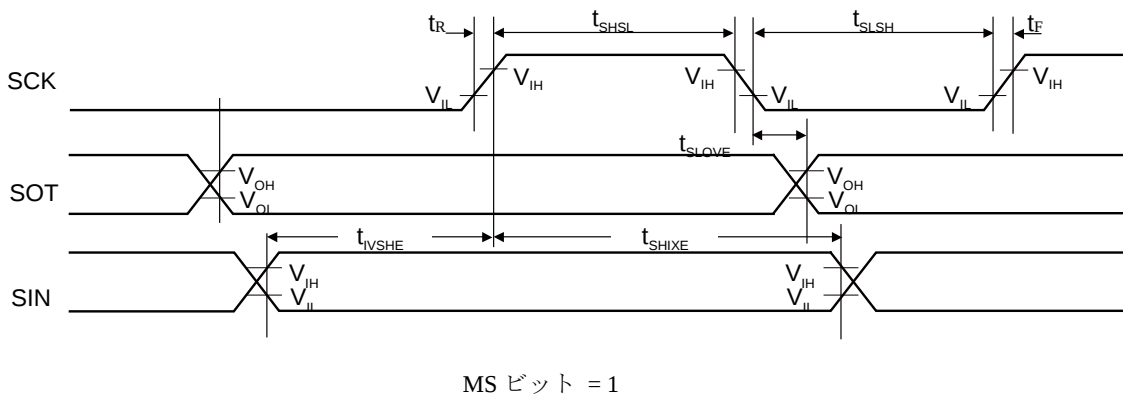
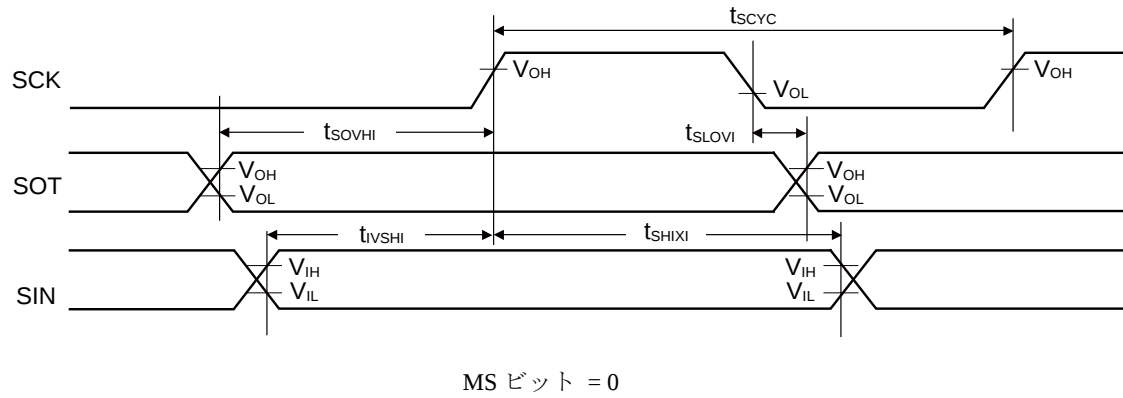
同期シリアル(SPI = 1, SCINV = 1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
ボーレート	-	-	-	-	8	-	8	Mbps
シリアルクロック サイクルタイム	tSCYC	SCKx	内部シフト クロック動作	4tCYCP	-	4tCYCP	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	tSLOVI	SCKx, SOTx		- 30	+ 30	- 20	+ 20	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	tIVSHI	SCKx, SINx		50	-	30	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	tSHIXI	SCKx, SINx		0	-	0	-	ns
SOT → SCK ↑ 遅延時間	tSOVHI	SCKx, SOTx		2tCYCP - 30	-	2tCYCP - 30	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	tSLSH	SCKx		2tCYCP - 10	-	2tCYCP - 10	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	tSHSL	SCKx	外部シフト クロック動作	tCYCP + 10	-	tCYCP + 10	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	tSLOVE	SCKx, SOTx		-	50	-	30	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	tIVSHE	SCKx, SINx		10	-	10	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	tSHIXE	SCKx, SINx		20	-	20	-	ns
SCK 立下り時間	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- tCYCP は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は同リロケート・ポート番号のみの保証です。
例えば SCLKx_0, SOTx_1 の組み合わせは保証外です。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時



同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 0, CSLVL=1)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS ↓ → SCK ↓ セットアップ時間	t _{CSI}	内部 シフト クロック 動作	(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK ↑ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHI}		(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDI}		(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	ns
SCS ↓ → SCK ↓ セットアップ時間	t _{SSE}	外部 シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCK ↑ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDE}		3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCS ↓ → SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	40	-	40	ns
SCS ↑ → SOT 遅延時間	t _{DEE}		0	-	0	-	ns

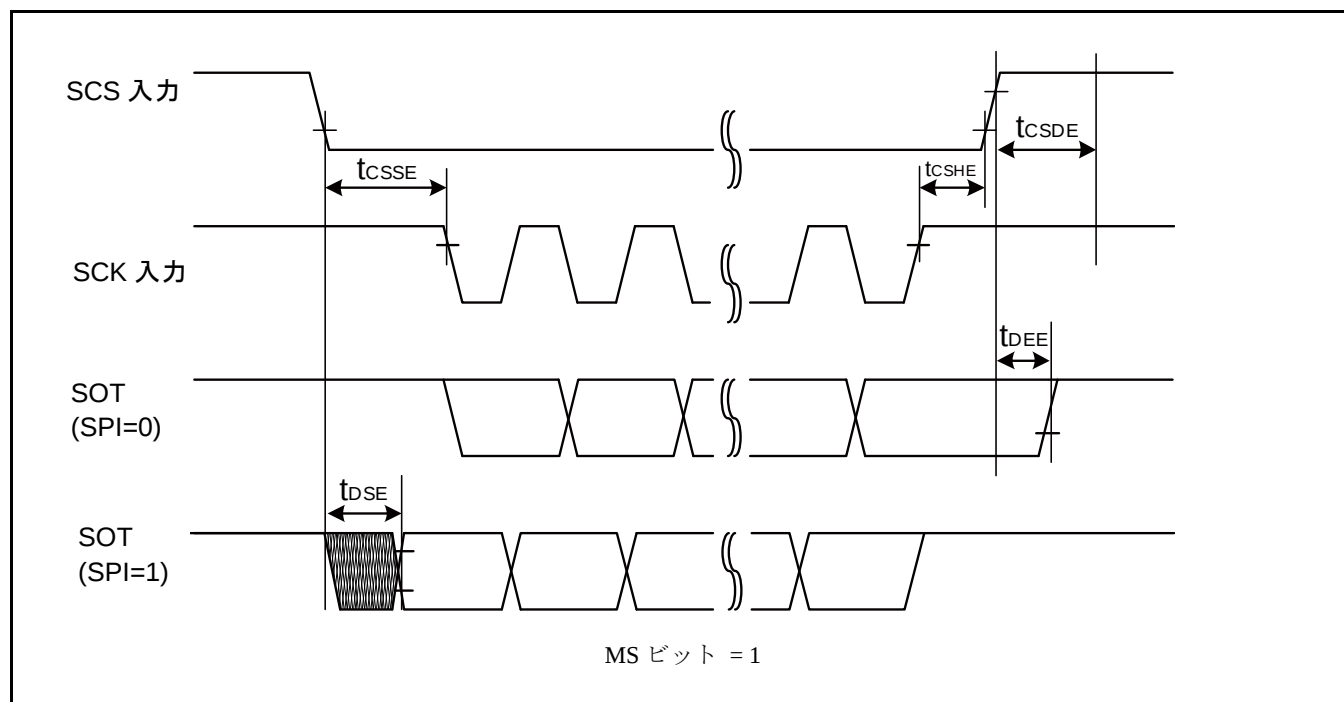
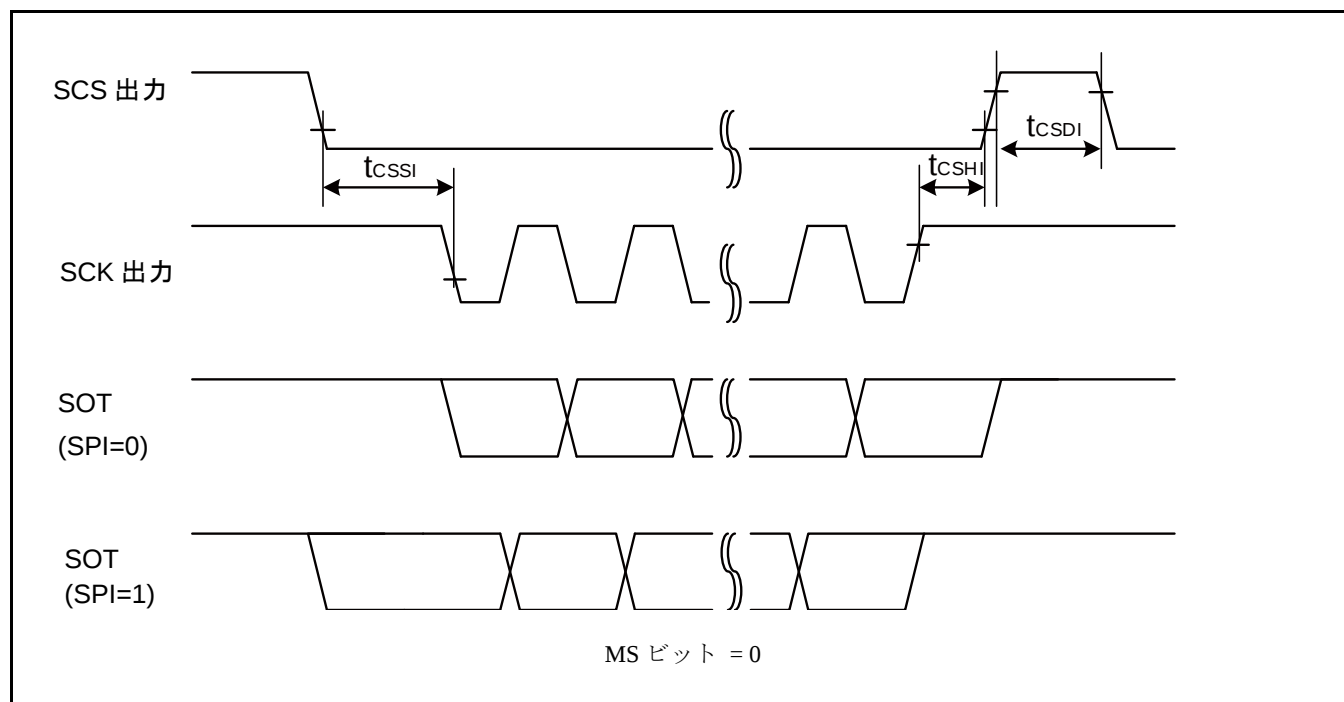
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 1, CSLVL=1)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS ↓ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSI}	内部シフト クロック 動作	(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK ↓ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHI}		(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDI}		(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	ns
SCS ↓ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCK ↓ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDE}		3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCS ↓ → SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	40	-	40	ns
SCS ↑ → SOT 遅延時間	t _{DDE}		0	-	0	-	ns

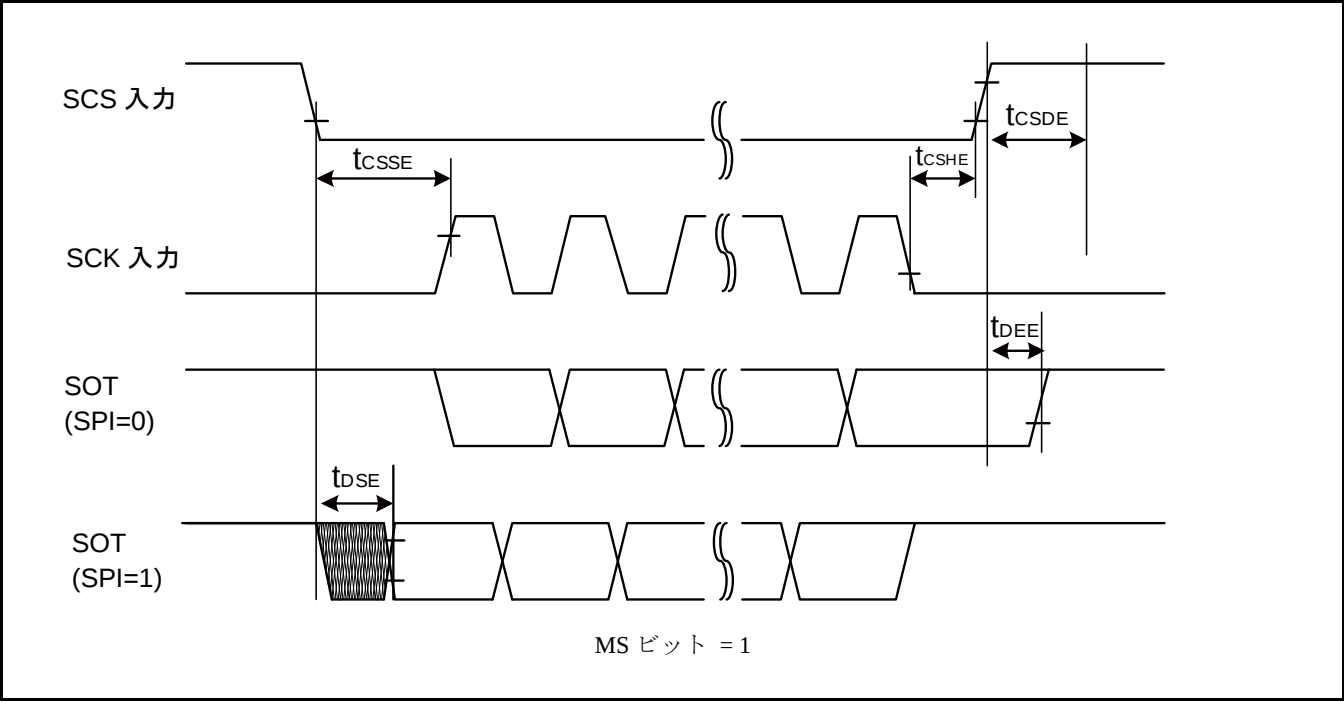
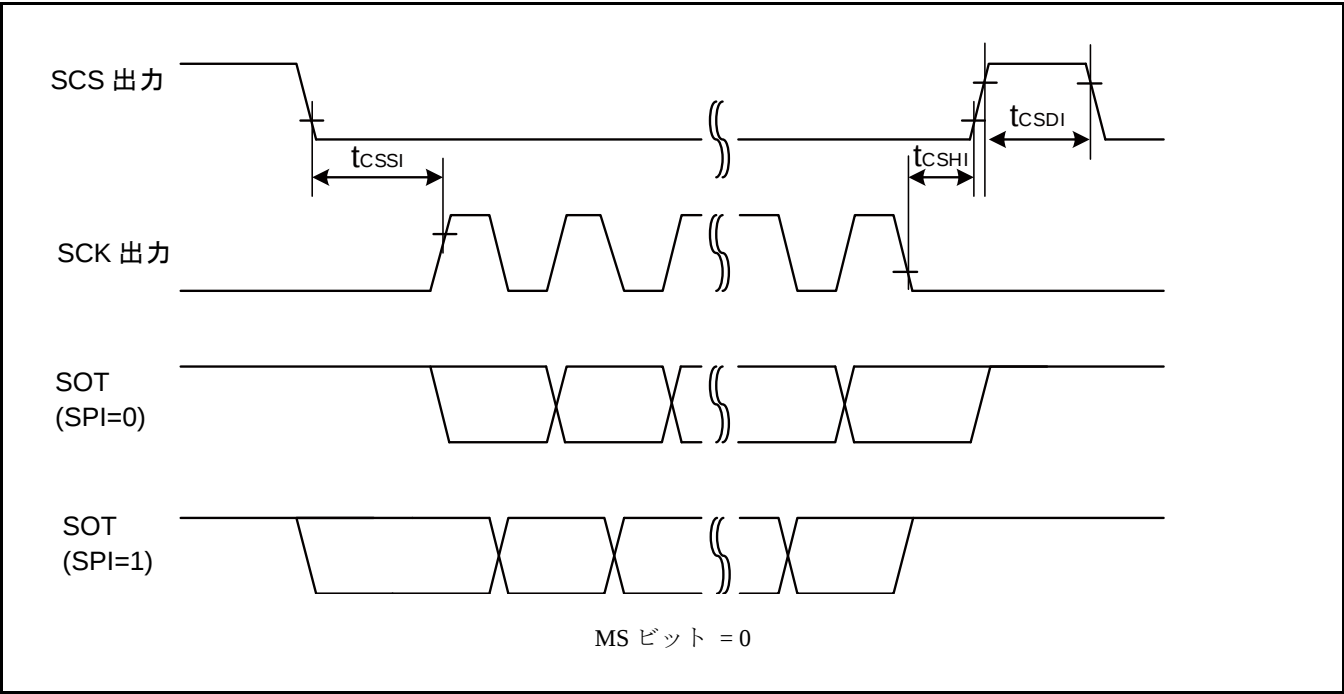
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 0, CSLVL=0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\downarrow$ セットアップ時間	t_{CSSI}	内部シフト クロック 動作	(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t_{CSHI}		(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS ディセレクト時間	t_{CSDI}		(*3)-50 +5 t_{CYCP}	(*3)+50 +5 t_{CYCP}	(*3)-50 +5 t_{CYCP}	(*3)+50 +5 t_{CYCP}	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\downarrow$ セットアップ時間	t_{CSSE}	外部シフト クロック 動作	3 t_{CYCP} +30	-	3 t_{CYCP} +30	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t_{CSHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t_{CSDE}		3 t_{CYCP} +30	-	3 t_{CYCP} +30	-	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{DSE}		-	40	-	40	ns
SCS $\downarrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t_{DEE}		0	-	0	-	ns

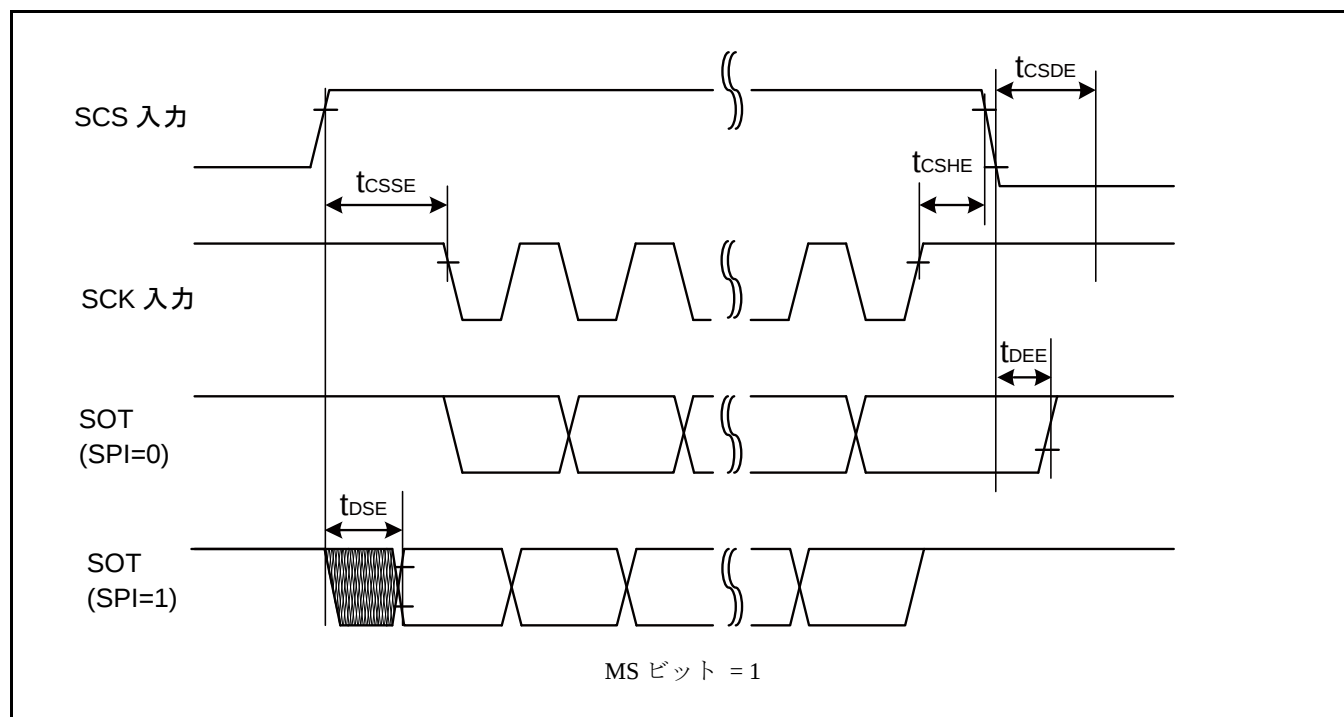
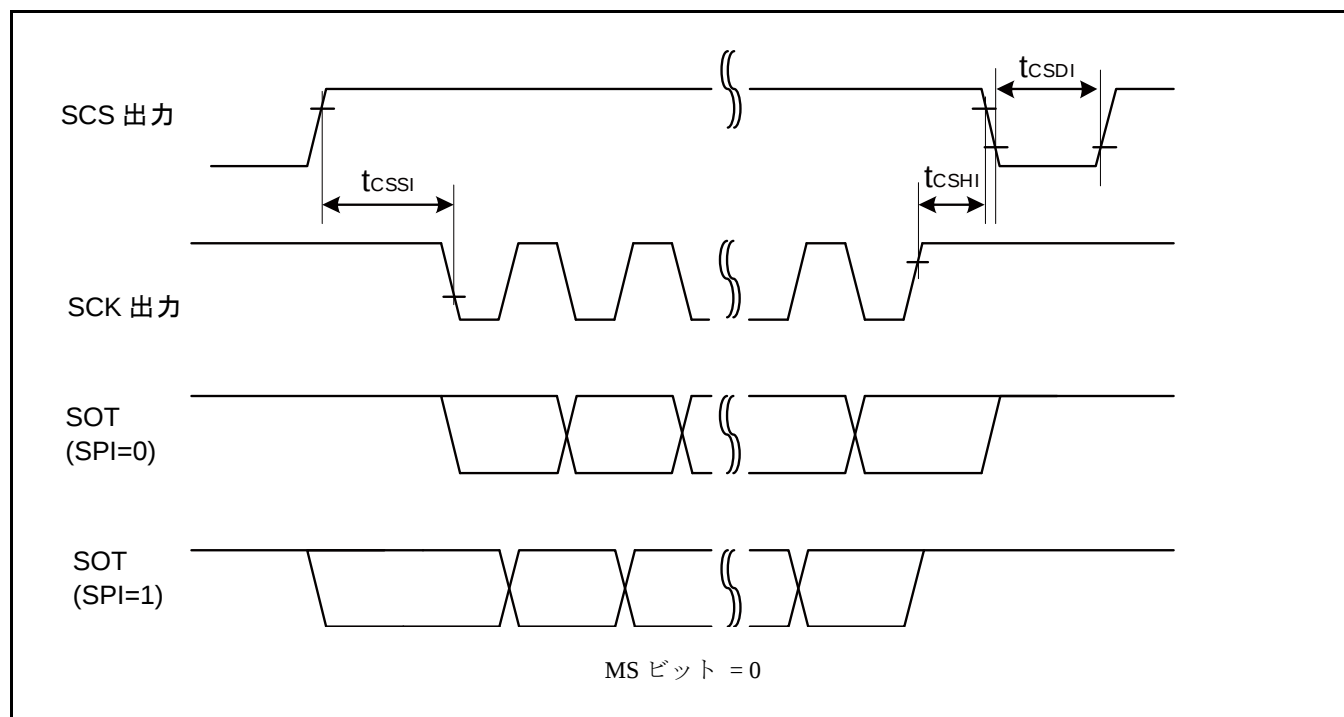
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時



同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 1, CSLVL=0)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	条件	V _{CC} < 4.5 V		V _{CC} ≥ 4.5 V		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS ↑ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSSI}	内部シフト クロック 動作	(*1)-50	(*1)+0	(*1)-50	(*1)+0	ns
SCK ↓ → SCS ↓ ホールド時間	t _{CSHI}		(*2)+0	(*2)+50	(*2)+0	(*2)+50	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDI}		(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	(*3)-50 +5t _{CYCP}	(*3)+50 +5t _{CYCP}	ns
SCS ↑ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCK ↓ → SCS ↓ ホールド時間	t _{CSHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSE}		3t _{CYCP} +30	-	3t _{CYCP} +30	-	ns
SCS ↑ → SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	40	-	40	ns
SCS ↓ → SOT 遅延時間	t _{DDE}		0	-	0	-	ns

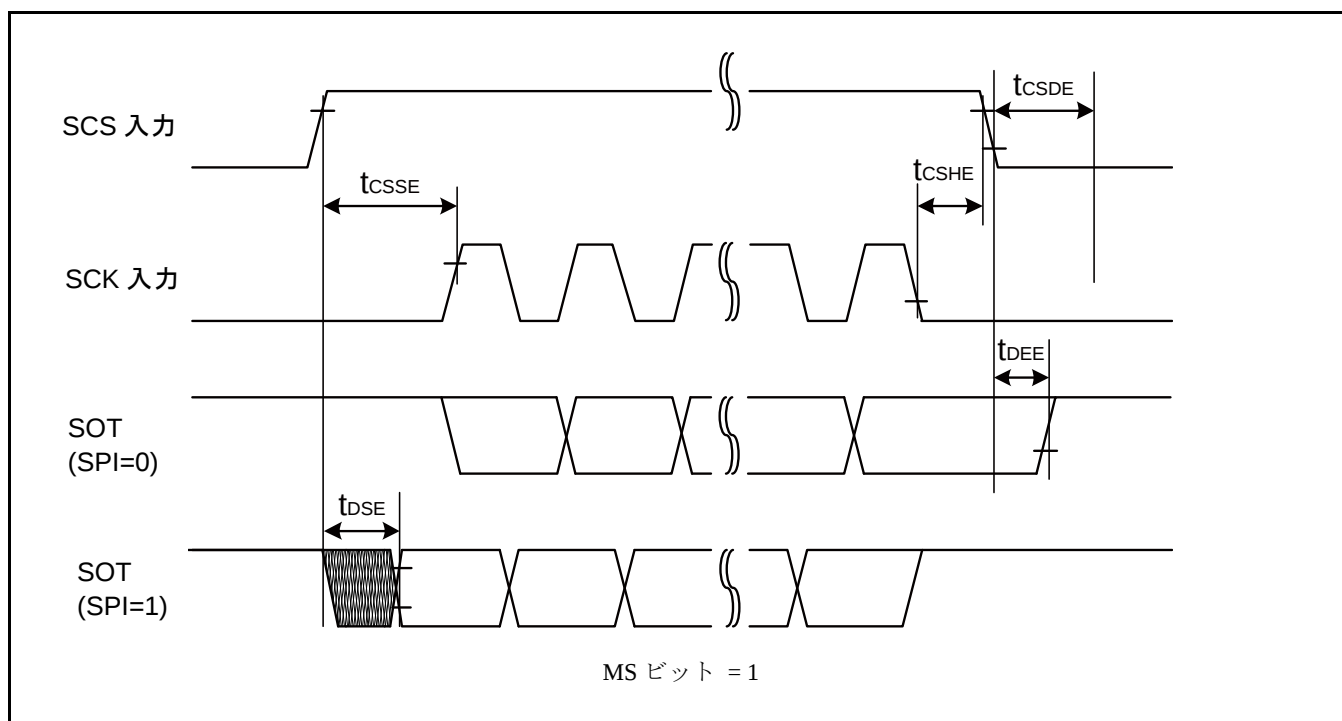
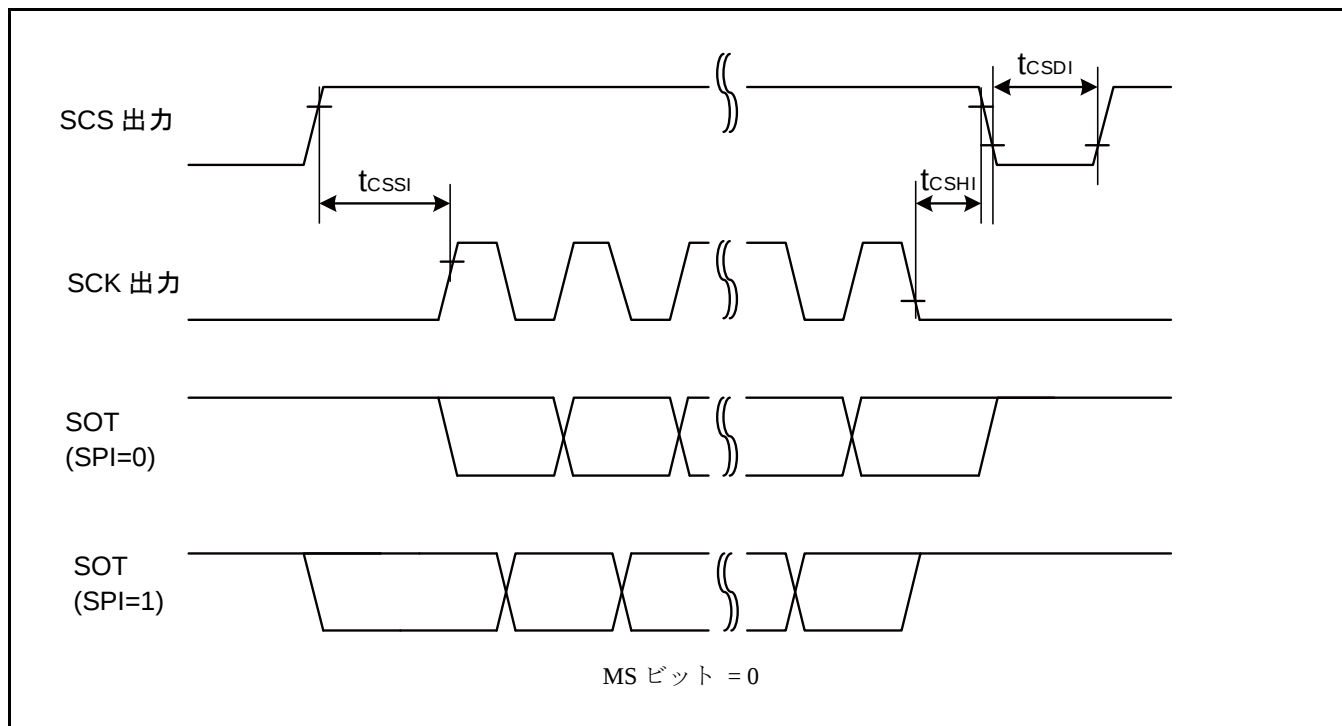
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



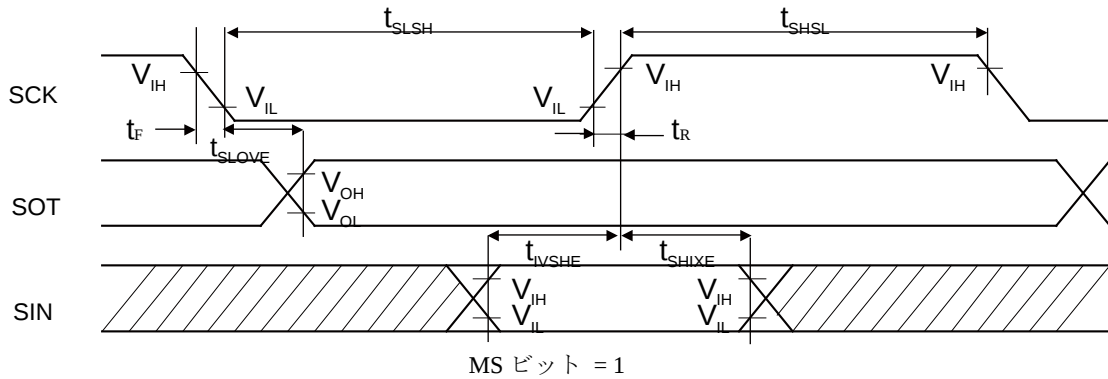
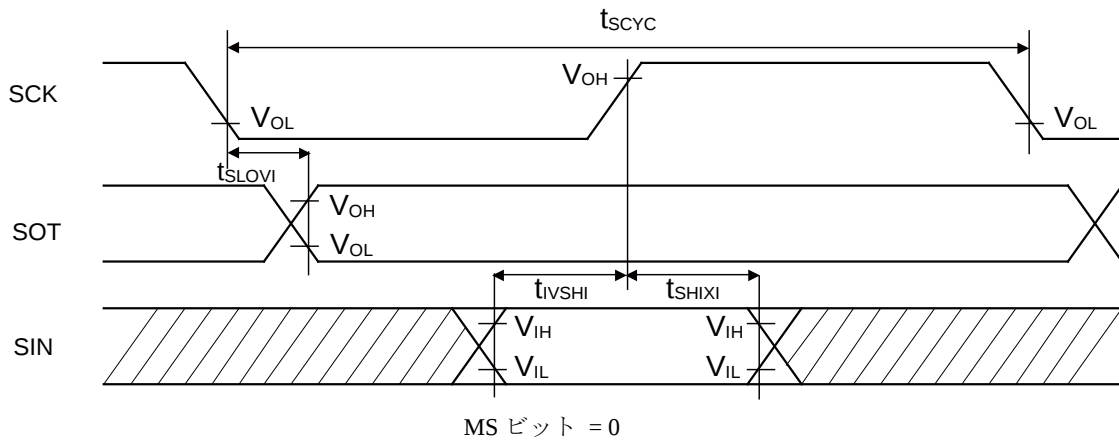
高速同期シリアル(SPI = 0, SCINV = 0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCKx	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVI}	SCKx, SOTx		-10	+10	-10	+10	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHI}	SCKx, SINx		14 12.5*	-	12.5	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXI}	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSH}	SCKx	外部シフト クロック動作	$2t_{CYCP} - 5$	-	$2t_{CYCP} - 5$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCKx		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	t_{SLOVE}	SCKx, SOTx		-	15	-	15	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	t_{IVSHE}	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	t_{SHIXE}	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は以下の端子のみの保証です。
 - ・ チップセレクトなし : SIN4_1, SOT4_1, SCK4_1
 - ・ チップセレクトあり : SIN6_1, SOT6_1, SCK6_1, SCS6_1
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 (* は $C_L = 10 \text{ pF}$ 時)



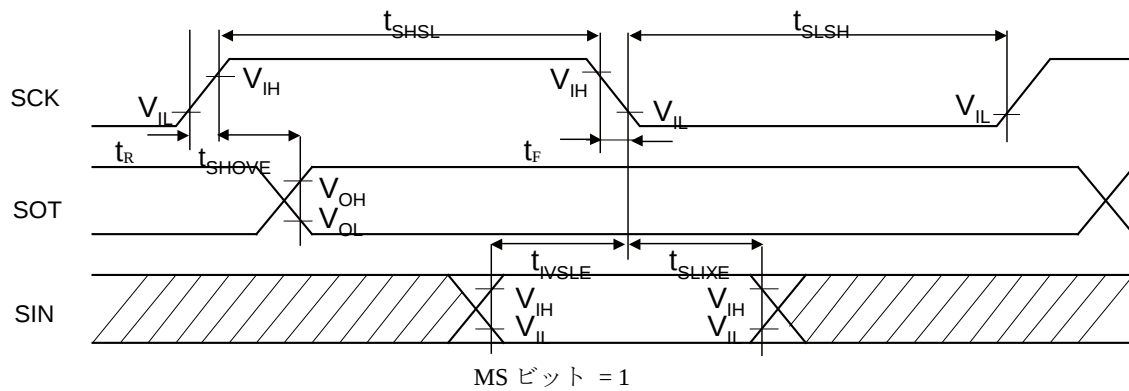
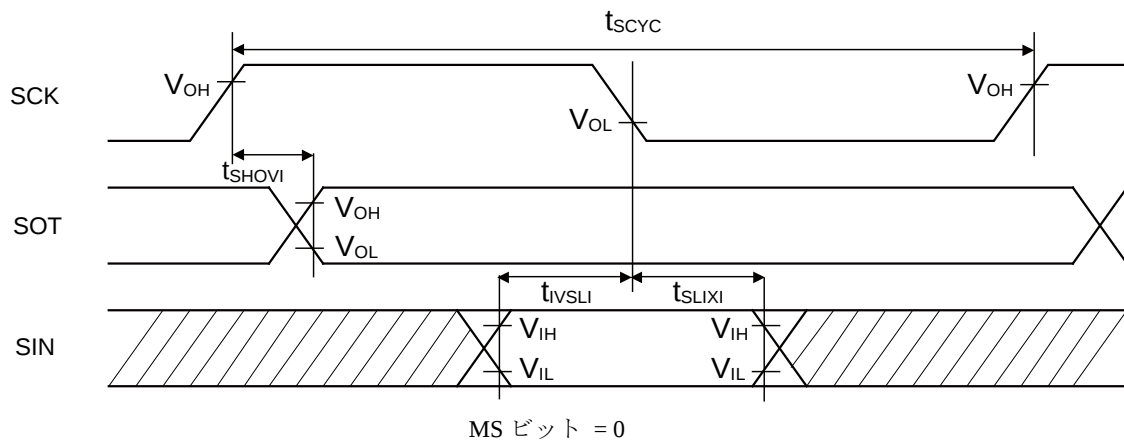
高速同期シリアル(SPI = 0, SCINV = 1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCK _x	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCK _x , SOT _x		-10	+10	-10	+10	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCK _x , SIN _x		14	-	12.5	-	ns
				12.5*				
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSLH}	SCK _x	外部シフト クロック動作	$2t_{CYCP} - 5$	-	$2t_{CYCP} - 5$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCK _x		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCK _x , SOT _x		-	15	-	15	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCK _x		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCK _x		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は以下の端子のみの保証です。
 - ・ チップセレクトなし : SIN4_1, SOT4_1, SCK4_1
 - ・ チップセレクトあり : SIN6_1, SOT6_1, SCK6_1, SCS6_1
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 (* は $C_L = 10 \text{ pF}$ 時)



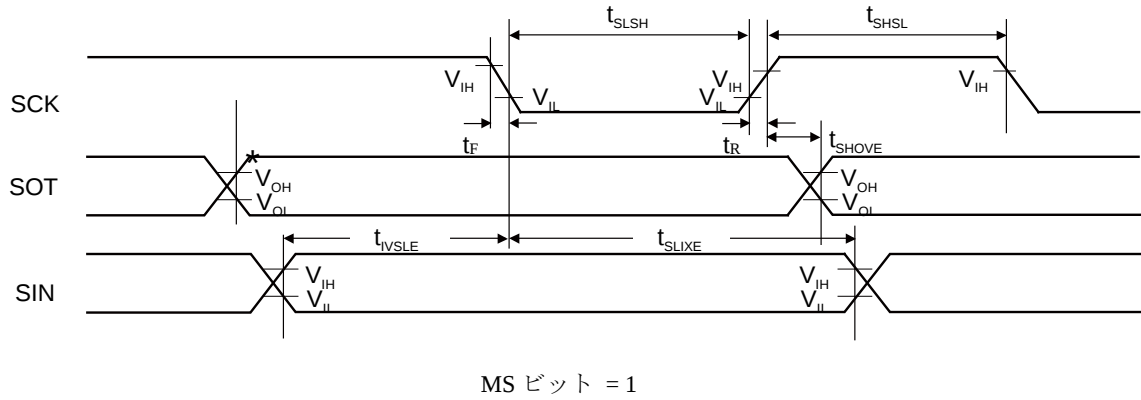
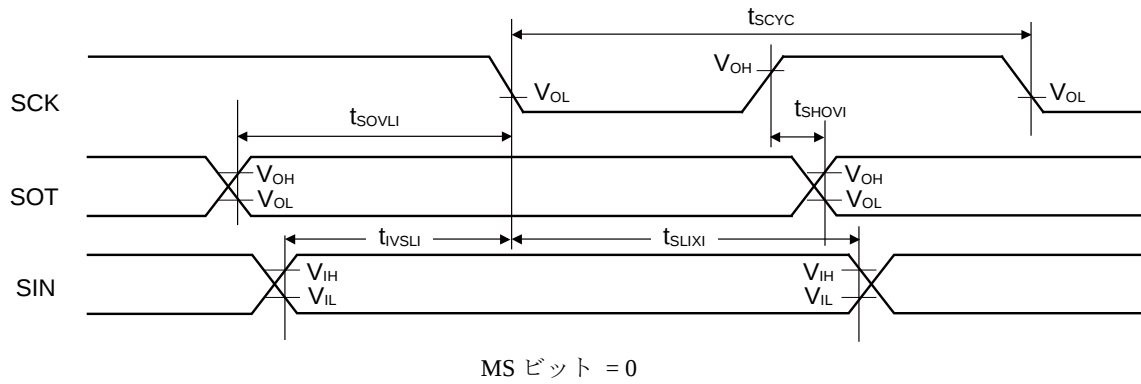
高速同期シリアル(SPI = 1, SCINV = 0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
シリアルクロック サイクルタイム	t_{SCYC}	SCK _x	内部シフト クロック動作	$4t_{CYCP}$	-	$4t_{CYCP}$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVI}	SCK _x , SOT _x		-10	+10	-10	+10	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLI}	SCK _x , SIN _x		14 12.5*	-	12.5	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXI}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
SOT → SCK ↓ 遅延時間	t_{SOVLI}	SCK _x , SOT _x		$2t_{CYCP} - 10$	-	$2t_{CYCP} - 10$	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	t_{LSLH}	SCK _x	外部シフト クロック動作	$2t_{CYCP} - 5$	-	$2t_{CYCP} - 5$	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	t_{HSL}	SCK _x		$t_{CYCP} + 10$	-	$t_{CYCP} + 10$	-	ns
SCK ↑ → SOT 遅延時間	t_{SHOVE}	SCK _x , SOT _x		-	15	-	15	ns
SIN → SCK ↓ セットアップ時間	t_{IVSLE}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
SCK ↓ → SIN ホールド時間	t_{SLIXE}	SCK _x , SIN _x		5	-	5	-	ns
SCK 立下り時間	t_F	SCK _x		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	t_R	SCK _x		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は以下のリロケート・ポート番号組み合わせのみの保証です。
 - ・ チップセレクトなし : SIN4_1, SOT4_1, SCK4_1
 - ・ チップセレクトあり : SIN6_1, SOT6_1, SCK6_1, SCS6_1
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 (* は $C_L = 10 \text{ pF}$ 時)



*: TDR レジスタにライトすると変化

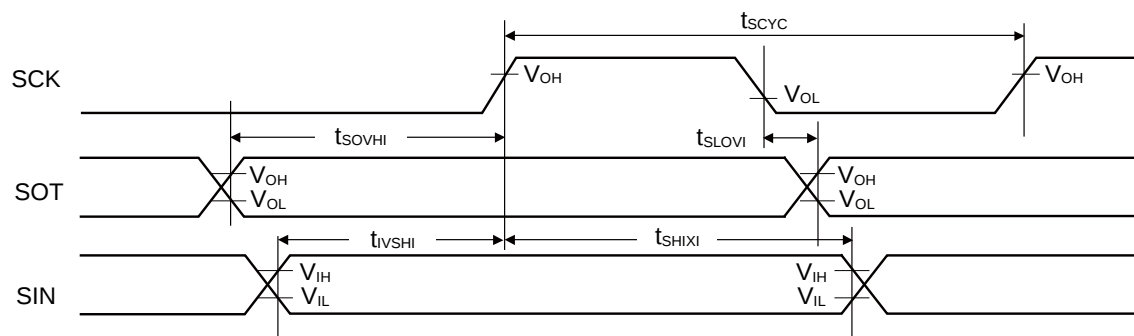
高速同期シリアル(SPI = 1, SCINV = 1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

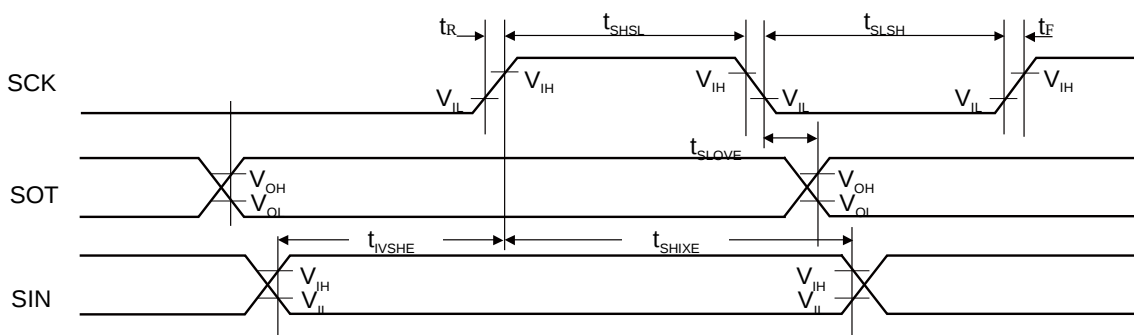
項目	記号	端子名	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
				最小	最大	最小	最大	
シリアルクロック サイクルタイム	tSCYC	SCKx	内部シフト クロック動作	4tCYCP	-	4tCYCP	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	tSLOVI	SCKx, SOTx		-10	+10	-10	+10	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	tIVSHI	SCKx, SINx		14 12.5*	-	12.5	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	tSHIXI	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
SOT → SCK ↑ 遅延時間	tSOVHI	SCKx, SOTx		2tCYCP -10	-	2tCYCP -10	-	ns
シリアルクロック L パルス幅	tSLSH	SCKx	外部シフト クロック動作	2tCYCP -5	-	2tCYCP -5	-	ns
シリアルクロック H パルス幅	tSHSL	SCKx		tCYCP + 10	-	tCYCP + 10	-	ns
SCK ↓ → SOT 遅延時間	tSLOVE	SCKx, SOTx		-	15	-	15	ns
SIN → SCK ↑ セットアップ時間	tIVSHE	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
SCK ↑ → SIN ホールド時間	tSHIXE	SCKx, SINx		5	-	5	-	ns
SCK 立下り時間	tF	SCKx		-	5	-	5	ns
SCK 立上り時間	tR	SCKx		-	5	-	5	ns

<注意事項>

- CLK 同期モード時の交流規格です。
- tCYCP は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- 本規格は以下のリロケート・ポート番号組み合わせのみの保証です。
 - ・ チップセレクトなし : SIN4_1, SOT4_1, SCK4_1
 - ・ チップセレクトあり : SIN6_1, SOT6_1, SCK6_1, SCS6_1
- 外部負荷容量 $C_L = 30 \text{ pF}$ 時 (* は $C_L = 10 \text{ pF}$ 時)



MS ビット = 0



MS ビット = 1

高速同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 0, CSLVL=1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS ↓ → SCK ↓ セットアップ時間	t _{CSI}	内部シフト クロック 動作	(*1)-20	(*1)+0	(*1)-20	(*1)+0	ns
SCK ↑ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHI}		(*2)+0	(*2)+20	(*2)+0	(*2)+20	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDI}		(*3)-20 +5t _{CYCP}	(*3)+20 +5t _{CYCP}	(*3)-20 +5t _{CYCP}	(*3)+20 +5t _{CYCP}	ns
SCS ↓ → SCK ↓ セットアップ時間	t _{CSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCK ↑ → SCS ↑ ホールド時間	t _{SHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{SDE}		3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCS ↓ → SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	25	-	25	ns
SCS ↑ → SOT 遅延時間	t _{DEE}		0	-	0	-	ns

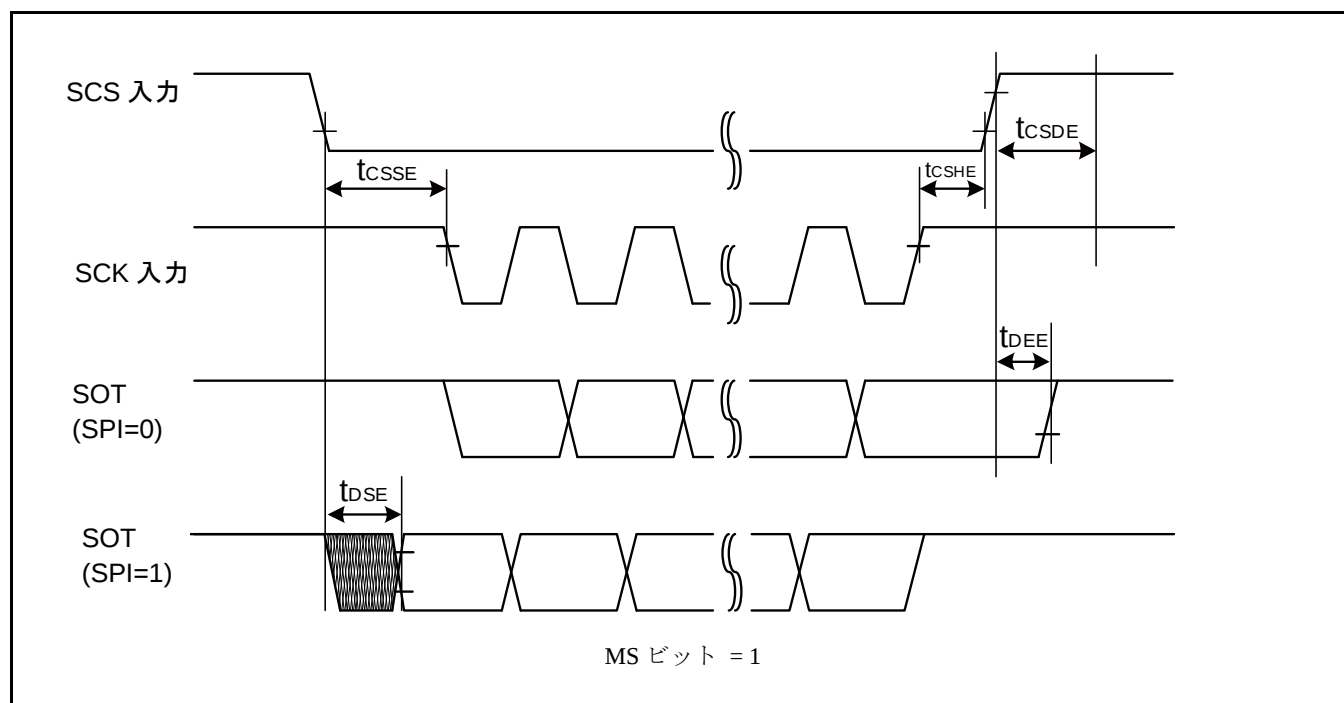
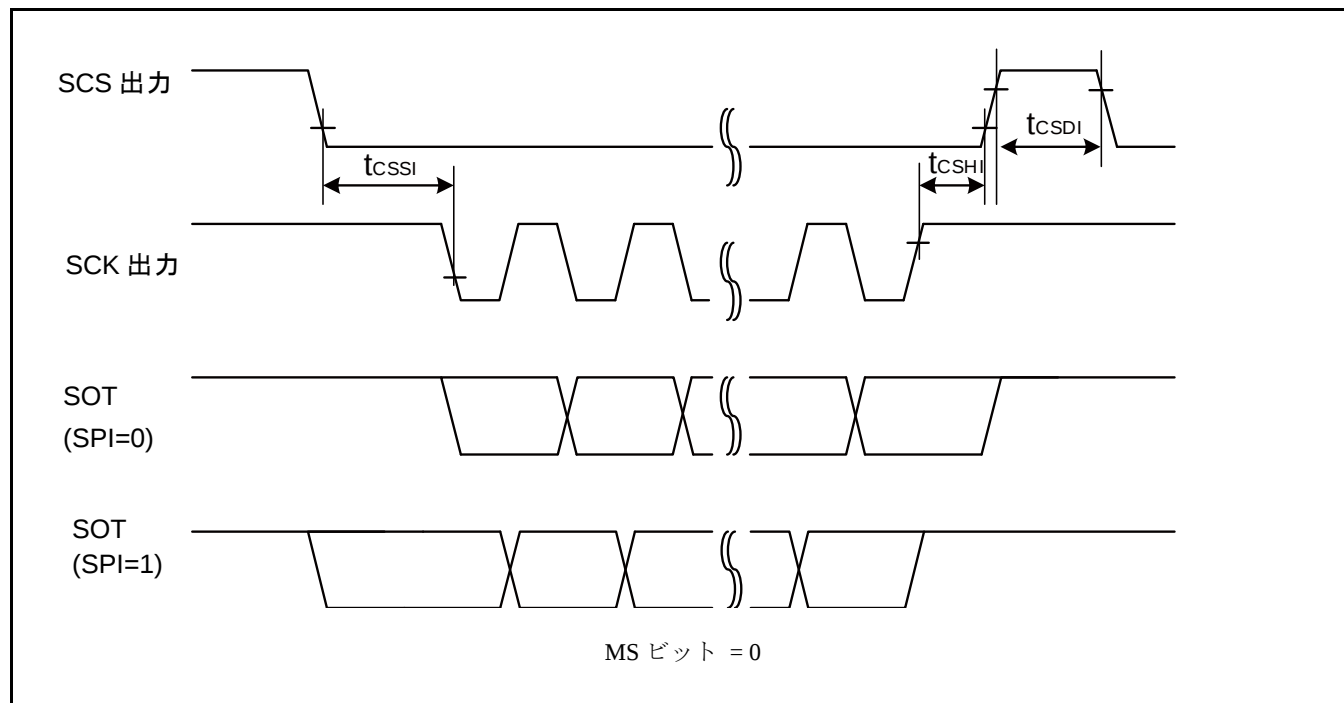
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



高速同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 1, CSLVL=1)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS ↓ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSSI}	内部シフト クロック 動作	(*1)-20	(*1)+0	(*1)-20	(*1)+0	ns
SCK ↓ → SCS ↑ ホールド時間	t _{CSHI}		(*2)+0	(*2)+20	(*2)+0	(*2)+20	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDI}		(*3)-20 +5t _{CYCP}	(*3)+20 +5t _{CYCP}	(*3)-20 +5t _{CYCP}	(*3)+20 +5t _{CYCP}	ns
SCS ↓ → SCK ↑ セットアップ時間	t _{CSSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCK ↓ → SCS ↑ ホールド時間	t _{CSHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDE}		3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCS ↓ → SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	25	-	25	ns
SCS ↑ → SOT 遅延時間	t _{DDE}		0	-	0	-	ns

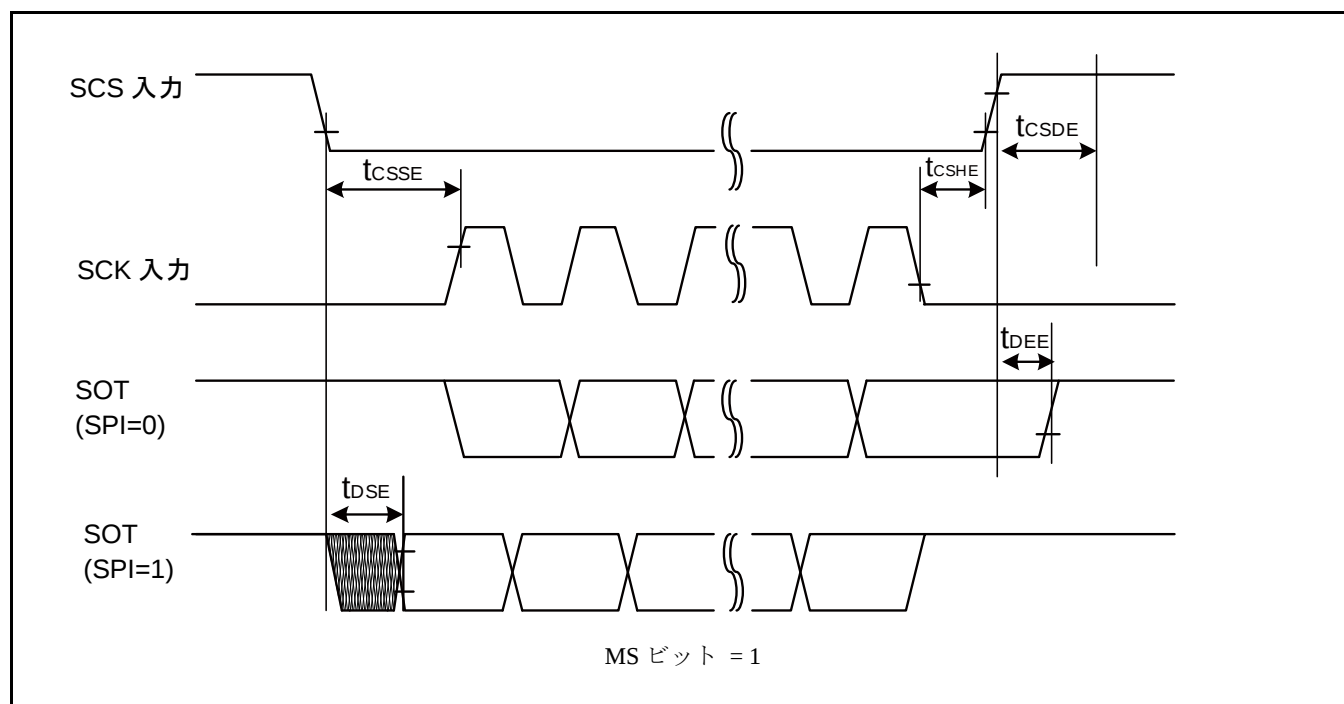
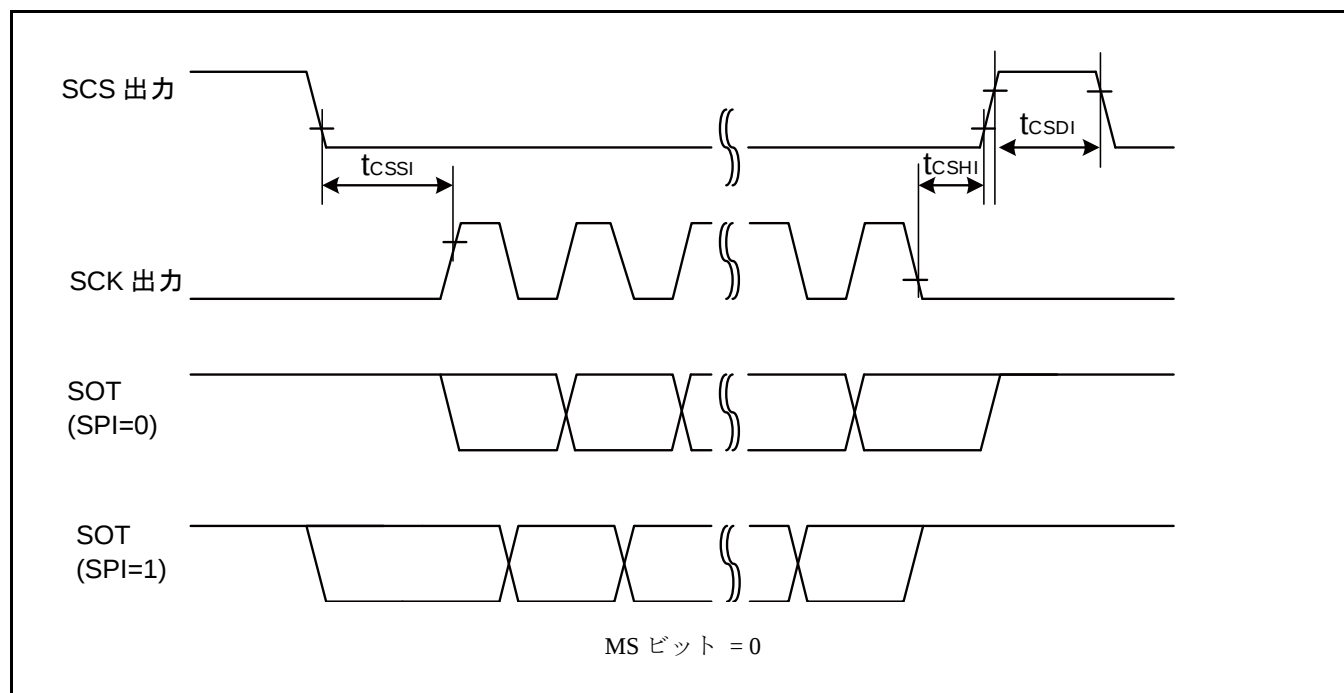
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



高速同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 0, CSLVL=0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\downarrow$ セットアップ時間	t _{CSSI}	内部シフト クロック 動作	(*)-20	(*)+0	(*)-20	(*)+0	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t _{CSHI}		(*)+0	(*)+20	(*)+0	(*)+20	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDI}		(*)-20 +5t _{CYCP}	(*)+20 +5t _{CYCP}	(*)-20 +5t _{CYCP}	(*)+20 +5t _{CYCP}	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\downarrow$ セットアップ時間	t _{CSSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCK $\uparrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t _{CSHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDE}		3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	25	-	25	ns
SCS $\downarrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t _{DDE}		0	-	0	-	ns

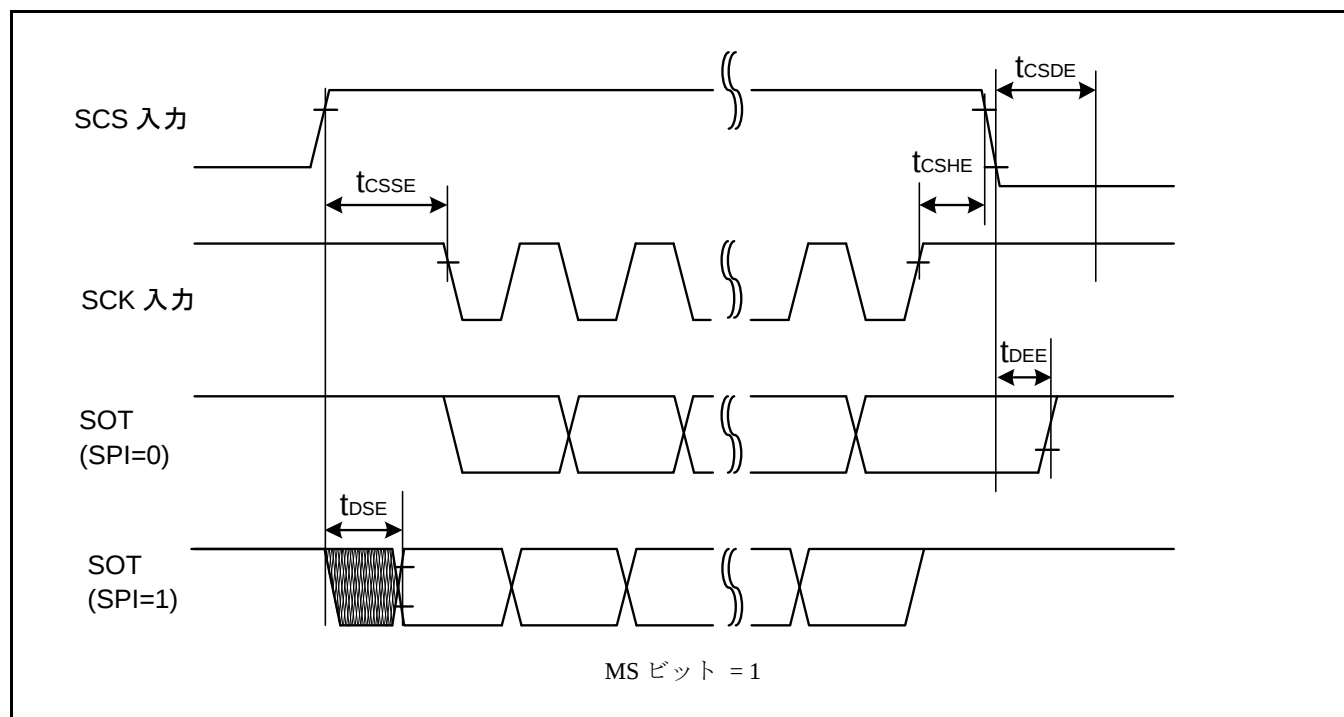
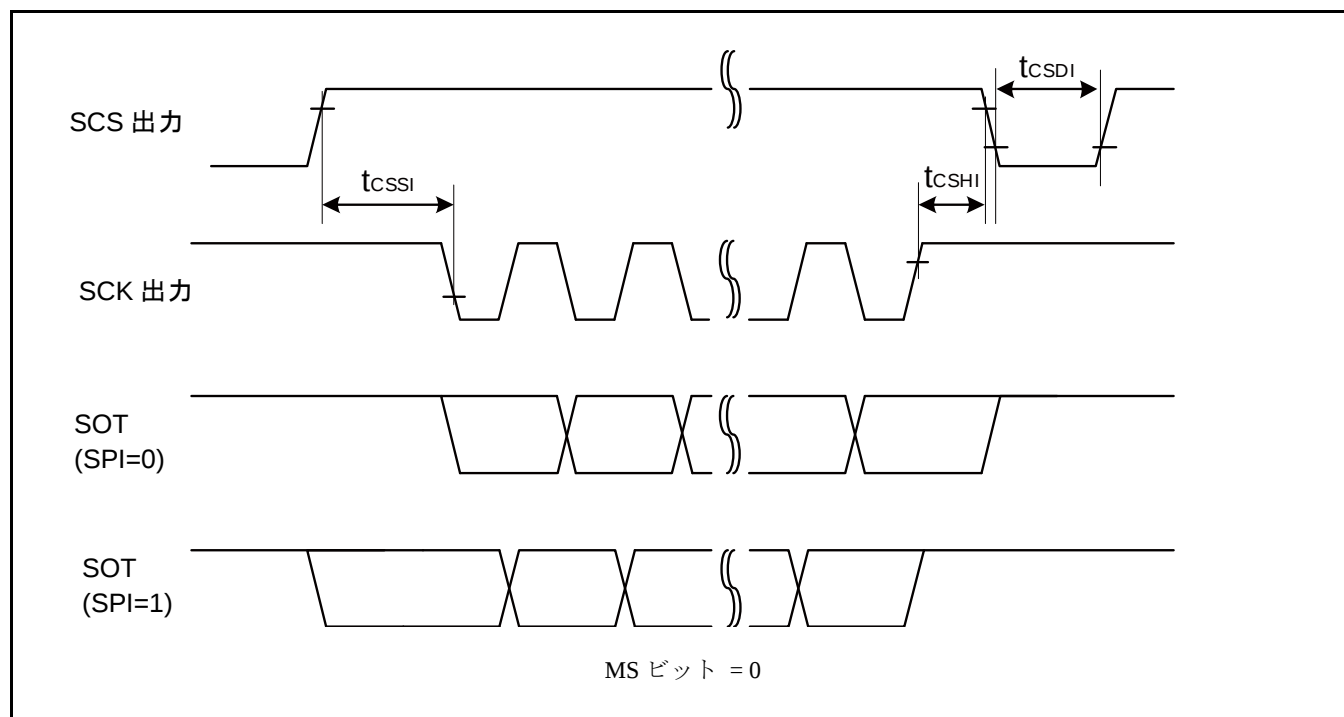
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



高速同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV = 1, CSLVL=0)

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	$V_{CC} < 4.5 V$		$V_{CC} \geq 4.5 V$		単位
			最小	最大	最小	最大	
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\uparrow$ セットアップ時間	t _{CSSI}	内部シフト クロック 動作	(*)-20	(*)+0	(*)-20	(*)+0	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t _{CSHI}		(*)+0	(*)+20	(*)+0	(*)+20	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDI}		(*)-20 +5t _{CYCP}	(*)+20 +5t _{CYCP}	(*)-20 +5t _{CYCP}	(*)+20 +5t _{CYCP}	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SCK $\uparrow$ セットアップ時間	t _{CSSE}	外部シフト クロック 動作	3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCK $\downarrow \rightarrow$ SCS $\downarrow$ ホールド時間	t _{CSHE}		0	-	0	-	ns
SCS ディセレクト時間	t _{CSDE}		3t _{CYCP} +15	-	3t _{CYCP} +15	-	ns
SCS $\uparrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t _{DSE}		-	25	-	25	ns
SCS $\downarrow \rightarrow$ SOT 遅延時間	t _{DDE}		0	-	0	-	ns

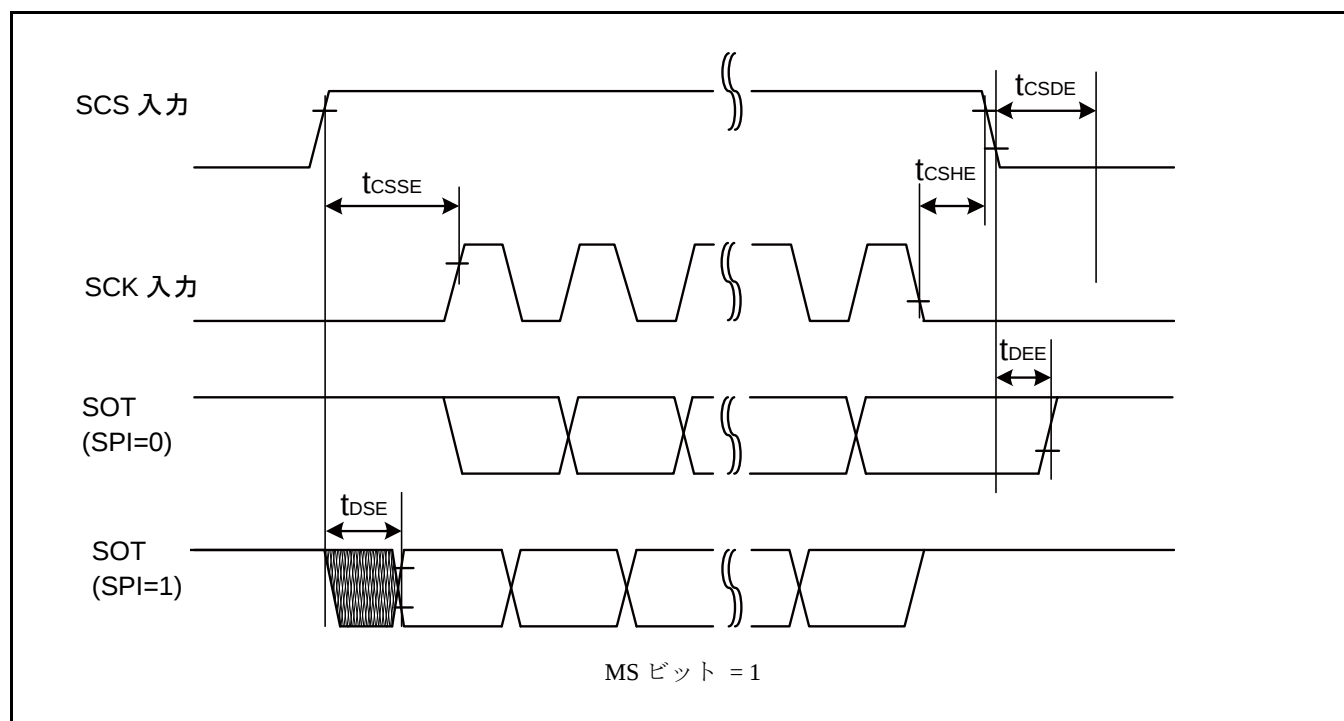
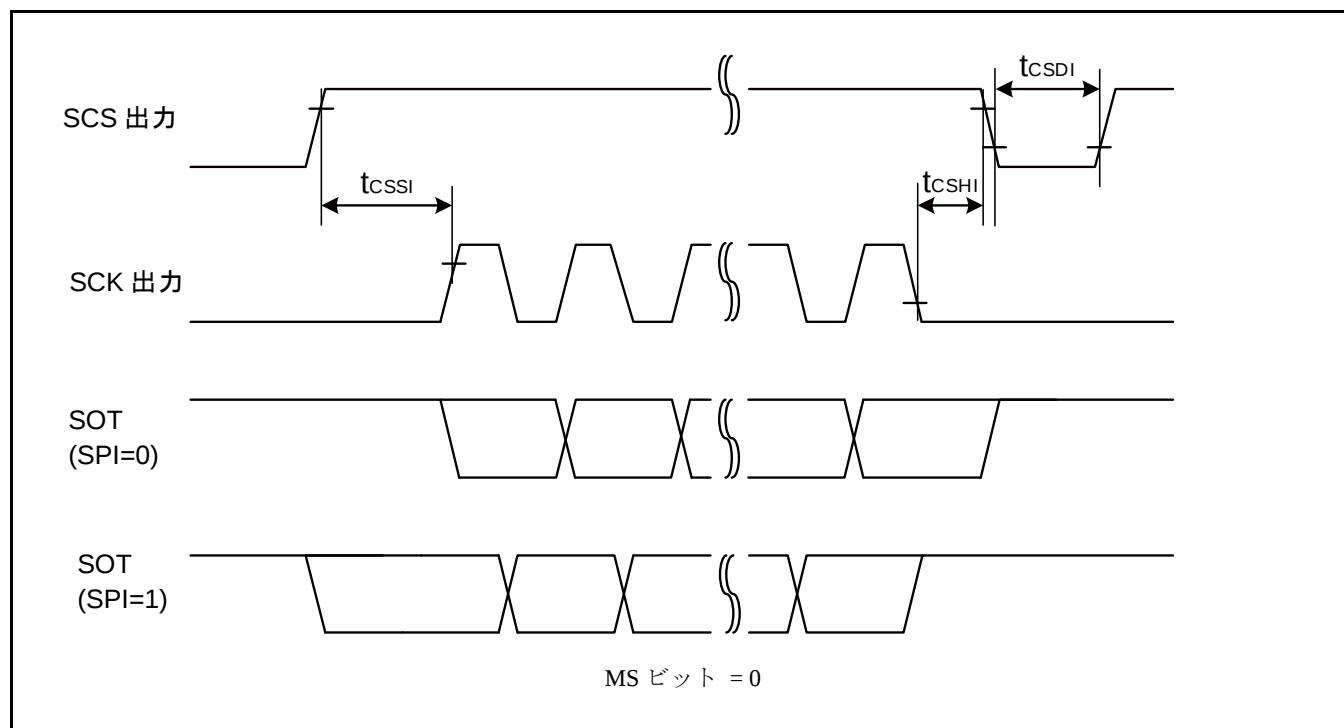
(*1): CSSU ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*2): CSHD ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

(*3): CSDS ビット値×シリアルチップセレクトタイミング動作クロック周期[ns]

<注意事項>

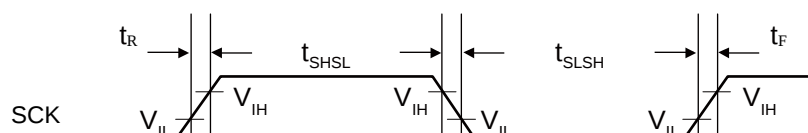
- t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。
マルチファンクションシリアルが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。
- CSSU, CSHD, CSDS, シリアルチップセレクトタイミング動作クロックは『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』を参照してください。
- 外部負荷容量 C_L = 30 pF 時



外部クロック (EXT = 1) : 非同期時のみ

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	規格値		単位	備考
			最小	最大		
シリアルクロック L パルス幅	t_{SLSH}	$C_L = 30 \text{ pF}$	$t_{CYCP} + 10$	-	ns	
シリアルクロック H パルス幅	t_{SHSL}		$t_{CYCP} + 10$	-	ns	
SCK 立下り時間	t_F		-	5	ns	
SCK 立上り時間	t_R		-	5	ns	



12.4.12 外部入力タイミング

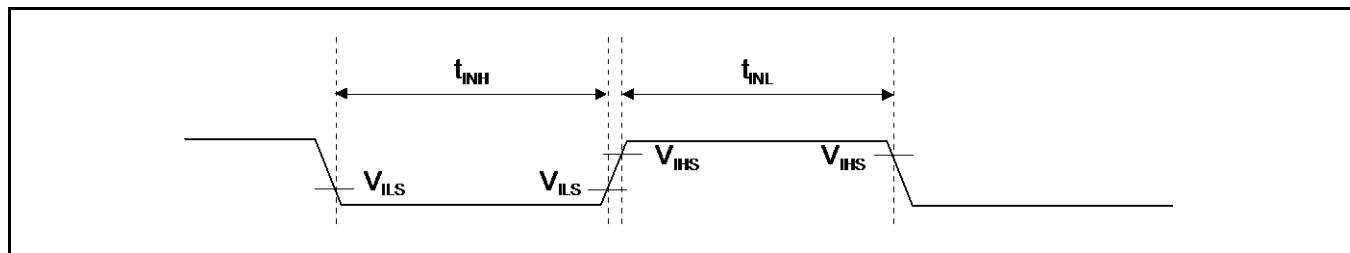
($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
入力パルス幅	t_{INH} , t_{INL}	ADTG	-	$2t_{CYCP}^{*1}$	-	ns	A/D コンバータトリガ入力
		FRCKx					フリーランタイム入力クロック
		ICxx					インプットキャプチャ
		DTTlxX	-	$2t_{CYCP}^{*1}$	-	ns	波形ジェネレータ
		INT00 ~ INT15, NMIX	-	$2t_{CYCP} + 100^{*1}$	-	ns	外部割込み, NMI
		WKUPx		500^{*2}	-	ns	
			-	500^{*3}	-	ns	ディープスタンバイ ウェイクアップ

*1: t_{CYCP} は APB バスクロックのサイクル時間です(タイマモード, ストップモードの停止時を除く)。A/D コンバータ, 多機能タイマ, 外部割込みが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。

*2: タイマモード, ストップモード時

*3: ディープスタンバイ RTC モード, ディープスタンバイストップモード時



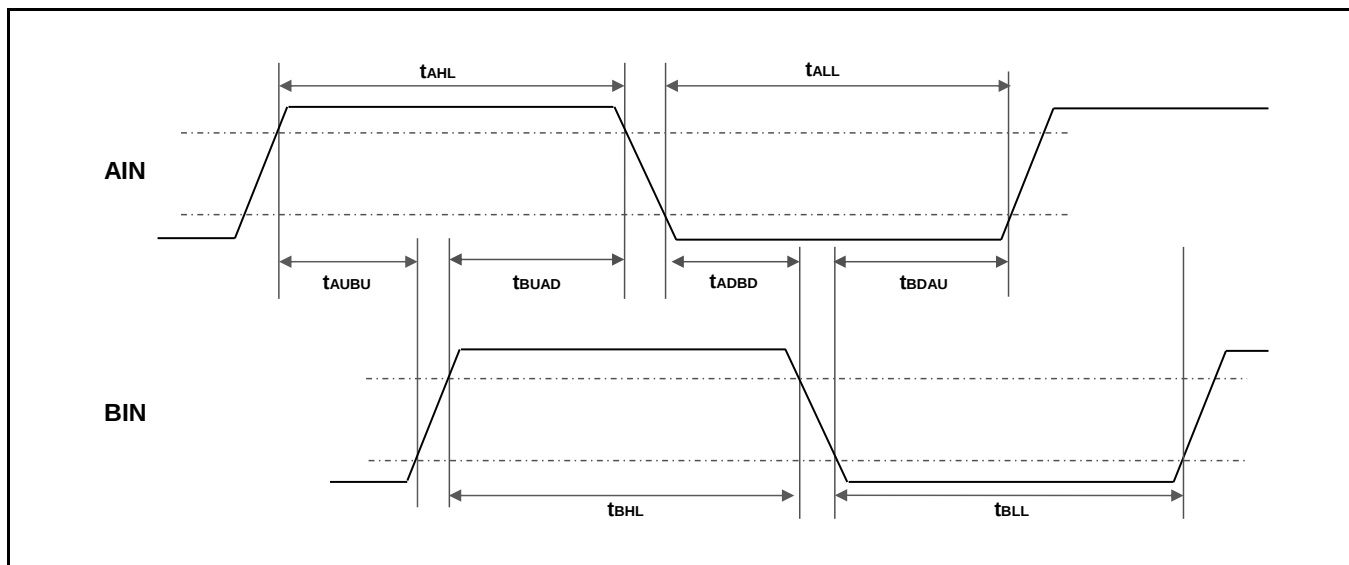
12.4.13 クアッドカウンタ タイミング

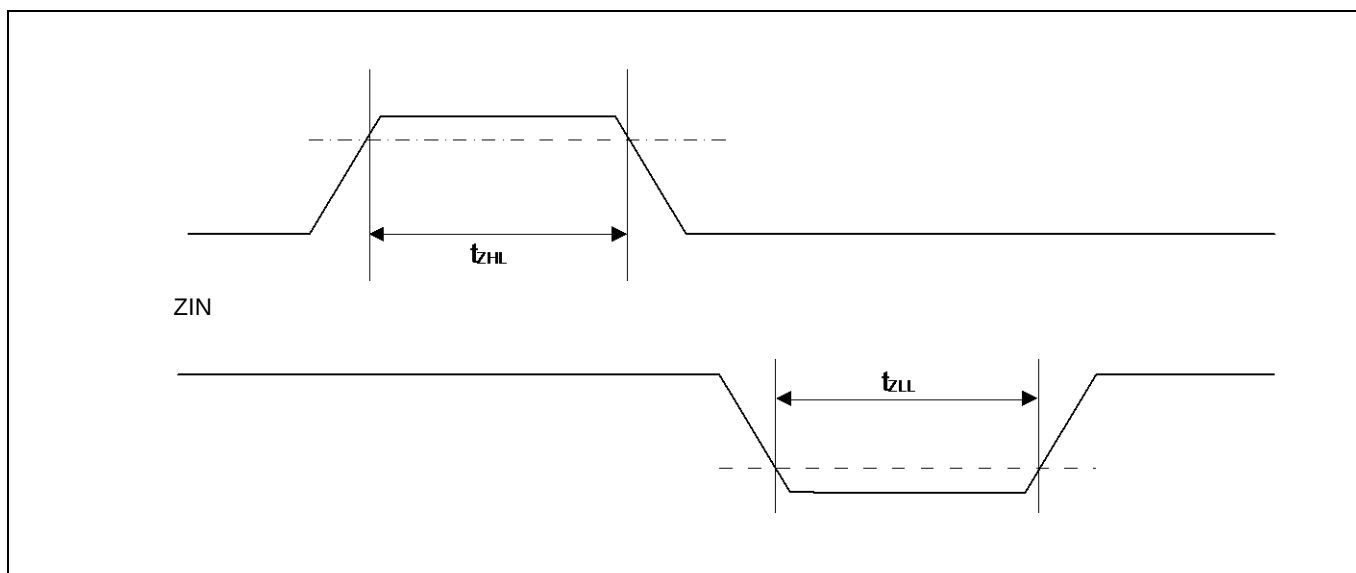
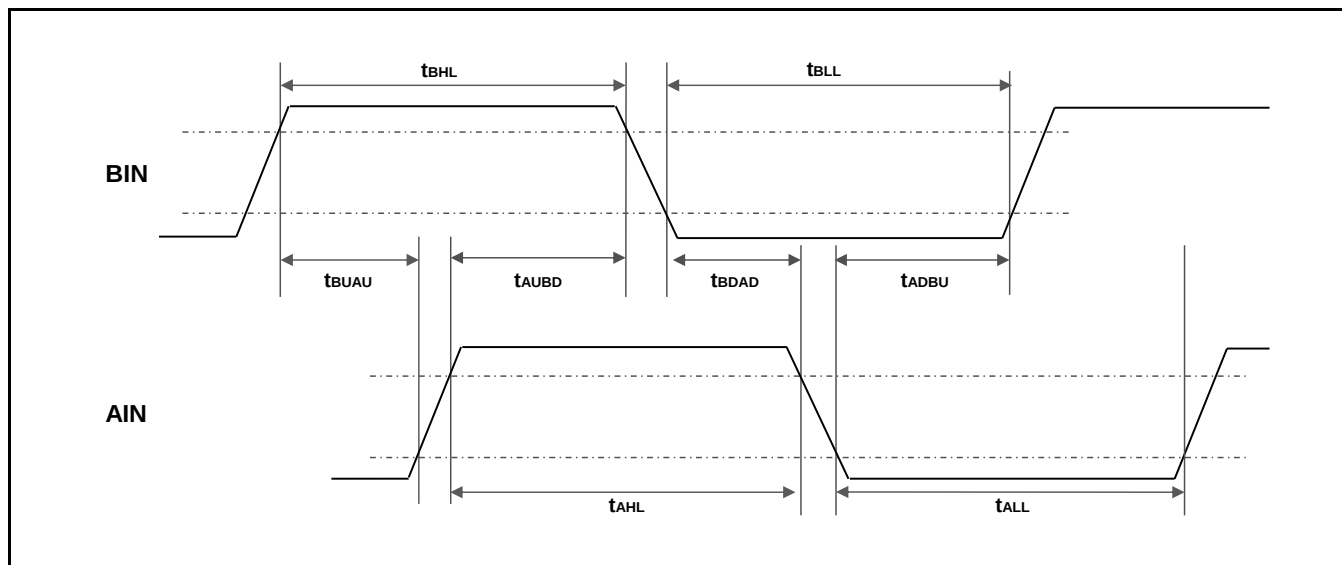
($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

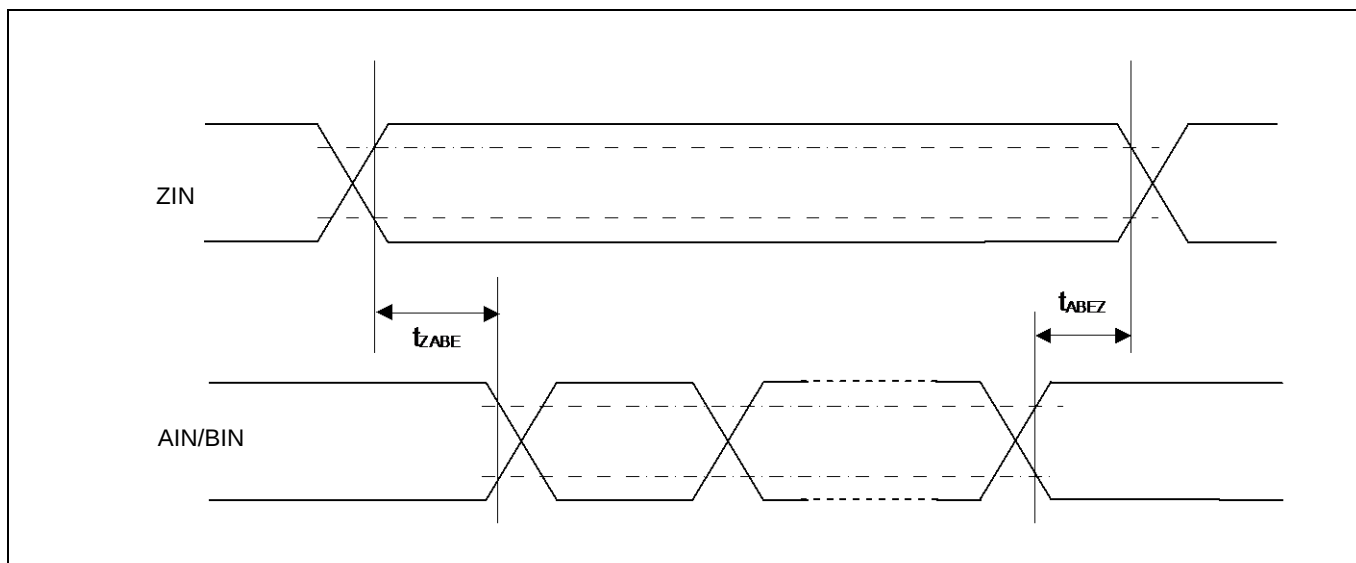
項目	記号	条件	規格値		単位
			最小値	最大値	
AIN 端子 H 幅	t _{AHL}	-	2t _{cyCP} *	-	ns
AIN 端子 L 幅	t _{ALL}	-			
BIN 端子 H 幅	t _{BHL}	-			
BIN 端子 L 幅	t _{BLL}	-			
AIN H レベルから BIN 立上り時間	t _{AUBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN H レベルから AIN 立下り時間	t _{BUAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN L レベルから BIN 立下り時間	t _{ADBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN L レベルから AIN 立上り時間	t _{BDAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN H レベルから AIN 立上り時間	t _{BUAU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN H レベルから BIN 立下り時間	t _{AUBD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
BIN L レベルから AIN 立下り時間	t _{BDAD}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
AIN L レベルから BIN 立上り時間	t _{ADBU}	PC_Mode2 または PC_Mode3			
ZIN 端子 H 幅	t _{ZHL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN 端子 L 幅	t _{ZLL}	QCR:CGSC="0"			
ZIN レベル確定から AIN/BIN 立下り立上り時間	t _{ZABE}	QCR:CGSC="1"			
AIN/BIN 立下り立上り時間から ZIN レベル確定	t _{ABEZ}	QCR:CGSC="1"			

*: t_{cyCP} は APB バスクロックのサイクル時間です(タイマモード, ストップモード時を除く)。

クアッドカウンタが接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。







12.4.14 I2C タイミング

Standard-mode, Fast-mode

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	条件	Standard-mode		Fast-mode		単位	備考
			最小	最大	最小	最大		
SCL クロック周波数	f_{SCL}	$C_L = 30 \text{ pF}$, $R = (V_p/I_{OL})^{*1}$	0	100	0	400	kHz	
(反復)「スタート」条件 ホールド時間 $SDA \downarrow \rightarrow SCL \downarrow$	t_{HDSTA}		4.0	-	0.6	-	μs	
SCL クロック L 幅	t_{LOW}		4.7	-	1.3	-	μs	
SCL クロック H 幅	t_{HIGH}		4.0	-	0.6	-	μs	
反復「スタート」条件 セットアップ時間 $SCL \uparrow \rightarrow SDA \downarrow$	t_{SUSTA}		4.7	-	0.6	-	μs	
データホールド時間 $SCL \downarrow \rightarrow SDA \downarrow \uparrow$	t_{HDDAT}		0	3.45^{*2}	0	0.9^{*3}	μs	
データセットアップ時間 $SDA \downarrow \uparrow \rightarrow SCL \uparrow$	t_{SUDAT}		250	-	100	-	ns	
「ストップ」条件 セットアップ時間 $SCL \uparrow \rightarrow SDA \uparrow$	t_{SUSTO}		4.0	-	0.6	-	μs	
「ストップ」条件と 「スタート」条件との間の バスフリー時間	t_{BUF}		4.7	-	1.3	-	μs	
ノイズフィルタ	t_{SP}	$2 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 40 \text{ MHz}$	$2t_{CYCP}^{*4}$	-	$2t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	*5
		$40 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 60 \text{ MHz}$	$4t_{CYCP}^{*4}$	-	$4t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$60 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 80 \text{ MHz}$	$6t_{CYCP}^{*4}$	-	$6t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$80 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 100 \text{ MHz}$	$8t_{CYCP}^{*4}$	-	$8t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$100 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 120 \text{ MHz}$	$10t_{CYCP}^{*4}$	-	$10t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$120 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 140 \text{ MHz}$	$12t_{CYCP}^{*4}$	-	$12t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$140 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 160 \text{ MHz}$	$14t_{CYCP}^{*4}$	-	$14t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	
		$160 \text{ MHz} \leq t_{CYCP} < 180 \text{ MHz}$	$16t_{CYCP}^{*4}$	-	$16t_{CYCP}^{*4}$	-	ns	

*1: R , C_L は SCL, SDA ラインのプルアップ抵抗、負荷容量です。 V_p はプルアップ抵抗の電源電圧、 I_{OL} は V_{OL} 保証電流を示します。

*2: 最大 t_{HDDAT} は少なくともデバイスの SCL 信号の L 区間(t_{LOW})を延長していないということを満たしていなければなりません。

*3: Fast-mode I2C バスデバイスは Standard-mode I2C バスシステムに使用できますが、要求される条件 $t_{SUDAT} \geq 250\text{ns}$ を満足しなければなりません。

*4: t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。

I2C が接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。

Standard-mode 使用時は、周辺バスクロックを 2 MHz 以上に設定してください。

Fast-mode 使用時は、周辺バスクロックを 8 MHz 以上に設定してください。

*5: ノイズフィルタ時間はレジスタの設定により切り替えることができます。

APB バスクロック周波数に応じて、ノイズフィルタ段数の変更をしてください。

Fast-mode Plus (Fm+)

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V, V_{SS} = 0V)

項目	記号	条件	Fast-mode plus(Fm+)*6		単位	備考
			最小	最大		
SCL クロック周波数	f _{SCL}	C _L = 30 pF, R = (V _p /I _{OL})*1	0	1000	kHz	
(反復)「スタート」条件 ホールド時間 SDA ↓ → SCL ↓	t _{HDSTA}		0.26	-	μs	
SCL クロック L 幅	t _{LOW}		0.5	-	μs	
SCL クロック H 幅	t _{HIGH}		0.26	-	μs	
反復「スタート」条件 セットアップ時間 SCL ↑ → SDA ↓	t _{SUSTA}		0.26	-	μs	
データホールド時間 SCL ↓ → SDA ↓ ↑	t _{HDDAT}		0	0.45*2, *3	μs	
データセットアップ時間 SDA ↓ ↑ → SCL ↑	t _{SUDAT}		50	-	ns	
「ストップ」条件 セットアップ時間 SCL ↑ → SDA ↑	t _{SUSTO}		0.26	-	μs	
「ストップ」条件と 「スタート」条件との間のバ スフリー時間	t _{BUF}		0.5	-	μs	
ノイズフィルタ	t _{SP}	60 MHz ≤ t _{CYCP} < 80 MHz	6 t _{CYCP} *4	-	ns	*5
		80 MHz ≤ t _{CYCP} < 100 MHz	8 t _{CYCP} *4	-	ns	
		100 MHz ≤ t _{CYCP} < 120 MHz	10 t _{CYCP} *4	-	ns	
		120 MHz ≤ t _{CYCP} < 140 MHz	12 t _{CYCP} *4	-	ns	
		140 MHz ≤ t _{CYCP} < 160 MHz	14 t _{CYCP} *4	-	ns	
		160 MHz ≤ t _{CYCP} < 180 MHz	16 t _{CYCP} *4	-	ns	

*1: R, C_L は SCL, SDA ラインのプルアップ抵抗、負荷容量です。V_p はプルアップ抵抗の電源電圧、I_{OL} は V_{OL} 保証電流を示します。

*2: 最大 t_{HDDAT} は少なくともデバイスの SCL 信号の L 区間(t_{LOW})を延長していないということを満たしていなければなりません。

*3: Fast-mode I²C バスデバイスは Standard-mode I²C バスシステムに使用できますが、要求される条件 t_{SUDAT} ≥ 250 ns を満足しなければなりません。

*4: t_{CYCP} は、APB バスクロックのサイクル時間です。

I²C が接続されている APB バス番号については「8. ブロックダイアグラム」を参照してください。

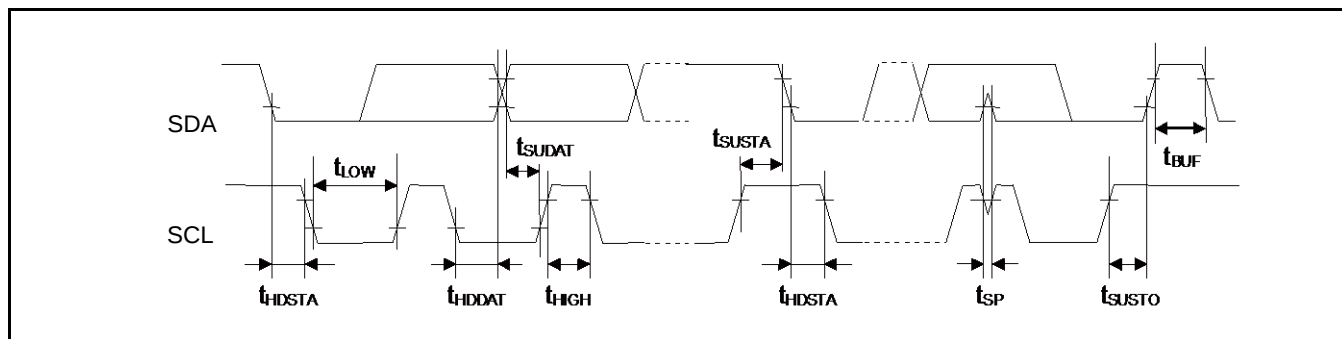
Fast-mode plus(Fm+)使用時は、周辺バスクロックを 64 MHz 以上に設定してください。

*5: ノイズフィルタ時間はレジスタの設定により切り替えることができます。

APB バスクロック周波数に応じて、ノイズフィルタ段数の変更をしてください。

*6: Fast-mode plus(Fm+)使用時は、I/O 端子を EPFR レジスタにて I²C Fm+に対応したモードに設定してください。

詳細は『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル 本編(MN709-00001)』の『CHAPTER 12: I/O ポート』の章を参照してください。



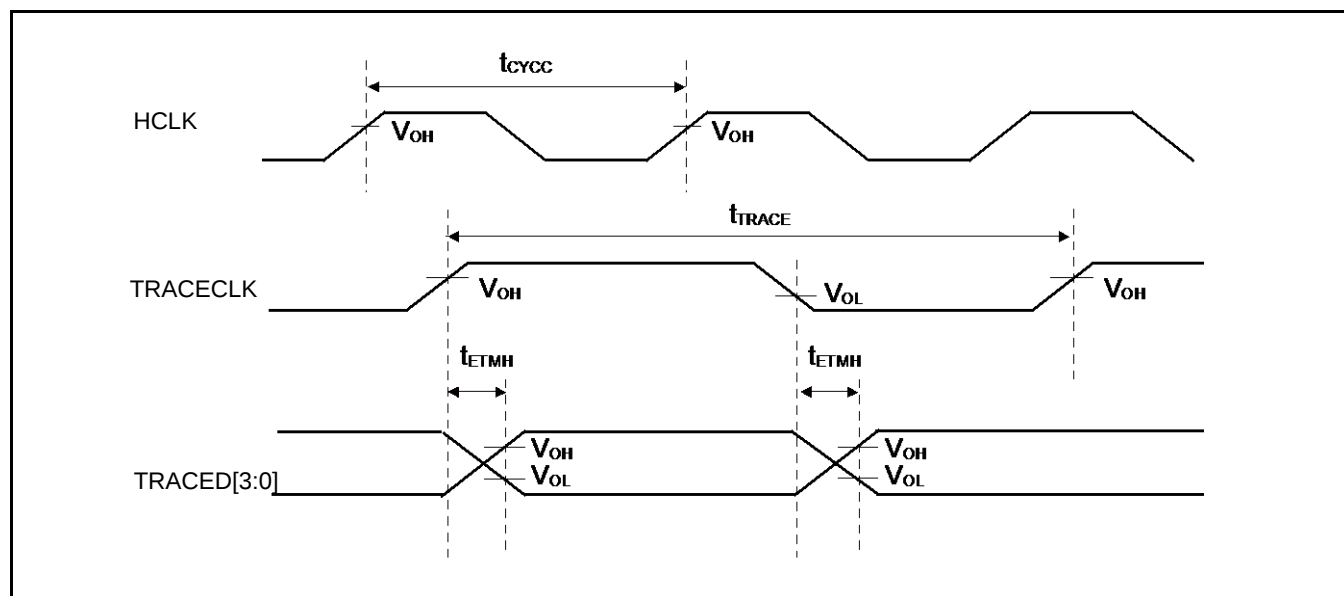
12.4.15 ETM タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
データホールド	t_{ETMH}	TRACECLK, TRACED[3:0]	$V_{CC} \geq 4.5V$	2	9	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	2	15		
TRACECLK 周波数	$1/t_{TRACE}$	TRACECLK	$V_{CC} \geq 4.5V$	-	50	MHz	
			$V_{CC} < 4.5V$	-	32	MHz	
TRACECLK クロック周期	t_{TRACE}	TRACECLK	$V_{CC} \geq 4.5V$	20	-	ns	
			$V_{CC} < 4.5V$	31.25	-	ns	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30pF$ 時



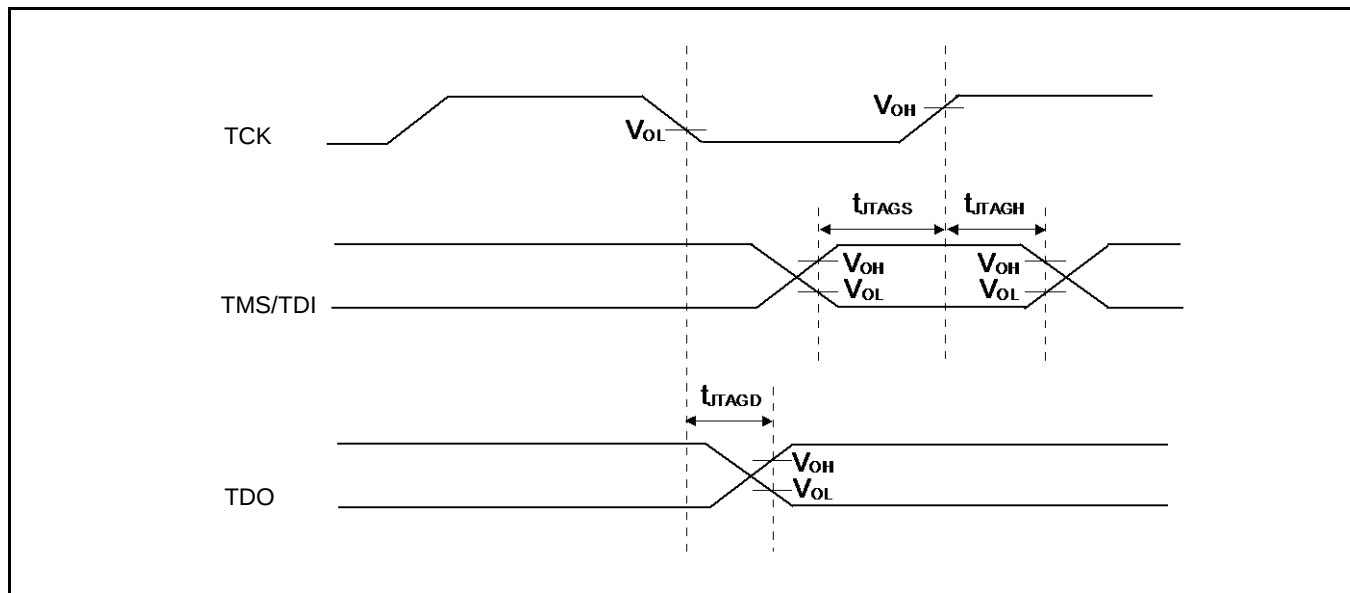
12.4.16 JTAG タイミング

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	条件	規格値		単位	備考
				最小	最大		
TMS, TDI セットアップ時間	t_{TAGS}	TCK, TMS, TDI	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	15	-	ns	
TMS, TDI ホールド時間	t_{TAGH}	TCK, TMS, TDI	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	15	-	ns	
TDO 遅延時間	t_{TAGD}	TCK TDO	$V_{CC} \geq 4.5V$ $V_{CC} < 4.5V$	- -	25 45	ns	

<注意事項>

- 外部負荷容量 $C_L = 30\text{ pF}$ 時



12.5 12 ビット A/D コンバータ

A/D 変換部電気的特性

($V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = AV_{SS} = AV_{RL} = 0V$)

項目	記号	端子名	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
分解能	-	-	-	-	12	bit	
積分直線性誤差	-	-	-	-	± 4.5	LSB	AVRH = 2.7 V ~ 5.5 V オフセットキャ リブレーション 機能使用時
微分直線性誤差	-	-	-	-	± 2.5	LSB	
ゼロトランジション 電圧	V_{ZT}	ANxx	-	± 2	± 7	LSB	
フルスケルトラン ジション電圧	V_{FST}	ANxx	-	$AVRH \pm 2$	$AVRH \pm 7$	LSB	
総合誤差	-	-	-	± 3	± 8	LSB	
変換時間	-	-	0.5^{*1}	-	-	μs	$AV_{CC} \geq 4.5 V$
サンプリング時間 *2	t_s	-	0.15	-	10	μs	$AV_{CC} \geq 4.5 V$
			0.3	-			$AV_{CC} < 4.5 V$
コンペアクロック周 期 *3	t_{CCK}	-	25	-	1000	ns	$AV_{CC} \geq 4.5 V$
			50	-	1000		$AV_{CC} < 4.5 V$
動作許可状態遷移時 間	t_{STT}	-	-	-	1.0	μs	
電源電流 (アナログ + デジタ ル)	-	AVCC	-	0.69	0.92	mA	A/D 1unit 動作時
			-	1.0	18	μA	A/D 停止時
基準電源電流 (AVRH)	-	AVRH	-	1.1	1.97	mA	A/D 1unit 動作時 AVRH=5.5 V
				0.3	6.3	μA	A/D 停止時
アナログ入力容量	C_{AIN}	-	-	-	12.05	pF	
アナログ入力抵抗	R_{AIN}	-	-	-	1.2	k Ω	$AV_{CC} \geq 4.5 V$
					1.8		$AV_{CC} < 4.5 V$
チャンネル間ばらつき	-	-	-	-	4	LSB	
アナログポート入力 リーク電流	-	ANxx	-	-	5	μA	
アナログ入力電圧	-	ANxx	AV_{SS}	-	AVRH	V	
基準電圧	-	AVRH	4.5	-	AV_{CC}	V	$T_{cck} < 50 ns$
			2.7	-	AV_{CC}		$T_{cck} \geq 50 ns$
	-	AVRL	AV_{SS}	-	AV_{SS}	V	

*1: 変換時間は サンプリング時間 (t_s) + コンペア時間 (t_c) の値です。

最小変換時間の条件は、サンプリング時間: 150ns, コンペア時間: 350 ns ($AV_{CC} \geq 4.5 V$)の値です。

必ずサンプリング時間(t_s), コンペアクロック周期(t_{cck})の規格を満足するようにしてください。

サンプリング時間, コンペアクロック周期の設定については、『FM4 ファミリー ペリフェラルマニュアル アナログマクロ編』の『CHAPTER 1-1: A/D コンバータ』の章を参照してください。

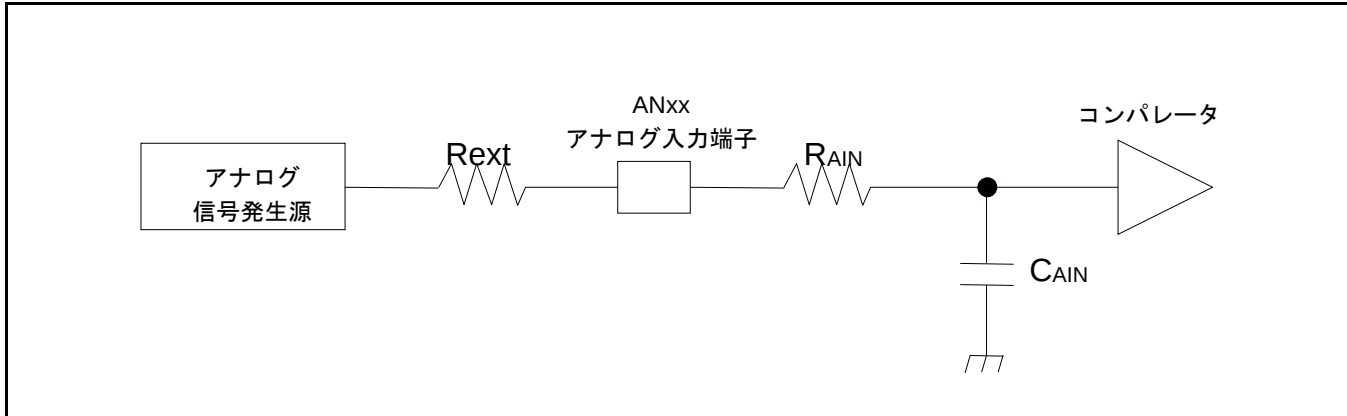
A/D コンバータのレジスタの設定は周辺クロックタイミングで反映されます。

サンプリングおよびコンペアクロックはベースクロック(HCLK)にて設定されます。

*2: 外部インピーダンスにより必要なサンプリング時間は変わります。

必ず(式 1)を満たすようにサンプリング時間を設定してください。

*3: コンペア時間(t_c) は (式 2)の値です。



(式 1) $t_s \geq (R_{AIN} + R_{ext}) \times C_{AIN} \times 9$

t_s : サンプリング時間

R_{AIN} : A/D の入力抵抗 = 1.2 k Ω 4.5 V $\leq$ AV_{CC} $\leq$ 5.5 V の場合

A/D の入力抵抗 = 1.8 k Ω 2.7 V $\leq$ AV_{CC} $\leq$ 4.5 V の場合

C_{AIN} : A/D の入力容量 = 12.05 pF 2.7 V $\leq$ AV_{CC} $\leq$ 5.5 V の場合

R_{ext} : 外部回路の出力インピーダンス

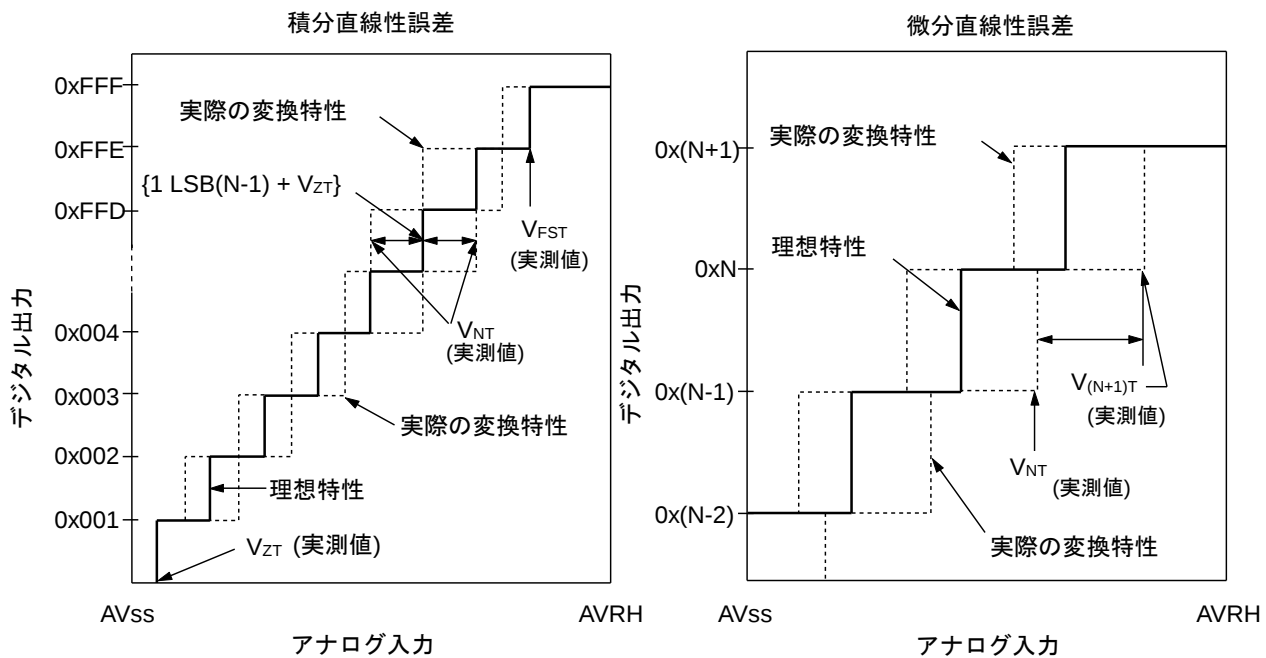
(式 2) $t_c = t_{CCK} \times 14$

t_c : コンペア時間

t_{CCK} : コンペアクロック周期

12 ビット A/D コンバータの用語の定義

- 分解能: A/D コンバータにより識別可能なアナログ変化
- 積分直線性誤差: ゼロトランジション点(0b000000000000 ↔ 0b000000000001)とフルスケールトランジション点(0b111111111110 ↔ 0b111111111111)を結んだ直線と実際の変換特性との偏差
- 微分直線性誤差: 出力コードを 1LSB 変化させるのに必要な入力電圧の理想値からの偏差



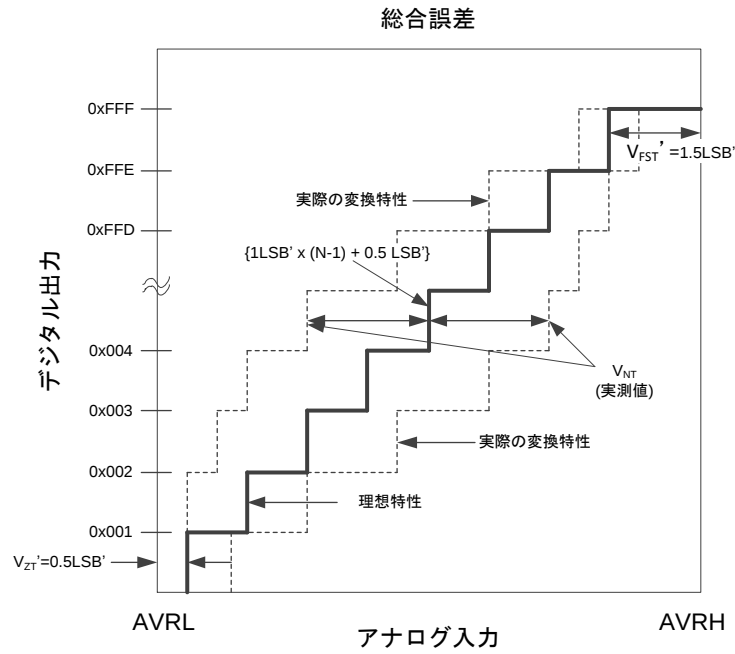
$$\text{デジタル出力 } N \text{ の積分直線性誤差} = \frac{V_{NT} - \{1\text{LSB} \times (N - 1) + V_{ZT}\}}{1\text{LSB}} \quad [\text{LSB}]$$

$$\text{デジタル出力 } N \text{ の微分直線性誤差} = \frac{V_{(N+1)T} - V_{NT}}{1\text{LSB}} - 1 \quad [\text{LSB}]$$

$$1\text{LSB} = \frac{V_{FST} - V_{ZT}}{4094}$$

- N: A/D コンバータデジタル出力値
- V_{ZT}: デジタル出力が 0x000 から 0x001 に遷移する電圧
- V_{FST}: デジタル出力が 0xFFE から 0xFFF に遷移する電圧
- V_{NT}: デジタル出力が 0x (N - 1) から 0xN に遷移する電圧

■総合誤差: 実際の値と理論値との差を言い、ゼロトランジション電圧/フルスケールトランジション電圧/直線性誤差を含む誤差



$$\text{デジタル出力Nの総合誤差} = \frac{V_{NT} - \{1 \text{ LSB}' \times (N-1) + 0.5 \text{ LSB}'\}}{1 \text{ LSB}'} \quad [\text{LSB}]$$

$$1 \text{ LSB}' (\text{理想値}) = \frac{AVRH - AVRL}{4096} \quad [\text{V}]$$

$$V_{ZT}' (\text{理想値}) = AVRL + 0.5 \text{ LSB}' \quad [\text{V}]$$

$$V_{FST}' (\text{理想値}) = AVRH - 1.5 \text{ LSB}' \quad [\text{V}]$$

V_{NT}' : デジタル出力が (N-1) からNに移る電圧

12.6 12 ビット D/A コンバータ

D/A 変換部電気的特性

($V_{CC} = AV_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = AV_{SS} = 0V$)

項目	記号	端子名	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
分解能	-	DAx	-	-	12	bit	
変換時間	tc20		0.56	0.69	0.81	μs	負荷 20 pF
	tc100		2.79	3.42	4.06	μs	負荷 100 pF
積分直線性誤差*	INL		- 16	-	+ 16	LSB	
微分直線性誤差*	DNL		- 0.98	-	+ 1.5	LSB	
出力電圧オフセット	V _{OFF}		-	-	10.0	mV	0x000 設定時
			- 20.0	-	+ 1.4	mV	0xFFF 設定時
アナログ出力インピーダンス	R _O		3.10	3.80	4.50	kΩ	D/A 動作時
			2.0	-	-	MΩ	D/A 停止時
電源電流*	IDDA	AVCC	260	330	410	μA	D/A 1unit 動作時 AV _{CC} =3.3 V
			400	510	620	μA	D/A 1unit 動作時 AV _{CC} =5.0 V
	IDSA		-	-	14	μA	D/A 停止時

*: 無負荷時

12.7 低電圧検出特性

12.7.1 低電圧検出リセット

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	-	2.25	2.45	2.65	V	電圧降下時
解除電圧	VDH	-	2.30	2.50	2.70	V	電圧上昇時

12.7.2 低電圧検出割込み

項目	記号	条件	規格値			単位	備考
			最小	標準	最大		
検出電圧	VDL	SVHI = 00111	2.58	2.8	3.02	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.67	2.9	3.13	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 00100	2.76	3.0	3.24	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		2.85	3.1	3.34	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 01100	2.94	3.2	3.45	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.04	3.3	3.56	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 01111	3.31	3.6	3.88	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.40	3.7	3.99	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 01110	3.40	3.7	3.99	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.50	3.8	4.10	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 01001	3.68	4.0	4.32	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.77	4.1	4.42	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 01000	3.77	4.1	4.42	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.86	4.2	4.53	V	電圧上昇時
検出電圧	VDL	SVHI = 11000	3.86	4.2	4.53	V	電圧降下時
解除電圧	VDH		3.96	4.3	4.64	V	電圧上昇時
LVD 安定待ち時間	tLVDW	-	-	-	4480 × tCYCP*	μs	

*: tCYCP は APB2 バスクロックのサイクル時間です。

12.8 メインフラッシュメモリ書込み/消去特性

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V)

項目		規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
セクタ消去時間	Large Sector	-	0.7	3.7	s	内部での消去前書込み時間を含む
	Small Sector		0.3	1.1		
ハーフワード(16ビット)書込み時間	書込みサイクル ≤ 100	-	12	100	μs	システムレベルのオーバーヘッド時間は除く
	書込みサイクル > 100			200		
チップ消去時間		-	13.6	68	s	内部での消去前書込み時間を含む

書込みサイクルとデータ保持時間

消去/書込みサイクル(cycle)	保持時間(年)
1,000	20 *
10,000	10 *
100,000	5 *

*: 信頼性評価結果からの換算値です(アレニウスの式を使用し、高温加速試験結果を平均温度+85°Cへ換算しています)。

12.9 ワークフラッシュメモリ書込み/消去特性

(V_{CC} = 2.7V ~ 5.5V)

項目		規格値			単位	備考
		最小	標準	最大		
セクタ消去時間		-	0.3	1.5	s	内部での消去前書込み時間を含む
ハーフワード(16ビット)書込み時間		-	20	200	μs	システムレベルのオーバーヘッド時間は除く
チップ消去時間		-	1.2	6	s	内部での消去前書込み時間を含む

書込みサイクルとデータ保持時間

消去/書込みサイクル(cycle)	保持時間(年)
1,000	20 *
10,000	10 *
100,000	5 *

*: 信頼性評価結果からの換算値です(アレニウスの式を使用し、高温加速試験結果を平均温度+85°Cへ換算しています)。

12.10 スタンバイ復帰時間

12.10.1 復帰要因: 割込み/WKUP

内部回路の復帰要因受付からプログラム動作開始までの時間を示します。

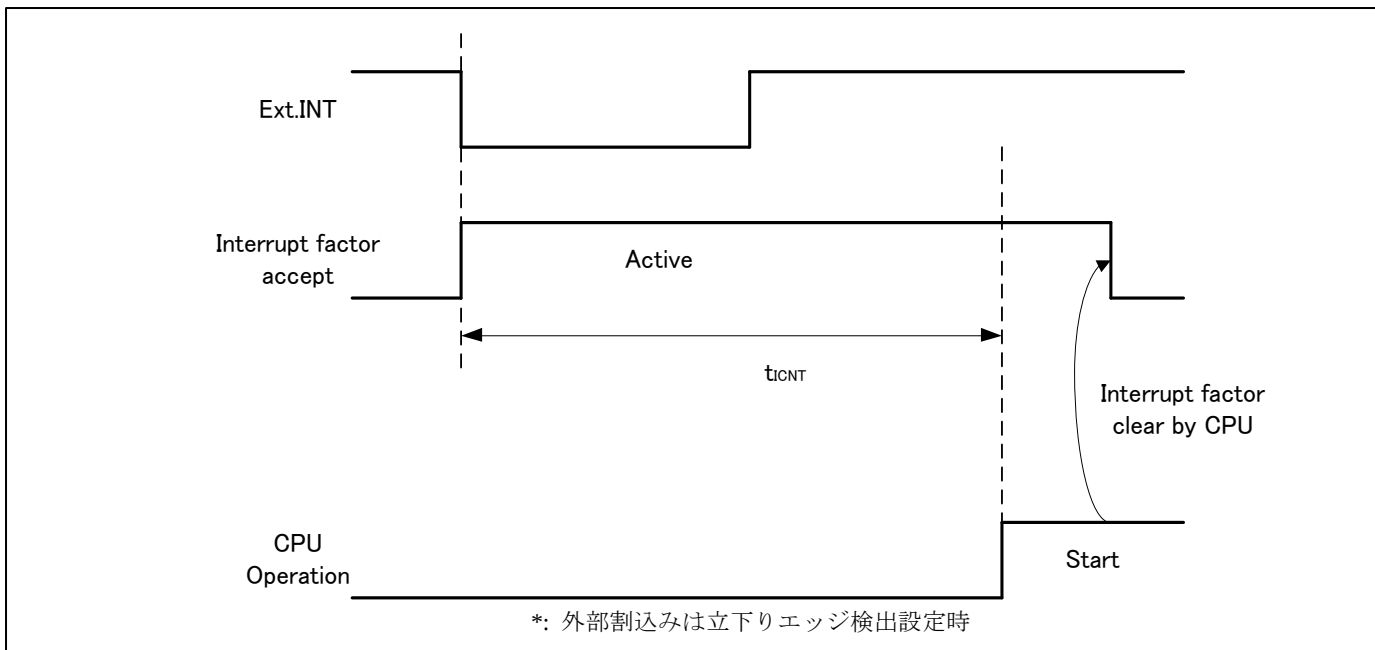
復帰カウント時間

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

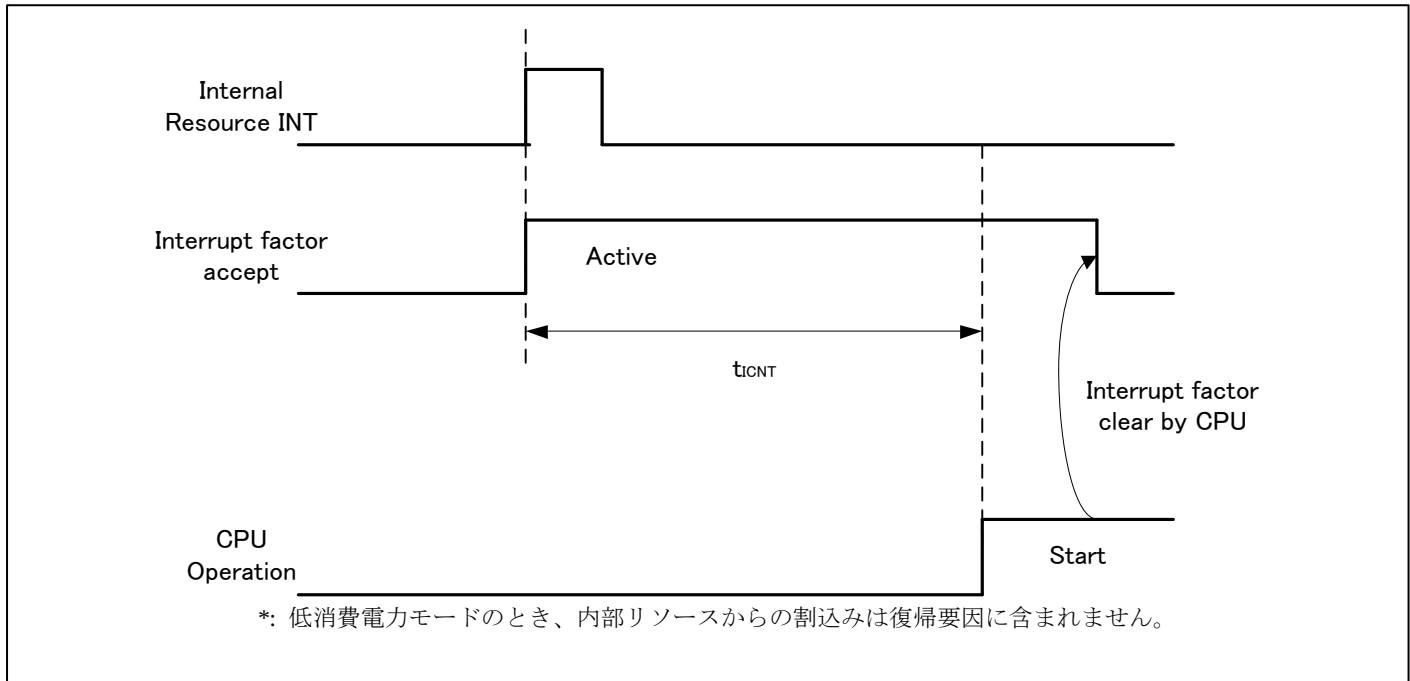
項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	t _{ICNT}	HCLK×1		μs	
高速 CR タイマモード メインタイマモード PLL タイマモード		40	80	μs	
低速 CR タイマモード		450	900	μs	
サブタイマモード		896	1136	μs	
RTC モード ストップモード (メイン/高速 CR/PLL ランモード復帰)		316	581	μs	
RTC モード ストップモード (サブ/低速 CR ランモード復帰)		270	540	μs	
ディープスタンバイ RTC モード		365	667	μs	RAM 保持なし
ディープスタンバイストップモード		365	667	μs	RAM 保持あり

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(外部割込み復帰時*)



スタンバイ復帰動作例(内部リソース割込み復帰時*)



<注意事項>

- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。
各低消費電力モードからの復帰要因は『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- 割込み復帰時、CPU が復帰する動作モードは低消費電力モード遷移前の状態に依存します。詳細は『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』を参照してください。

12.10.2 復帰要因: リセット

リセット解除からプログラム動作開始までの時間を示します。

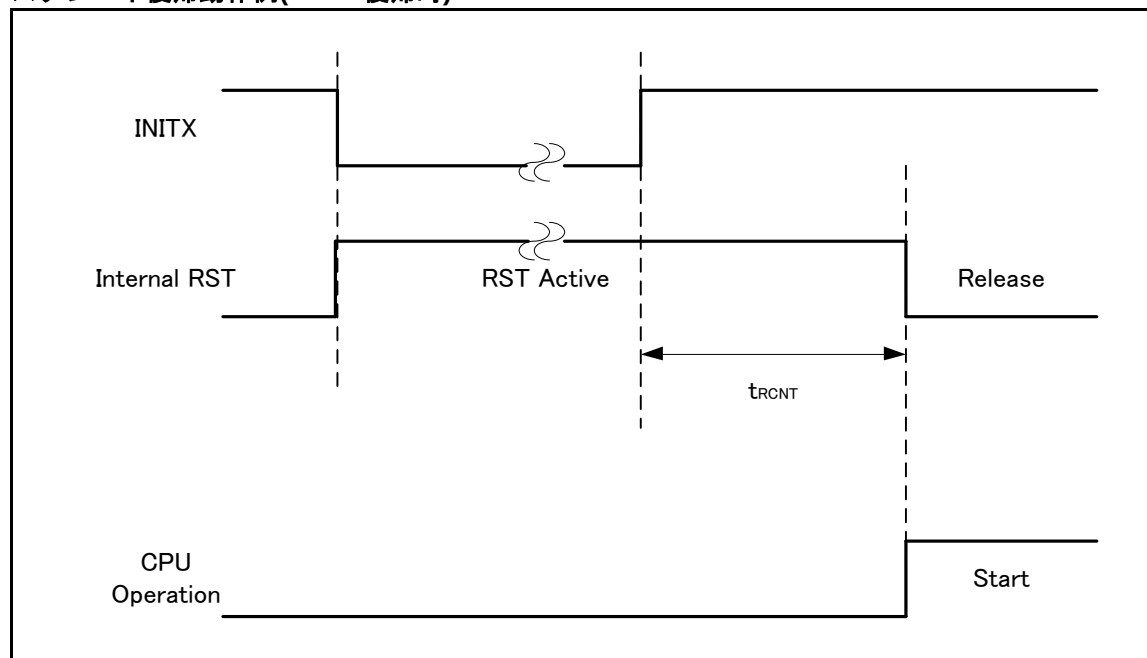
復帰カウント時間

($V_{CC} = 2.7V \sim 5.5V$, $V_{SS} = 0V$)

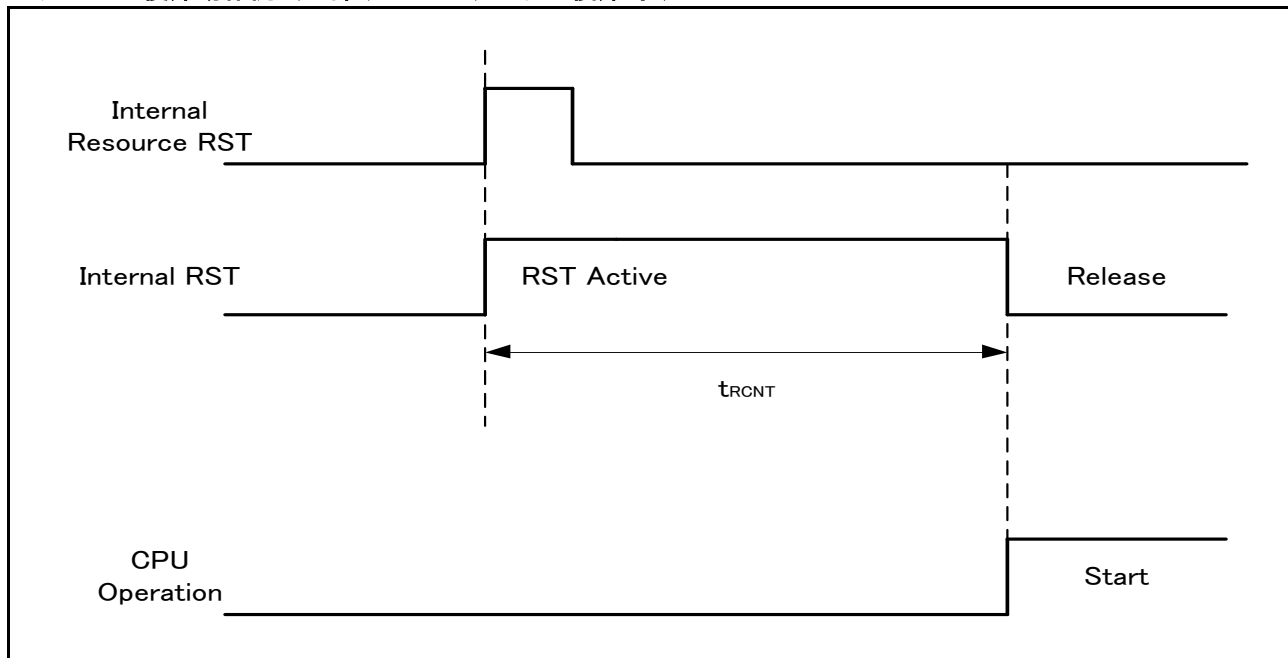
項目	記号	規格値		単位	備考
		標準	最大*		
スリープモード	t _{RCNT}	155	266	μs	
高速 CR タイマモード メインタイマモード PLL タイマモード		155	266	μs	
低速 CR タイマモード		315	567	μs	
サブタイマモード		315	567	μs	
RTC モード		315	567	μs	
ストップモード		315	567	μs	
ディープスタンバイ RTC モード ディープスタンバイストップモード		336	667	μs	RAM 保持なし
		336	667	μs	RAM 保持あり

*: 規格値の最大値は内蔵 CR の精度に依存します。

スタンバイ復帰動作例(INITX 復帰時)



スタンバイ復帰動作例（内部リソースリセット復帰時*）



*: 低消費電力モードのとき、内部リソースからのリセット発行は復帰要因に含まれません。

<注意事項>

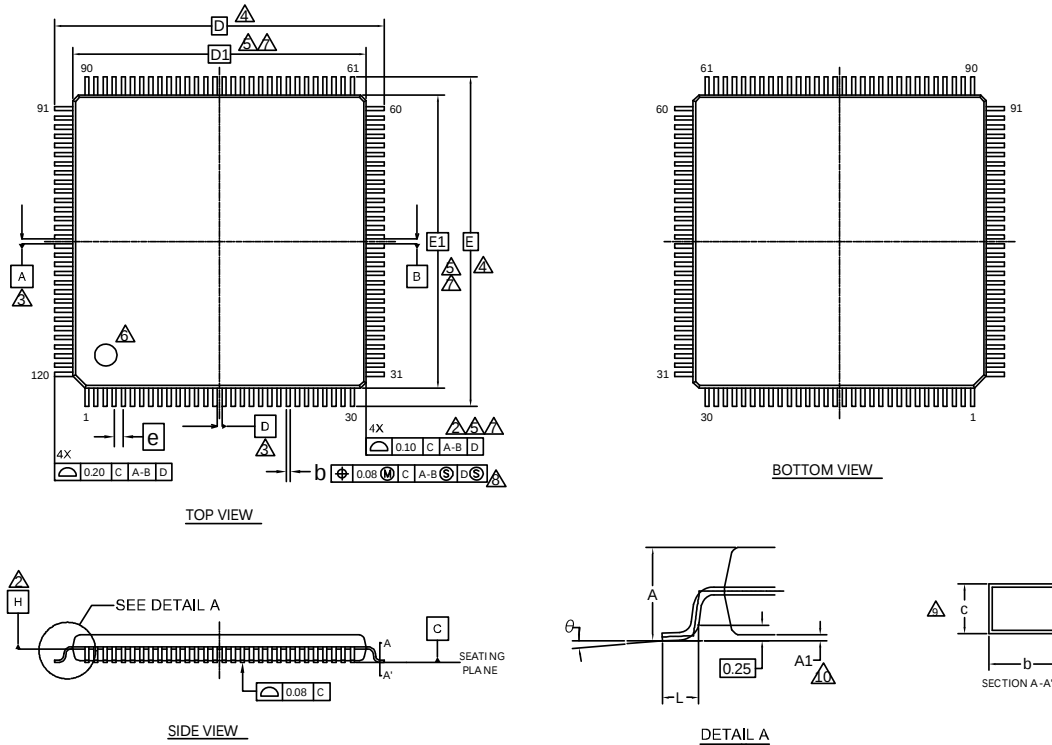
- 復帰要因は低消費電力モードごとに異なります。
各低消費電力モードからの復帰要因は『FM4 ファミリ ペリフェラルマニュアル』の『CHAPTER 6: 低消費電力モード』のスタンバイモード動作説明を参照してください。
- パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、復帰要因には含まれません。パワーオンリセット/低電圧検出リセット時は、「12. 電氣的特性 12.4 交流規格 (6) パワーオンリセットタイミング」を参照してください。
- リセットからの復帰時、CPU は高速CR ランモードに遷移します。
メインクロックやPLL クロックを使用する場合、追加でメインクロック発振安定待ち時間や、メインPLL クロックの安定待ち時間が必要になります。
- 内部リソースリセットとはウォッチドッグリセット, CSV リセットを指します。

13. オーダ型格

型格	パッケージ
S6E2H16G0A GV20000	Plastic LQFP (0.5-mm pitch), 120 pin (LQM120)
S6E2H14G0A GV20000	
S6E2H16F0A GV20000	Plastic LQFP (0.5-mm pitch), 100 pin (LQI100)
S6E2H14F0A GV20000	
S6E2H16E0A GV20000	Plastic LQFP (0.5-mm pitch), 80 pin (LQH080)
S6E2H14E0A GV20000	
S6E2H16G0A GB3000A	Plastic FBGA (0.5-mm pitch), 121 pin (FDI121)
S6E2H14G0A GB3000A	

14. パッケージ・外形寸法図

Package Type	Package Code
LQFP 120	LQM120



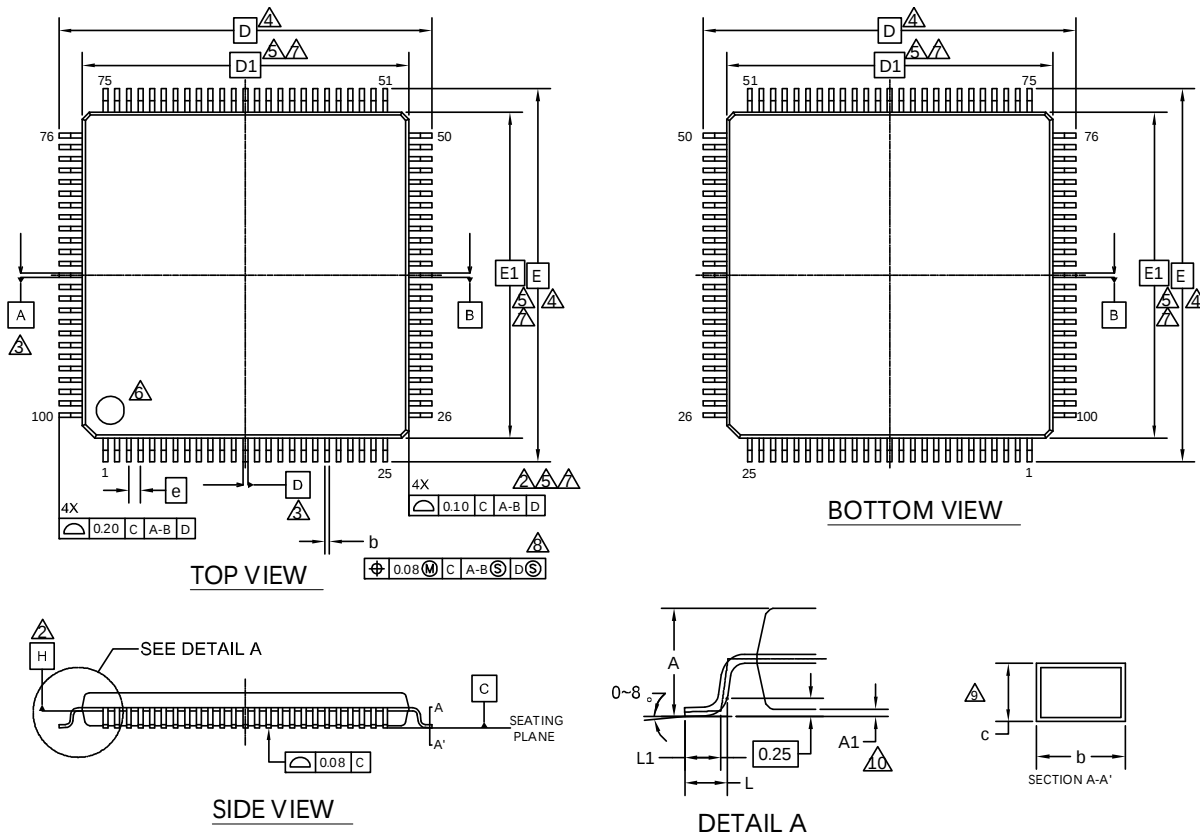
SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.05	—	0.15
b	0.17	0.22	0.27
c	0.115	—	0.195
D	18.00 BSC		
D1	16.00 BSC		
e	0.50 BSC		
E	18.00 BSC		
E1	16.00 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
θ	0°	—	8°

NOTES

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
- DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
- DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
- REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS, BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
- DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. THE DAMBAR PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
- THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
- A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

11. JEDEC SPECIFICATION NO. REF: N/A.

Package Type	Package Code
LQFP 100	LQI100



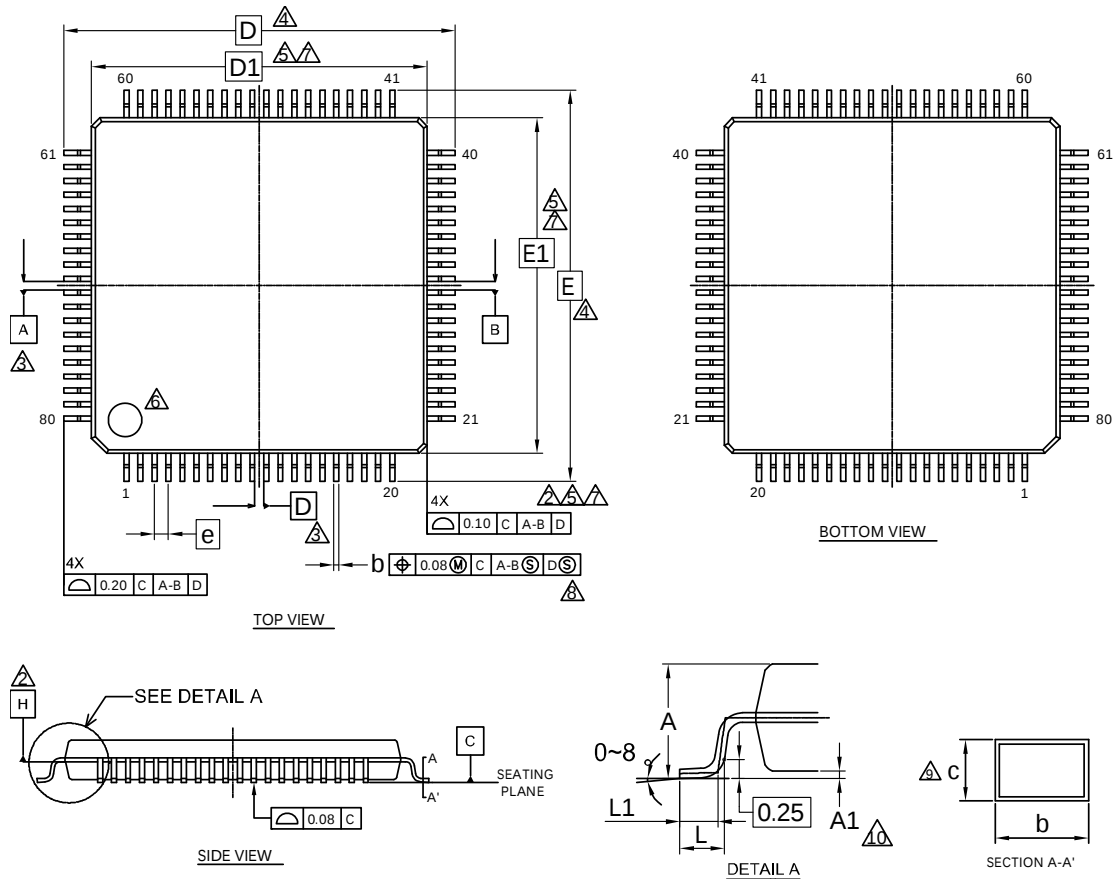
SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.00	—	0.20
b	0.15	—	0.27
c	0.09	—	0.20
D	16.00 BSC		
D1	14.00 BSC		
e	0.50 BSC		
E	16.00 BSC		
E1	14.00 BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70

NOTES :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
3. DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
4. TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
5. DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
6. DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
7. REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS. DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS. BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDED BODY.
8. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBER PROTRUSION. THE DAMBAR PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
9. THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
10. A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

PACKAGE OUTLINE, 100 LEAD LQF 002-11500 **
14.0X14.0X1.7 MM LOI100 Rev**

Package Type	Package Code
LQFP 80	LQH080

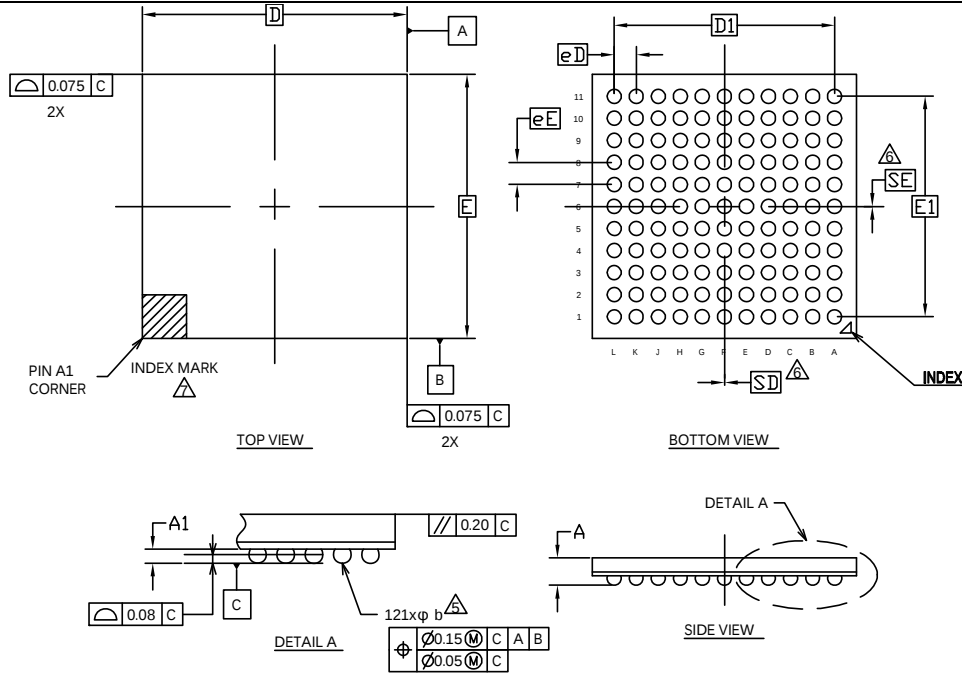


SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.70
A1	0.05	—	0.15
b	0.15	—	0.27
c	0.09	—	0.20
D	14.00 BSC.		
D1	12.00 BSC.		
e	0.50 BSC.		
E	14.00 BSC.		
E1	12.00 BSC.		
L	0.45	0.60	0.75
L1	0.30	0.50	0.70

NOTES

- CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (mm)
- DATUM PLANE H IS LOCATED AT THE BOTTOM OF THE MOLD PARTING LINE COINCIDENT WITH WHERE THE LEAD EXITS THE BODY.
- DATUMS A-B AND D TO BE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- TO BE DETERMINED AT SEATING PLANE C.
- DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PRE SIDE. DIMENSIONS D1 AND E1 INCLUDE MOLD MISMATCH AND ARE DETERMINED AT DATUM PLANE H.
- DETAILS OF PIN 1 IDENTIFIER ARE OPTIONAL BUT MUST BE LOCATED WITHIN THE ZONE INDICATED.
- REGARDLESS OF THE RELATIVE SIZE OF THE UPPER AND LOWER BODY SECTIONS, DIMENSIONS D1 AND E1 ARE DETERMINED AT THE LARGEST FEATURE OF THE BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND GATE BURRS. BUT INCLUDING ANY MISMATCH BETWEEN THE UPPER AND LOWER SECTIONS OF THE MOLDER BODY.
- DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBER PROTRUSION. THE DAMBER PROTRUSION (S) SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED b MAXIMUM BY MORE THAN 0.08mm. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OR THE LEAD FOOT.
- THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
- A1 IS DEFINED AS THE DISTANCE FROM THE SEATING PLANE TO THE LOWEST POINT OF THE PACKAGE BODY.

Package Type	Package Code
FBGA 121	FDI121



NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- SOLDER BALL POSITION DESIGNATION N PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.
- "e" REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.
- SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.
SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION.
N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.
- DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.
- "SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW.
WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" OR "SE" = 0.
WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.
- A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK METALIZED MARK, INDENTATION OR OTHER MEANS.
- "+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED SOLDER BALLS.

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.20
A1	0.20	0.25	0.30
D	6.00 BSC		
E	6.00 BSC		
D1	5.00 BSC		
E1	5.00 BSC		
MD	11		
ME	11		
N	121		
Ø b	0.27	0.32	0.37
eD	0.50 BSC		
eE	0.50 BSC		
SD	0.00		
SE	0.00		

改訂履歴

文書名: S6E2H1 シリーズ 32 ビット ARM® Cortex®-M4F, FM4 マイクロコントローラ

文書番号: 001-99424

版	ECN 番号	変更者	発行日	変更内容
**	4884630	YUIA	08/18/2015	New Spec. (これは英語版の 001-98940 Rev. ** を翻訳した日本語版です。)
*A	4932870	YUIA	10/02/2015	Preliminary から Final に変更。 12.2 推奨動作条件 を更新: "平滑コンデンサ容量(Cs)"を追加。 "動作時最大リーク電流"の"電流値"を追加。 12.3.1 電流規格 を更新: Table 12-1 ~ 12-9 を更新: "最大値"を追加。 Table 12-11 を更新: 電圧、温度条件を追加。 12.10.1 復帰要因: 割込み/WKUP を更新: 復帰カウント時間を更新。 12.10.2 復帰要因: リセット を更新: 復帰カウント時間を更新。
*B	5027953	YUIA	11/26/2015	2. パッケージと品種対応 を更新: FBGA を"開発中から""対応"に変更。 4 端子機能一覧 を更新: JTAG 端子についての"注意事項"を追加。 12.5 12 ビット A/D コンバータを更新: "ゼロトランジション" と"フルスケールトランジション"の値を更新。 "総合誤差"を追加。
*C	5639298	NOSU	02/22/2017	サイプレスロゴを更新 特長 リアルタイムクロック(RTC:Real Time Clock)の記述を以下の様に修正((秒/曜日)の削除): 修正前) 日時指定(年/月/日/時/分/秒/曜日)での割込み機能、年/月/日/時/分だけの個別設定も可能 修正後) 日時指定(年/月/日/時/分)での割込み機能、年/月/日/時/分だけの個別設定も可能 3 端子配列図を更新: 図から信号名を削除。 4 端子機能一覧を更新: 入出力回路形式および端子状態形式にハイパーリンクを追加。 5 入出力回路形式を更新: 分類 N の備考に"- 5V トレラント"を追加。 7 デバイス使用上の注意を更新: 電源投入時についてにコメントを追加。 10 メモリマップを更新:

				メモリマップ(2)の最大アドレスを 0x200D_FFFF に変更。 11 各 CPU ステートにおける端子状態を更新: VBAT ドメイン端子状態一覧表に”*1”を追加。 12.3.1 電流規格を更新: Table 12-9 に”*7”を追加。 12.4.7 パワーオンリセットタイミグを更新: 項目、規格を以下の様に変更。また、備考および<注意事項>としてコメントを追記。 電源立上り時間(T_r)を削除。 電源断時間(T_{off})の規格値を変更。 修正前)電源断時間(t_{off})[ms] : 1(最小), -(最大) 修正後)電源断時間(t_{off})[ms] : 50(最小), -(最大) 電源立上り速度(dV/dt)を追加。 12.4.11 CSIO タイミグを更新: 以下の例に従い、表タイトルから”SPI=1”および”MS=0”を削除。また、タイミグ図に”MS ビット=0”または”MS ビット=1”を追加。 計 8 か所 (106、108、110、112、122、124、126、128 ページ)。 表タイトル修正の例 (106 ページの場合) 修正前) 同期シリアル チップセレクト使用時(SPI=1, SCINV=0, MS=0, CSLVL=1) 修正後) 同期シリアル チップセレクト使用時(SCINV=0, CSLVL=1) 12.4.11 CSIO タイミグの表にボーレートの最大値を追加。 計 4 か所 (98、100、102、104 ページ) 13 オーダ型格を以下の様に修正: S6E2H14G0AGB30000 → S6E2H14G0AGB3000A S6E2H16G0AGB30000 → S6E2H16G0AGB3000A 14 パッケージ・外形寸法図の図を更新
--	--	--	--	---

セールス、ソリューションおよび法律情報

ワールドワイドな販売と設計サポート

サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持しています。お客様の最寄りのオフィスについては、[サイプレスのロケーション ページ](#)をご覧ください。

製品

ARM® Cortex® Microcontrollers cypress.com/arm

車載用 cypress.com/automotive

クロック&バッファ cypress.com/clocks

インターフェース cypress.com/interface

IoT (モノのインターネット) cypress.com/iot

メモリ cypress.com/memory

マイクロコントローラ cypress.com/mcu

PSoC cypress.com/psoc

電源用 IC cypress.com/pmic

タッチ センシング cypress.com/touch

USB コントローラー cypress.com/usb

ワイヤレス/RF cypress.com/wireless

PSoC® ソリューション

PSoC 1 | PSoC 3 | PSoC 4 | PSoC 5LP

サイプレス開発者コミュニティ

[フォーラム](#) | [WICED IOT Forums](#) | [Projects](#) | [ビデオ](#) | [ブログ](#)
| [トレーニング](#) | [Components](#)

テクニカルサポート

cypress.com/support

ARM and Cortex are the registered trademarks of ARM Limited in the EU and other countries.

All other trademarks or registered trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

© Cypress Semiconductor Corporation, 2015-2017. 本書面は、Cypress Semiconductor Corporation 及び Spansion LLC を含むその子会社 (以下「Cypress」という。) に帰属する財産である。本書面 (本書面に含まれ又は言及されているあらゆるソフトウェア若しくはファームウェア (以下「本ソフトウェア」という。) を含む) は、アメリカ合衆国及び世界のその他の国における知的財産法令及び条約に基づき Cypress が所有する。Cypress はこれらの法令及び条約に基づく全ての権利を留保し、本段落で特に記載されているものを除き、その特許権、著作権、商標権又はその他の知的財産権のライセンスを一切許諾しない。本ソフトウェアにライセンス契約書が伴っておらず、かつ Cypress との間で別途本ソフトウェアの使用方法を定める書面による合意がない場合、Cypress は、(1) 本ソフトウェアの著作権に基づき、(a) ソースコード形式で提供されている本ソフトウェアについて、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、かつ組織内部でのみ、本ソフトウェアの修正及び複製を行うこと、並びに (b) Cypress のハードウェア製品ユニットに用いるためにのみ、(直接又は再販売者及び販売代理店を介して間接のいずれかで) 本ソフトウェアをバイナリコード形式で外部エンドユーザーに配布すること、並びに (2) 本ソフトウェア (Cypress により提供され、修正がなされていないもの) が抵触する Cypress の特許権のクレームに基づき、Cypress ハードウェア製品と共に用いるためにのみ、本ソフトウェアの作成、利用、配布及び輸入を行うことについての非独占的で譲渡不能な一身専属的ライセンス (サブライセンスの権利を除く) を付与する。本ソフトウェアのその他の使用、複製、修正、変換又はコンパイルを禁止する。

適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、本書面又はいかなる本ソフトウェア若しくはこれに伴うハードウェアに関しても、明示又は黙示を問わず、いかなる保証 (商品性及び特定の目的への適合性の黙示の保証を含むがこれらに限られない) も行わない。適用される法律により許される範囲内で、Cypress は、別途通知することなく、本書面を変更する権利を留保する。Cypress は、本書面に記載のある、いかなる製品若しくは回路の適用又は使用から生じる一切の責任を負わない。本書面で提供されたあらゆる情報 (あらゆるサンプルデザイン情報又はプログラムコードを含む) は、参照目的のためにのみ提供されたものである。この情報で構成するあらゆるアプリケーション及びその結果としてのあらゆる製品の機能性及び安全性を適切に設計、プログラム、かつテストすることは、本書面のユーザーの責任において行われるものとする。Cypress 製品は、兵器、兵器システム、原子力施設、生命維持装置若しくは生命維持システム、蘇生用の設備及び外科的移植を含むその他の医療機器若しくは医療システム、汚染管理若しくは有害物質管理の運用のために設計され若しくは意図されたシステムの重要な構成部分としての使用、又は装置若しくはシステムの不具合が人身傷害、死亡若しくは物的損害を生じさせるようなその他の使用 (以下「本目的外使用」という。) のためには設計、意図又は承認されていない。重要な構成部分とは、その不具合が装置若しくはシステムの不具合を生じさせるか又はその安全性若しくは実効性に影響すると合理的に予想できるような装置若しくはシステムのあらゆる構成部分をいう。Cypress 製品のあらゆる本目的外使用から生じ、若しくは本目的外使用に関連するいかなる請求、損害又はその他の責任についても、Cypress はその全部又は一部を問わず一切の責任を負わず、かつ Cypress はそれら一切から本書により免除される。Cypress は Cypress 製品の目的外使用から生じ又は本目的外使用に関連するあらゆる請求、費用、損害及びその他の責任 (人身傷害又は死亡に基づく請求を含む) から免責補償される。

Cypress、Cypress のロゴ、Spansion、Spansion のロゴ及びこれらの組み合わせ、WICED、PSoC、Capsense、EZ-USB、F-RAM、及び Traveo は、米国及びその他の国における Cypress の商標又は登録商標である。Cypress の商標のより完全なリストは、cypress.com を参照のこと。その他の名称及びブランドは、それぞれの権利者の財産として権利主張がなされている可能性がある。